

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **10-207066**

(43)Date of publication of application : **07.08.1998**

(51)Int.Cl.

G03F 7/039  
C08F 8/00  
C08F112/14  
C08K 5/13  
C08K 5/17  
C08K 5/34  
C08K 5/42  
C08L 25/18  
H01L 21/027

(21)Application number : **09-110395**

(71)Applicant : **SHIN ETSU CHEM CO LTD**

(22)Date of filing : **11.04.1997**

(72)Inventor : **WATANABE SATOSHI  
WATANABE OSAMU  
FURUHATA TOMOYOSHI  
TAKEDA YOSHIFUMI  
NAGURA SHIGEHIRO  
ISHIHARA TOSHINOBU  
YAMAOKA TSUGIO**

(30)Priority

Priority number : **08127930** Priority date : **24.04.1996** Priority country : **JP**  
**08329228** **25.11.1996**

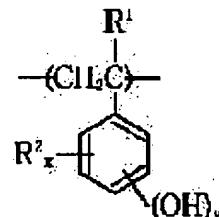
**JP**

## (54) CHEMICALLY SENSITIZED POSITIVE RESIST MATERIAL AND PATTERN FORMING METHOD

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide the chemically sensitized positive resist material having high sensitivity and resolution and wide exposure latitude and process aptitude and good reproduction performance and superior resistances to etching and heat by using a specified polymer compound as a base resin, and mixing an acid generator and a basic compound and a specified aromatic compound with the base resin.

**SOLUTION:** This resist material comprises an organic solvent, the polymer compound as the base resin, the acid generator, the basic compound, and the aromatic compound having a  $\equiv$ C-COOH group. This base resin has repeating units each represented by the formula in which R1 is an H atom or a methyl group, and R2 is a 1-8 C alkyl group, and a part of the phenolic hydroxyl groups are partially substituted by an acid-instable group and one of the other hydroxyl groups are cross-linked by the cross-linking group having C-O-C groups obtained by intramolecular



(19)日本国特許庁 (JP)

## (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-207066

(43)公開日 平成10年(1998)8月7日

(51) Int.C1.<sup>6</sup>  
 G03F 7/039  
 C08F 8/00  
 112/14  
 C08K 5/13  
 5/17

識別記号  
 501

F I  
 G03F 7/039  
 C08F 8/00  
 112/14  
 C08K 5/13  
 5/17

審査請求 未請求 請求項の数12 FD (全71頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平9-110395

(22)出願日 平成9年(1997)4月11日

(31)優先権主張番号 特願平8-127930

(32)優先日 平8(1996)4月24日

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(31)優先権主張番号 特願平8-329228

(32)優先日 平8(1996)11月25日

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000002060

信越化学工業株式会社  
東京都千代田区大手町二丁目6番1号

(72)発明者 渡辺 聰

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1  
信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72)発明者 渡辺 修

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1  
信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(74)代理人 弁理士 小島 隆司

最終頁に続く

(54)【発明の名称】化学增幅ポジ型レジスト材料及びパターン形成方法

(57)【要約】 (修正有)

【解決手段】 (A) : 有機溶剤

(B) : ベース樹脂として1種又は2種以上の酸不安定基を有する高分子化合物が更に分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されている重量平均分子量が1,000~500,000の高分子化合物

(C) : 酸発生剤

(D) : 塩基性化合物

(E) : 分子内に≡C-COOHで示される基を有する芳香族化合物

を含有してなることを特徴とする化学增幅ポジ型レジスト材料。

【効果】 化学增幅ポジ型レジスト材料は、高エネルギー線に感応し、感度、解像性、プラズマエッチング耐性に優れ、しかもレジストパターンの耐熱性、再現性にも優れている。また、パターンがオーバーハング状になりにくく、寸法制御性に優れている。更に、アセチレンアルコール誘導体の配合により保存安定性が向上する。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) : 有機溶剤

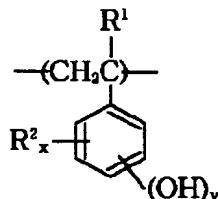
(B) : ベース樹脂として1種又は2種以上の酸不安定基を有する高分子化合物が更に分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されている重量平均分子量が1,000~500,000の高分子化合物

(C) : 酸発生剤

(D) : 塩基性化合物

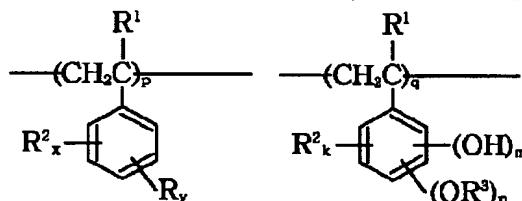
(E) : 分子内に≡C-COOHで示される基を有する芳香族化合物を含有してなることを特徴とする化学增幅ポジ型レジスト材料。

【請求項2】 (B) 成分のベース樹脂として、下記一



(式中、R¹は水素原子又はメチル基を示し、R²は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、x+y≤5を満足する数である。)

【請求項3】 (B) 成分のベース樹脂として、下記一般式(2)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物



(式中、Rは水酸基又はOR³基を示し、少なくとも1個は水酸基である。R¹は水素原子又はメチル基を示し、R²は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R³は酸不安定基を示す。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、x+y≤5を満足する数であり、kは0又は正の整数、mは0又は正の整数であり、nは正の整数であり、k+m+n≤5を満足する数である。p、qは正数であり、p+q=1を満足する数である。なお、nが2以上の場合、R³は互いに同一であっても異なっていてもよい。)

【請求項4】 (B) 成分のベース樹脂として、下記一

般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基の一部の水素原子が1種又は2種以上の酸不安定基により部分置換され、かつ残りのフェノール性水酸基の一部とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)のフェノール性水酸基の水素原子全体の平均0モル%を超える80モル%以下の割合である重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物を含有してなる請求項1記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【化1】

(1)

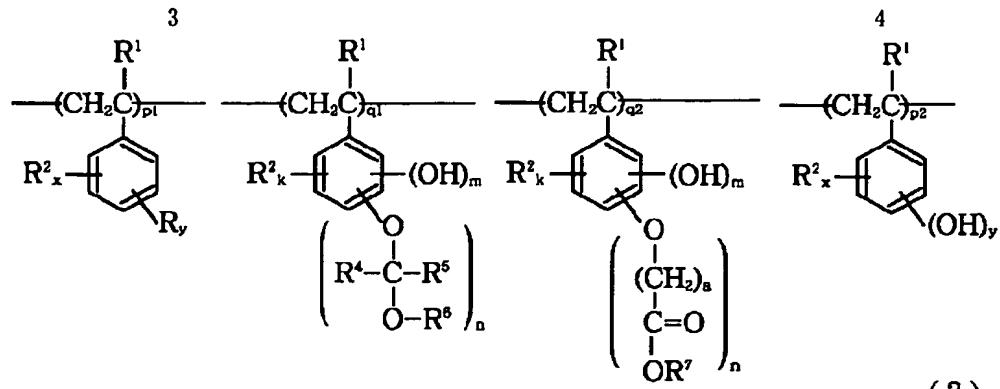
との反応により得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)のフェノール性水酸基の水素原子全体の平均0モル%を超える80モル%以下の割合である重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物を含有してなる請求項2記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【化2】

(2)

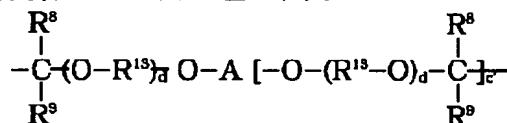
般式(3)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基の水素原子がとれてその酸素原子が下記一般式(4a)又は(4b)で示されるC-O-C基を有する架橋基により分子内及び/又は分子間で架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)のフェノール性水酸基の水素原子全体の平均0モル%を超える80モル%以下の割合である重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物を含有してなる請求項3記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【化3】

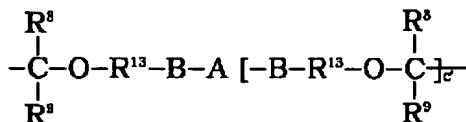


(3)

(式中、Rは水酸基又はOR<sup>1</sup>基を示し、少なくとも1個は水酸基である。R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>2</sup>は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。R<sup>3</sup>は酸不安定基を示す。R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R<sup>6</sup>は炭素数1～18のヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基を示し、R<sup>4</sup>とR<sup>5</sup>、R<sup>4</sup>とR<sup>6</sup>、R<sup>5</sup>とR<sup>6</sup>とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>はそれぞれ炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R<sup>7</sup>は



(4 a)



(4 b)

(式中、R<sup>8</sup>、R<sup>9</sup>は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、R<sup>8</sup>とR<sup>9</sup>とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR<sup>8</sup>、R<sup>9</sup>は炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R<sup>13</sup>は炭素数1～10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、dは0又は1～10の整数である。Aは、c価の炭素数1～50の脂肪族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基を示し、これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、カルボニル基又はフッ素原子によって置換されていてもよい。Bは-CO-O-、-NHCO-O-又は-NHCONH-を示す。cは2～8、c'は1～7の整数である。)

【請求項5】 (C) 成分として、オニウム塩及び/又

炭素数4～12の3級アルキル基を示す。p1、p2は正数、q1、q2は0又は正数であり、0<p1/(p1+q1+q2+p2)≤0.8、0≤q1/(p1+q1+q2+p2)≤0.8、0≤q2/(p1+q1+q2+p2)≤0.8、p1+q1+q2+p2=1を満足する数であるが、q1とq2が同時に0となることはない。aは0又は1～6の正の整数である。x、y、k、m、nはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

## 20 【化4】

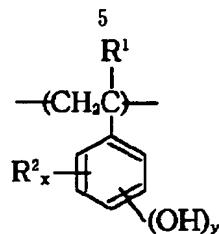
40

はジアゾメタン誘導体を配合したことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【請求項6】 (D) 成分として、脂肪族アミンを配合したことを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【請求項7】 更に、(F)：(B)成分とは別のベース樹脂として、下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基の水素原子を1種又は2種以上の酸不安定基により全体として平均0モル%以上80モル%以下の割合で部分置換した重量平均分子量3,000～30,000,000の高分子化合物を配合したことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

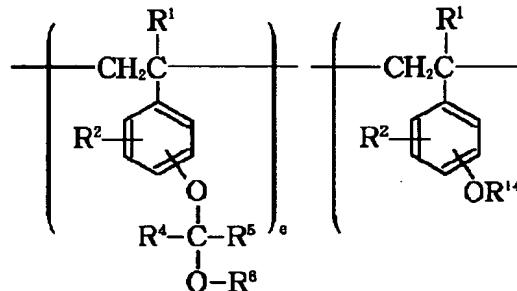
【化5】



(1)

(式中、R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>2</sup>は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、x+y≤5を満足する数である。)

【請求項8】 (F) 成分として、下記一般式(10)



(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>は上記と同様の意味を示し、R<sup>14</sup>は-CR<sup>4</sup>R<sup>6</sup>OR<sup>6</sup>とは異なる酸不安定基であり、e、fは0又は正数、gは正数で、e+f+g=1であり、0≤e/(e+f+g)≤0.5、0.4≤g/(e+f+g)≤0.9である。)

【請求項9】 更に、(G)：溶解制御剤を配合したこととを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【請求項10】 更に、(H)：紫外線吸収剤を配合したことを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【請求項11】 更に、(I)：アセチレンアルコール誘導体を配合したことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【請求項12】 (i) 請求項1乃至11のいずれか1項に記載の化学增幅ポジ型レジスト材料を基板上に塗布する工程と、(ii) 次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長300nm以下の高エネルギー線もしくは電子線で露光する工程と、(iii) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

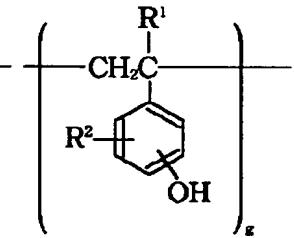
【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、1種又は2種以上の酸不安定基を有する高分子化合物が更に分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されている高分子化合物をベース樹脂としてレジスト材料に配合することにより、露光前後のアルカリ溶解コントラストが大幅に高く、高感度で高解像性を有し、特に超LSI製造用の微細パターン形成材料として再現性に優

で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量が3,000～30,000の高分子化合物を配合したことを特徴とする請求項7記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【化6】



(10)

れた化学增幅ポジ型レジスト材料に関する。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】 近年、LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの微細化が求められているなか、次世代の微細加工技術として遠紫外線リソグラフィーが有望視されている。遠紫外線リソグラフィーは、0.5μm以下の加工も可能であり、光吸収の低いレジスト材料を用いた場合、基板に対して垂直に近い側壁を有したパターン形成が可能になる。

【0003】 近年開発された酸を触媒とした化学增幅ポジ型レジスト材料(特公平2-27660号、特開昭63-27829号公報等記載)は、遠紫外線の光源として高輝度なKrFエキシマレーザーを利用し、感度、解像性、ドライエッチング耐性が高く、優れた特徴を有した遠紫外線リソグラフィーに特に有望なレジスト材料として期待されている。

【0004】 このような化学增幅ポジ型レジスト材料としては、ベース樹脂、酸発生剤からなる二成分系、ベース樹脂、酸発生剤、酸不安定基を有する溶解制御剤からなる三成分系が知られている。

【0005】 例えば、特開昭62-115440号公報には、ポリ-4-tert-ブトキシスチレンと酸発生剤からなるレジスト材料が提案され、この提案と類似したものとして特開平3-223858号公報には分子内にtert-ブトキシ基を有する樹脂と酸発生剤からなる二成分系レジスト材料、更には特開平4-211258号公報にはメチル基、イソプロピル基、tert-ブチル基、テトラヒドロピラニル基、トリメチルシリル基含有ポリヒドロキシスチレンと酸発生剤からなる二成分

系のレジスト材料が提案されている。

【0006】更に、特開平6-100488号公報には、ポリ〔3, 4-ビス(2-テトラヒドロピラニルオキシ)スチレン〕、ポリ〔3, 4-ビス(tert-ブトキシカルボニルオキシ)スチレン〕、ポリ〔3, 5-ビス(2-テトラヒドロピラニルオキシ)スチレン〕等のポリジヒドロキシスチレン誘導体と酸発生剤からなるレジスト材料が提案されている。

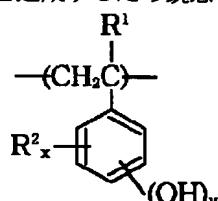
【0007】しかしながら、これらレジスト材料のベース樹脂は、酸不安定基を側鎖に有するものであり、酸不安定基がtert-ブチル基、tert-ブトキシカルボニル基のように強酸で分解されるものであると、空気中の塩基性化合物と反応して失活する結果、酸不安定基の分解が起りにくくなり、そのレジスト材料のパターン形状がT-トップ形状になり易い。一方、エトキシカルボニル基等のようなアルコキシアルキル基は弱酸で分解されるため、空気中の塩基性化合物の影響は少ないが、露光から加熱処理までの時間経過に伴ってパターン形状が著しく細るという欠点を有したり、側鎖に嵩高い基を有しているので、耐熱性が下がったり、感度及び解像度が満足できるものではないなど、いずれも問題を有しており、未だ実用化に至っていないのが現状であり、このためこれら問題の改善が望まれる。

【0008】なお、特開平8-305025号公報記載の高分子化合物は上記問題の改善を目的にしたものであるが、製造方法の特性上酸不安定基及び架橋基の置換基比率の設計が困難であり、また特開平8-253534号公報記載の架橋基の副生を招くという欠点を有している。即ち、レジスト組成物を設計するに当たり、酸発生剤、添加剤の選択及び添加量の設定により、様々なアルカリ溶解速度の高分子化合物を必要とし、更にその高分子化合物の製造の再現性が要求されるが、上記公報記載の製造方法では酸不安定基及び架橋基の選択の制約及び置換基比率の制約を受けざるを得ないという欠点を有している。

【0009】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、従来のレジスト材料を上回る高感度及び高解像度、露光余裕度、プロセス適応性、再現性を有し、プラズマエッチング耐性に優れ、しかもレジストパターンの耐熱性にも優れた化学增幅ポジ型レジスト材料を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果



果、後述する方法によって得られる重量平均分子量が1, 000~500, 000である分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋された1種又は2種以上の酸不安定基を有する新規高分子化合物が、これをベース樹脂として用い、これに酸発生剤、塩基性化合物、分子内に≡C-COOHで示される基を有する芳香族化合物を配合した化学增幅ポジ型レジスト材料が、レジスト膜の溶解コントラストを高め、特に露光後の溶解速度を増大させること、更に、レジストのPDE安定性を向上させ、塗化膜基板上でのエッジラフネスを改善させること、またアセチレンアルコール誘導体を配合することにより、塗布性、保存安定性を向上させ、高解像度、露光余裕度、プロセス適応性に優れ、実用性の高い、精密な微細加工に有利であり、超LSI用レジスト材料として非常に有効であることを知見した。

【0011】即ち、本発明は、下記の化学增幅ポジ型レジスト材料を提供する。

【I】 (A) : 有機溶剤

(B) : ベース樹脂として1種又は2種以上の酸不安定基を有する高分子化合物が更に分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されている重量平均分子量が1, 000~500, 000の高分子化合物

(C) : 酸発生剤

(D) : 塩基性化合物

(E) : 分子内に≡C-COOHで示される基を有する芳香族化合物

を含有してなることを特徴とする化学增幅ポジ型レジスト材料。

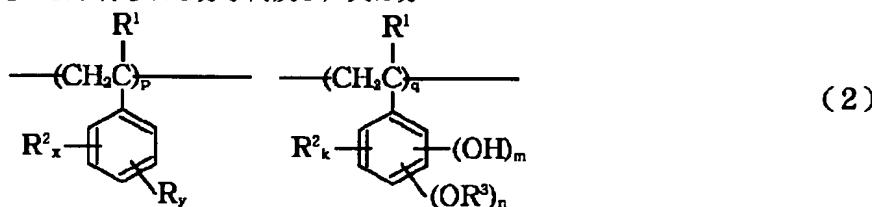
【0012】【II】(B)成分のベース樹脂として、下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基の一部の水素原子が1種又は2種以上の酸不安定基により部分置換され、かつ残りのフェノール性水酸基の一部とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)のフェノール性水酸基の水素原子全体の平均0モル%を超える80モル%以下の割合である重量平均分子量1, 000~500, 000の高分子化合物を含有してなる上記【I】記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【0013】

【化7】

(式中、R'は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>1</sup>は炭素数1~8の直鎖状、分歧状又は環状のアルキル基を示す。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、x+y≤5を満足する数である。)

【0014】【III】(B)成分のベース樹脂として、下記一般式(2)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により得られる分子内及び/又は分



(式中、Rは水酸基又はOR'基を示し、少なくとも1個は水酸基である。R'は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>1</sup>は炭素数1~8の直鎖状、分歧状又は環状のアルキル基を示し、R<sup>3</sup>は酸不安定基を示す。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、x+y≤5を満足する数であり、kは0又は正の整数、mは0又は正の整数であり、nは正の整数であり、k+m+n≤5を満足する数である。p、qは正数であり、p+q=1を満足する数である。なお、nが2以上の場合、R<sup>3</sup>は互いに同一であっても異なっていてもよい。)

【0016】【IV】(B)成分のベース樹脂として、下記一般式(3)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基の水素原子がとれてその酸素原子が下記一般式(4a)又は(4b)で示されるC-O-C基を有する架橋基により分子内及び/又は分子間で架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)のフェノール性水酸基の水素原子全体の平均0モル%を超えるモル%以下の割合である重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物を含有してなる上記【III】記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)のフェノール性水酸基の水素原子全体の平均0モル%を超えるモル%以下の割合である重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物を含有してなる上記【III】記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

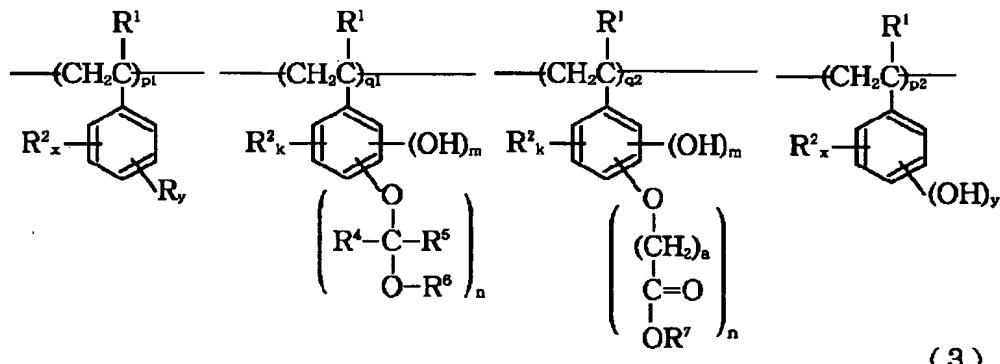
【0015】

【化8】

子化合物のRで示されるフェノール性水酸基の水素原子がとれてその酸素原子が下記一般式(4a)又は(4b)で示されるC-O-C基を有する架橋基により分子内及び/又は分子間で架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)のフェノール性水酸基の水素原子全体の平均0モル%を超えるモル%以下の割合である重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物を含有してなる上記【III】記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【0017】

【化9】



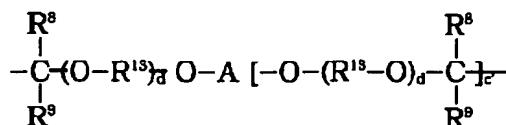
(式中、Rは水酸基又はOR'基を示し、少なくとも1個は水酸基である。R'は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>1</sup>は炭素数1~8の直鎖状、分歧状又は環状のアルキル基を示す。R<sup>3</sup>は酸不安定基を示す。R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分歧状又は環状のアルキル基を示し、R<sup>6</sup>は炭素数1~18のヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基を示し、R<sup>4</sup>とR<sup>5</sup>、R<sup>4</sup>とR<sup>6</sup>、R<sup>5</sup>とR<sup>6</sup>とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>はそれぞれ炭素数1~8の直鎖状又は分歧状のアルキレン基を示す。R'は

炭素数4~12の3級アルキル基を示す。p1、p2は40正数、q1、q2は0又は正数であり、0<p1/(p1+q1+q2+p2)≤0.8、0≤q1/(p1+q1+q2+p2)≤0.8、0≤q2/(p1+q1+q2+p2)≤0.8、p1+q1+q2+p2=1を満足する数であるが、q1とq2が同時に0となることはない。aは0又は1~6の正の整数である。x、y、k、m、nはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

【0018】

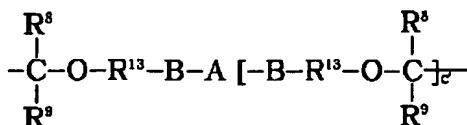
【化10】

11



12

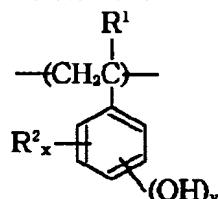
(4a)



(4b)

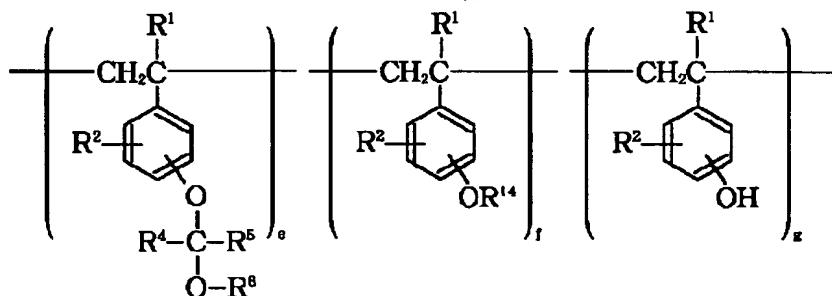
(式中、 $R^8$ 、 $R^9$ は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、 $R^8$ と $R^9$ とは環を形成してもよく、環を形成する場合には $R^8$ 、 $R^9$ は炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。 $R^{13}$ は炭素数1～10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、 $d$ は0又は1～10の整数である。Aは、cの炭素数1～50の脂肪族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基を示し、これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、カルボニル基又はフッ素原子によって置換されていてもよい。Bは $-CO-O-$ 、 $-NHCO-O-$ 又は $-NHCONH-$ を示す。cは2～8、c'は1～7の整数である。)

【0019】(V) (C)成分として、オニウム塩及び／又はジアゾメタン誘導体を配合したことを特徴とする



(式中、 $R^1$ は水素原子又はメチル基を示し、 $R^2$ は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、 $x+y \leq 5$ を満足する数である。)

【0023】(VIII) (F)成分として、下記一般式(10)で示される繰り返し単位を有する重量平均分



(1)

上記【I】乃至【IV】のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【0020】(VI) (D)成分として、脂肪族アミンを配合したことを特徴とする上記【I】乃至【V】のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【0021】(VII)更に、(F)：(B)成分とは別のベース樹脂として、下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基の水素原子を1種又は2種以上の酸不安定基により全体として平均0モル%以上80モル%以下の割合で部分置換した重量平均分子量3,000～300,000の高分子化合物を配合したことを特徴とする上記【I】乃至【VI】のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【0022】

【化11】

子量が3,000～300,000の高分子化合物を配合したことを特徴とする上記【VII】記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【0024】

【化12】

(10)

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^8$ は上記と同様の意味を示し、 $R^{14}$ は $-CR^4R^5OR^6$ とは異なる酸不安定基であり、e、fは0又は正数、gは正数で、 $e+f+g$

=1であり、 $0 \leq e/(e+f+g) \leq 0.5$ 、 $0.4 \leq g/(e+f+g) \leq 0.9$ である。)

【0025】(IX)更に、(G)：溶解制御剤を配合

したことを特徴とする上記【I】乃至【VIII】のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【0026】【X】更に、(H)：紫外線吸収剤を配合したことを特徴とする上記【I】乃至【IX】のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【0027】【X】更に、(I)：アセチレンアルコール誘導体を配合したことを特徴とする上記【I】乃至【X】のいずれか1項記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

【0028】また、本発明は、(i)上記【I】乃至【X】のいずれか1項に記載の化学增幅ポジ型レジスト材料を基板上に塗布する工程と、(ii)次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長300nm以下の高エネルギー線もしくは電子線で露光する工程と、(iii)必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法を提供する。

【0029】ここで、上記のような高分子化合物をベース樹脂としてレジスト材料に配合した場合、この高分子化合物は、特にC-O-C基を有する架橋基によって架橋されているため、溶解阻止性が大きく、露光後の溶解コントラストも大きいという利点を有している。

【0030】即ち、側鎖にアルコキシアルキル基が単独に付加したポリマーの場合、弱い酸により脱離反応が進行することからTトップ形状にはなり難いが、上述したように酸に対して敏感であるために露光から加熱処理までの時間経過に伴ってパターン形状が著しく細るという欠点がある。また、アルカリに対する溶解阻止効果が低いために、溶解コントラストを得るには高置換率体を使用しなければならず、耐熱性に欠けるという欠点を有するものである。一方、フェノール性水酸基の側鎖をtert-ブロキシカルボニル基で保護したポリマーの場合、これをレジスト材料に配合すると、アルカリ溶解阻止性は良くなり、低置換率で溶解コントラストが得られたり、耐熱性が良いという長所を有しているが、脱離させてアルカリ可溶性にするためにはトリフルオロメタンスルホン酸等の強い酸を発生させる酸発生剤が必要であり、そのような酸を使用すると上述したようにTトップ形状になり易いという欠点を有するものとなる。

【0031】このようなポリマーに対して、上述したようにフェノール性水酸基の一部とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応によって得られるような分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基で架橋させた高分子化合物を用いたレジスト材料は、側鎖をアセタール基で保護したポリマーにおける耐熱性が低いという欠点、tert-ブロキシカルボニル基で保護したポリマーにおけるTトップ形状を形成し易いという欠点を解消するものである。

【0032】一方、本発明の化学增幅ポジ型レジスト材

料に用いる高分子化合物の効果として、本発明に係る高分子化合物は酸に不安定であるC-O-C基を有する架橋基によって架橋され、酸不安定基によって保護されているため、レジスト膜の未露光部における重量平均分子量及びアルカリ現像液に対する溶解性が変化することはないが、レジスト膜の露光部の重量平均分子量は、発生した酸による分解を経て、更には酸不安定基の脱離を伴って架橋及び酸不安定基によって保護する前のアルカリ可溶性ベース樹脂の重量平均分子量に戻るため、アルカリ溶解速度が未露光部に比べ大きく増大することから溶解コントラストを高めることができ、結果として高解像度化が達成できるものである。

【0033】また、C-O-C基を有する架橋基が酸によって分解されると、アルコール化合物(ジオール、トリオール、ポリオール化合物等)が生成されるが、その親水性基によりアルカリ現像液との親和性が向上し、結果として高解像度化が達成できる。

【0034】更に、レジスト組成物を設計するに当たり、酸発生剤、添加剤の選択及び添加量の設定により、様々なアルカリ溶解速度の高分子化合物を必要とし、更にその高分子化合物の製造の再現性が要求されるが、上記高分子化合物を用いることにより酸不安定基及び架橋基の選択の制約及び置換基比率の制約を受けずに設計することが可能である。

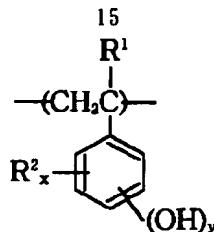
【0035】即ち、上記高分子化合物をベース樹脂として使用した化学增幅ポジ型レジスト材料は、Tトップ形状になり易い、パターン形状が細く、耐熱性に欠けるという問題が従来のものより極めて少なく、レジスト膜の溶解コントラストを高めることができ、結果的に高感度及び高解像性を有し、かつパターンの寸法制御、パターンの形状コントロールを組成により任意に行うことが可能であり、プロセス適応性、再現性にも優れた化学增幅ポジ型レジスト材料となるものである。

【0036】以下、本発明につき更に詳細に説明すると、本発明の新規化学增幅ポジ型レジスト材料に用いる高分子化合物は、1種又は2種以上の酸不安定基を有する高分子化合物が、更に分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されている重量平均分子量が1,000~500,000の高分子化合物である。

【0037】上記高分子化合物は、下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基の一部の水素原子が酸不安定基により部分置換され、かつ残りのフェノール性水酸基の一部とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されている高分子化合物とができる。

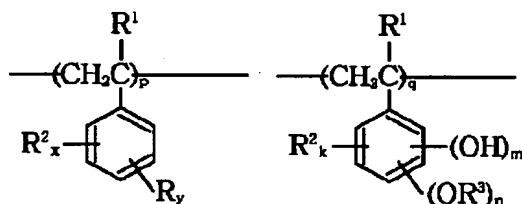
【0038】

【化13】



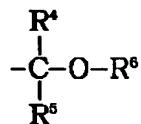
(1)

【0039】ここで、R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>2</sup>は炭素数1～8、好ましくは1～5、更に好ましくは1～3の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、iso-ブチル基、tert-ブチル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基等を例示できる。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、x+y≤5を満足するものであるが、yは1～3、特に1～2であることが好ましい。

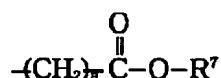


(2)

(式中、Rは水酸基又はOR³基を示し、少なくとも1個は水酸基である。R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>2</sup>は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R³は酸不安定基を示す。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、x+y≤5を満足する数であり、kは0又は正の整数、mは0又は正の整数であり、nは正の整数であり、k+m+n≤5を満足する数である。p、qは正数であり、p+q=1を満足する数である。なお、nが2以上の場合、R³は互いに同一であっても異なっていてもよい。)



(5)



(6)

【0045】式中、R⁴、R⁶は水素原子又は炭素数1～8、好ましくは1～6、更に好ましくは1～5の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R⁴は炭素数1～18、好ましくは1～10、更に好ましくは1～8の酸素原子等のヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基を示し、R⁴とR⁵、R⁴とR⁶、R⁵とR⁶とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR⁴、R⁶、R⁵はそれぞれ炭素数1～18、好ましくは1～10、更に好ましくは1～8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R⁷は炭素数4～12、好ましくは4～8、更

【0040】本発明に係る高分子化合物は、具体的には下記一般式(2)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基の一部とアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により得られる分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋されている高分子化合物とすることができる。

【0041】

【化14】

【0042】ここで、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>の具体例、yの好適範囲は上述した通りであり、nは1～2、mは0～1であることが好ましい。

【0043】上記フェノール性水酸基の水素原子と置換される酸不安定基或いはR<sup>3</sup>の酸不安定基としては、種々選定されるが、特に下記式(5)、(6)で示される基、tert-アルキル基、トリアルキルシリル基、ケトアルキル基等であることが好ましい。

【0044】

【化15】

に好ましくは4～6の3級アルキル基を示す。また、aは0～6の整数である。

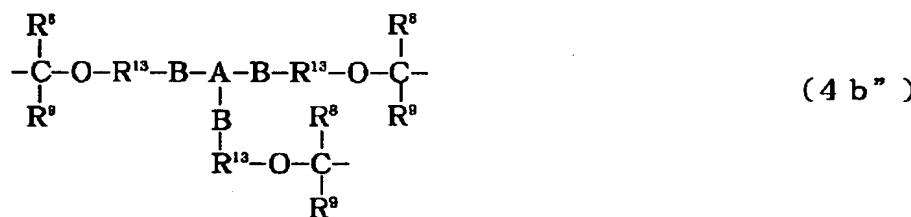
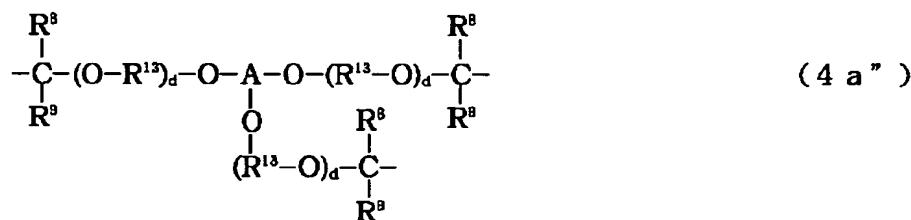
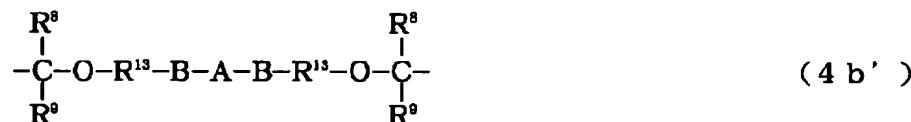
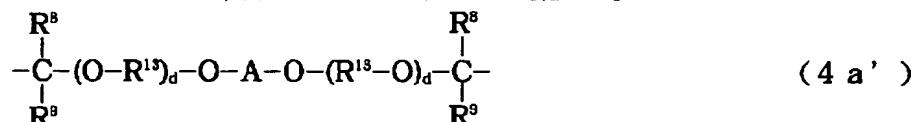
【0046】R<sup>4</sup>、R<sup>6</sup>の炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基としては、R<sup>2</sup>で説明したものと同様の基が挙げられる。

【0047】R<sup>6</sup>としては、直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、フェニル基、p-メチルフェニル基、p-エチルフェニル基、p-メトキシフェニル基等のアルコキシ置換フェニル基等の非置換又は置換アリール基、ベンジル基、フェネチル基等のアラルキル基等や、これら



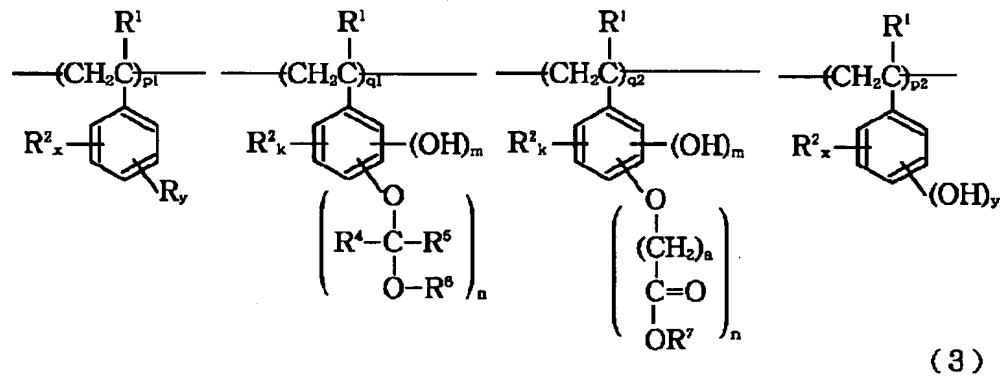
ニルエーテル化合物、ハロゲン化アルキルエーテル化合物に由来する。

【0055】架橋基は、上記式(4a)、(4b)のc'の値から明らかなように、2価に限られず、3価～8価の基でもよい。例えば、2価の架橋基としては、下



【0057】本発明に係る高分子化合物としては、具体的な例として、下記一般式(3)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基の水素原子がとれてその酸素原子が上記一般式(4

a) 又は(4b)で示されるC-O-C基を有する架橋



(式中、Rは水酸基又はOR'基を示し、少なくとも1個は水酸基である。R'は水素原子又はメチル基を示し、R'は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のア

記式(4a')、(4b')、3価の架橋基としては、下記式(4a'')、(4b'')で示されるものが挙げられる。

【0056】

【化19】

(4a')

(4b')

(4a'')

(4b'')

基により分子内及び/又は分子間で架橋されている高分子化合物を挙げることができる。

【0058】

【化20】

ルキル基を示す。R'は酸不安定基を示す。R'、R'は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R'は炭素数1～18のヘテロ原子

を有していてもよい1価の炭化水素基を示し、 $R'$ と $R'$ 、 $R'$ と $R'$ 、 $R'$ と $R'$ とは環を形成してもよく、環を形成する場合には $R'$ 、 $R'$ 、 $R'$ はそれぞれ炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。 $R'$ は炭素数4～12の3級アルキル基を示す。 $p_1$ 、 $p_2$ は正数、 $q_1$ 、 $q_2$ は0又は正数であり、 $0 < p_1 / (p_1 + q_1 + q_2 + p_2) \leq 0.8$ 、 $0 \leq q_1 / (p_1 + q_1 + q_2 + p_2) \leq 0.8$ 、 $0 \leq q_2 / (p_1 + q_1 + q_2 + p_2) \leq 0.8$ 、 $p_1 + q_1 + q_2 + p_2 = 1$ を満足する数であるが、 $q_1$ と $q_2$ が同時に0となることはない。 $a$ は0又は1～6の正の整数である。 $x$ 、 $y$ 、 $k$ 、 $m$ 、 $n$ はそれぞれ上記と同様の意味を示す。なお、 $p_1 + p_2 = p$ 、 $q_1 + q_2 = q$ である。)

$$0 < \frac{p_1}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} \leq 0.4, \text{特に } 0.01 \leq \frac{p_1}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} \leq 0.2$$

$$0 \leq \frac{q_1}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} \leq 0.6, \text{特に } 0 \leq \frac{q_1}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} \leq 0.4$$

$$0 \leq \frac{q_2}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} \leq 0.6, \text{特に } 0 \leq \frac{q_2}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} \leq 0.4$$

$$0.4 \leq \frac{p_2}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} < 1, \text{特に } 0.5 \leq \frac{p_2}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} \leq 0.9$$

$$0 < \frac{q_1 + q_2}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} \leq 0.8, \text{特に } 0.1 \leq \frac{q_1 + q_2}{p_1 + q_1 + p_2 + q_2} \leq 0.4$$

また、 $q_1 / (q_1 + q_2)$ は0～1、より好ましくは0.5～1、更に好ましくは0.7～1であることが望ましい。

【0062】この高分子化合物の例としては、下記式(3'-1)、(3'-2)で示されるものを挙げるこ

【0059】ここで、 $R$ 、 $R'$ ～ $R'$ 、 $x$ 、 $y$ 、 $k$ 、 $m$ 、 $n$ 、 $a$ の具体例、好適範囲は上記の通りである。また、 $p_1$ 、 $p_2$ は正数、 $q_1$ 、 $q_2$ は0又は正数であり、 $0 < p_1 / (p_1 + q_1 + q_2 + p_2) \leq 0.8$ 、 $0 \leq q_1 / (p_1 + q_1 + q_2 + p_2) \leq 0.8$ 、 $0 \leq q_2 / (p_1 + q_1 + q_2 + p_2) \leq 0.8$ 、 $p_1 + q_1 + q_2 + p_2 = 1$ を満足する数であるが、 $q_1$ と $q_2$ が同時に0となることはない。

【0060】より好ましくは、 $p_1$ 、 $p_2$ 、 $q_1$ 、 $q_2$ の値は下記の通りである。

【0061】

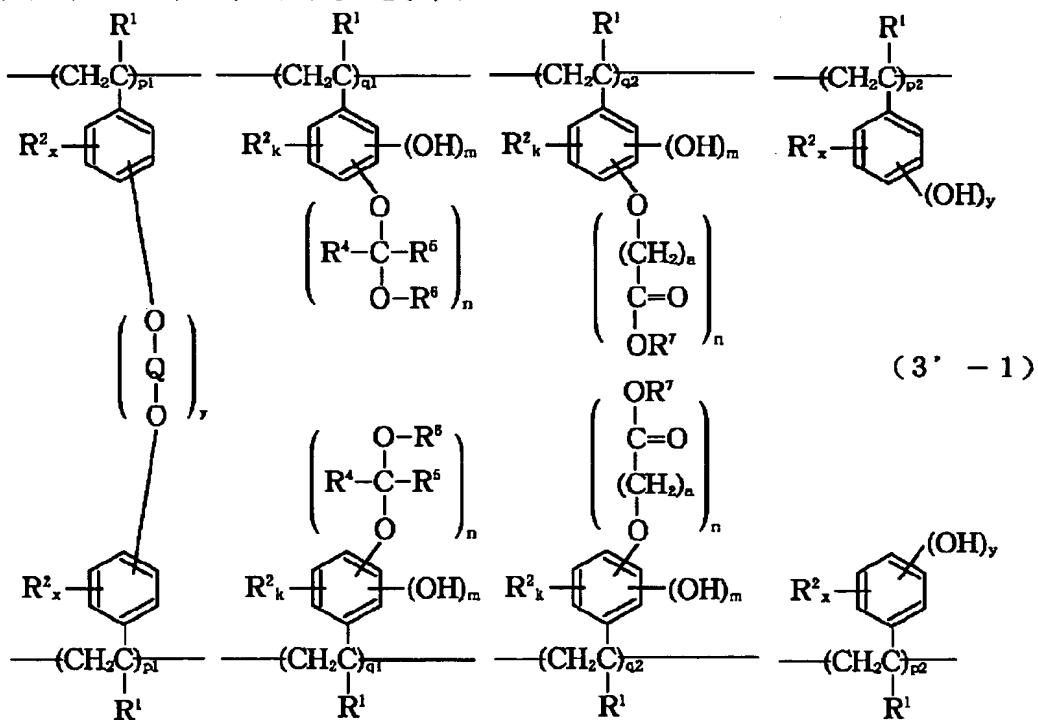
【数1】

とができる。

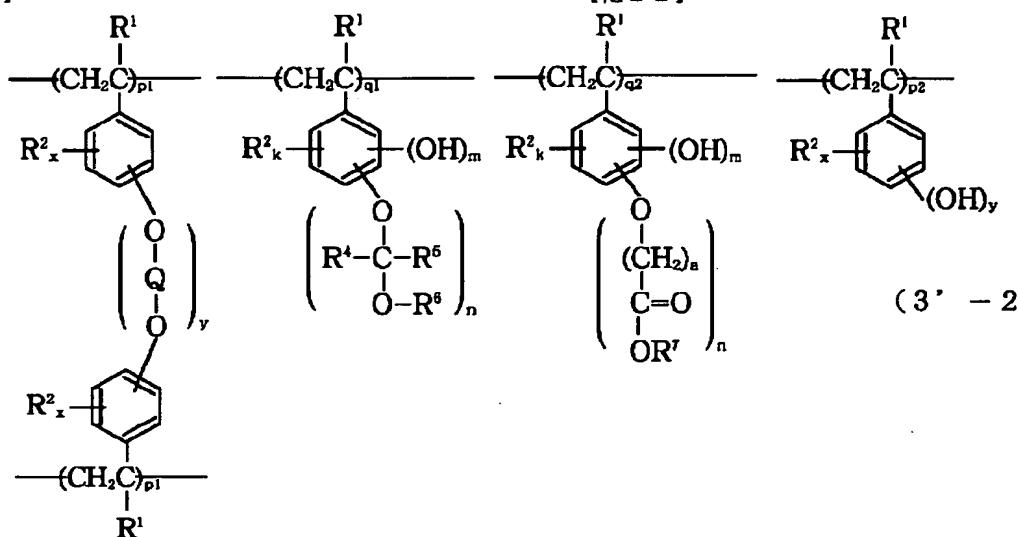
【0063】

【0064】

【化21】



【0065】

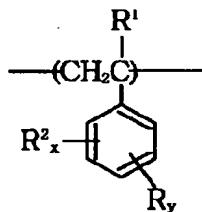


なお、式(3'-1)は分子間結合、式(3'-2)は分子内結合をしている状態を示し、これらはそれぞれ単独で又は混在していてもよい。

【0066】但し、QはC—O—C基を有する架橋基、典型的には上記式(4a)又は(4b)で示される架橋基、特に式(4a')、(4b')や(4a'')、(4b'')で示される架橋基である。この場合、架橋基が3価以上の場合、上記式(3)において、下記の単位の3個以上にQが結合したものとなる。

【0067】

【化23】



【0068】本発明の高分子化合物は、そのフェノール性水酸基の水素原子の一部が酸不安定基及び上記C—O—C基を有する架橋基で置換されているものであるが、より好ましくは、式(1)の化合物のフェノール性水酸基の水素原子全体に対して酸不安定基と架橋基との合計が平均0モル%を超える80モル%以下、特に2~50モル%であることが好ましい。

【0069】この場合、C—O—C基を有する架橋基の割合は平均0モル%を超える80モル%以下、特に1~20モル%が好ましい。0モル%となると、アルカリ溶解速度のコントラストが小さくなり、架橋基の長所を引き出すことができなくなり、解像度が悪くなる。一方、80モル%を超えると、架橋しすぎてゲル化し、アルカリに対して溶解性がなくなったり、アルカリ現像の際に膜厚変化や膜内応力又は気泡の発生を引き起こしたり、親水基が少なくなるために基板との密着性に劣る場合が

ある。

【0070】また、酸不安定基の割合は、平均0モル%を超える80モル%以下、特に10~50モル%が好ましい。0モル%になるとアルカリ溶解速度のコントラストが小さくなり、解像度が悪くなる。一方、80モル%を超えるとアルカリに対する溶解性がなくなったり、アルカリ現像の際に現像液との親和性が低くなり、解像性が劣る場合がある。

【0071】なお、C—O—C基を有する架橋基及び酸不安定基はその値を上記範囲内で適宜選定することによりパターンの寸法制御、パターンの形状コントロールを任意に行うことができる。本発明の高分子化合物において、C—O—C基を有する架橋基及び酸不安定基の含有量は、レジスト膜の溶解速度のコントラストに影響し、パターン寸法制御、パターン形状等のレジスト材料の特性にかかわるものである。

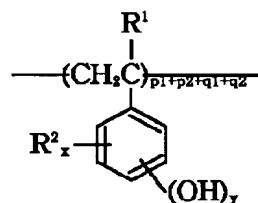
【0072】本発明に係る高分子化合物は、それぞれ重量平均分子量(測定法は後述の通りである)が、1,000~500,000、好ましくは3,000~30,000である必要がある。重量平均分子量が1,000に満たないとレジスト材料が耐熱性に劣るものとなり、500,000を超えるとアルカリ溶解性が低下し、解像性が劣化してしまうからである。

【0073】更に、本発明に係る高分子化合物において、架橋される前のベース樹脂の分子量分布( $M_w/M_n$ )が広い場合は低分子量や高分子量のポリマーが存在するために架橋数の設計がしづらく、同じ性能を持ったレジスト材料を製造するのが困難となる場合がある。それ故、パターンルールが微細化するに従ってこのような分子量、分子量分布の影響が大きくなり易いことから、微細なパターン寸法に好適に用いられるレジスト材料を得るには、分子量分布が1.0~1.5、特に1.0~1.3と狭分散であることが好ましい。ただし、これら

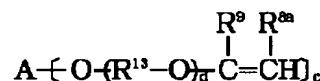
に限定されるものではなく、分子量分布が1.5より大きいものを使用することも勿論可能である。

【0074】本発明に係る高分子化合物を製造する方法としては、例えば一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基に一般式(5)で示される酸不安定基を導入し、単離後、アルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により分子内及び/又は分子間でC-O-C基を有する架橋基により架橋させる方法、或いはアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応により分子内及び/又は分子間でC-O-Cで示される基により架橋させ、単離後、一般式(5)で示される酸不安定基を導入する方法、或いはアルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエーテル化合物との反応と一般式(5)で示される酸不安定基の導入を一括に行う方法が挙げられるが、アルケニルエーテル化合物もしくはハロゲン化アルキルエー

### 第1方法



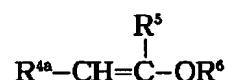
(1')



(I)



(II)



(5a)

【0077】ここで、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、x、y及びp<sub>1</sub>、p<sub>2</sub>、q<sub>1</sub>、q<sub>2</sub>は上記と同様の意味を示し、p<sub>1</sub>+p<sub>2</sub>+q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>=1である。また、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>は上記と同様の意味を示し、R<sup>4a</sup>、R<sup>5a</sup>は水素原子又は炭素数1~7の直鎖状、分歧状又は環状のアルキル基を示す。

【0078】更に、式(I)又は(II)で示されるビニルエーテル化合物において、Aはc値(cは2~6を示す)の有機基であり、Bは-CO-O-、-NHCO-O-又は-NHCONH-を示し、R<sup>13</sup>は炭素数1~10の直鎖状又は分歧状のアルキレン基を示し、dは0又は1~10の整数、cは2~8の整数を示す。

【0079】Aのc値の有機基は、具体的には、炭化水素基として好ましくは炭素数1~50、特に1~40の

テル化合物との反応と一般式(5)で示される酸不安定基の導入を一括に行う方法が好ましい。また、これによって得られた高分子化合物に、必要に応じて一般式(6)で示される酸不安定基、tert-アルキル基、トリアルキルシリル基、ケトアルキル基等の導入を行うことも可能である。

【0075】具体的には、第1方法として、式(1')で示される繰り返し単位を有する高分子化合物と、下記一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物と、下記一般式(5a)で示される化合物を用いる方法、第2方法として、式(1')で示される繰り返し単位を有する高分子化合物と、下記一般式(VI)I又は(VIII)で示されるハロゲン化アルキルエーテル化合物と、下記一般式(5b)で示される化合物を用いる方法が挙げられる。

【0076】

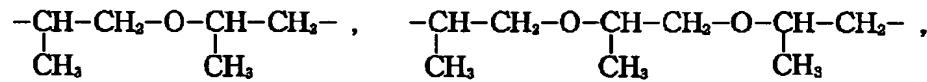
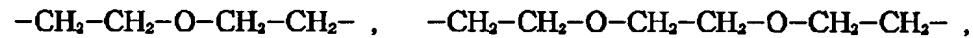
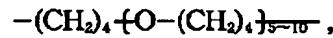
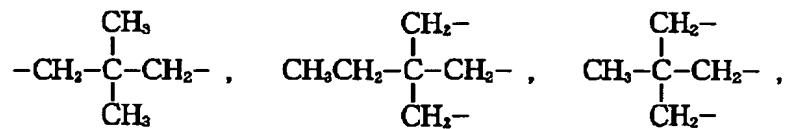
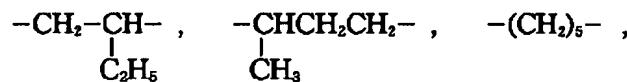
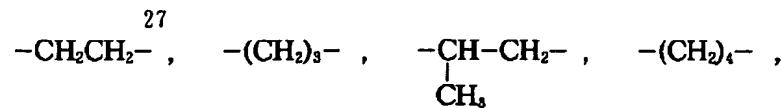
【化24】

O、NH、N(CH<sub>3</sub>)、S、SO<sub>2</sub>等のヘテロ原子が介在してもよい非置換又は水酸基、カルボキシル基、カルボニル基又はフッ素原子置換のアルキレン基、好ましくは炭素数6~50、特に6~40のアリーレン基、これらアルキレン基とアリーレン基とが結合した基、上記各基の炭素原子に結合した水素原子が脱離したc"値(c"は3~8の整数)の基が挙げられ、更にc値のヘテロ環基、このヘテロ環基と上記炭化水素基とが結合した基などが挙げられる。

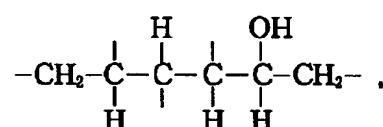
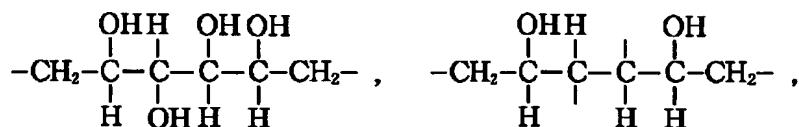
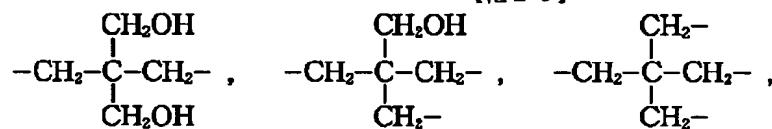
【0080】具体的に例示すると、Aとして下記のものが挙げられる。

【0081】

【化25】

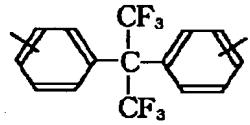
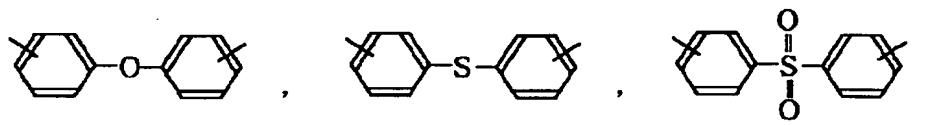
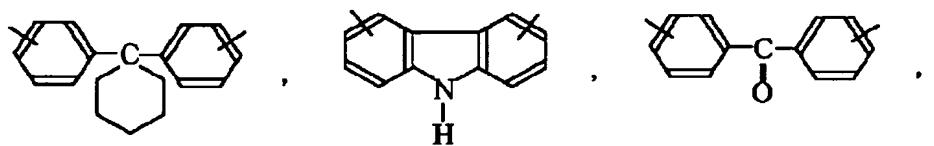
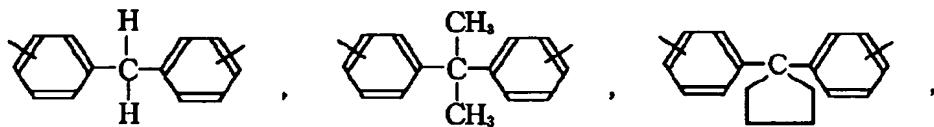
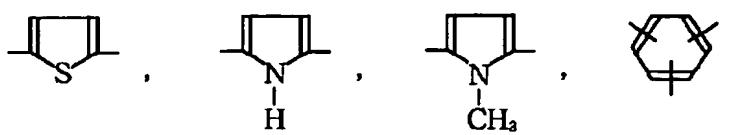
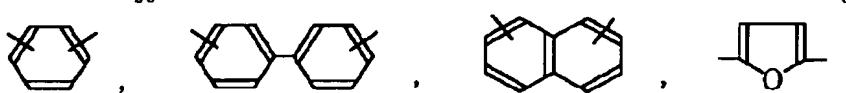


【0082】



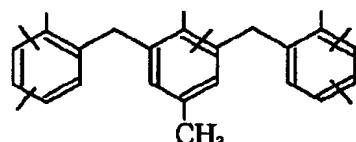
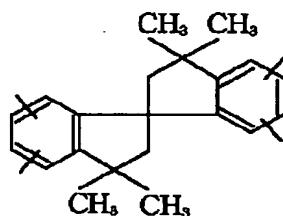
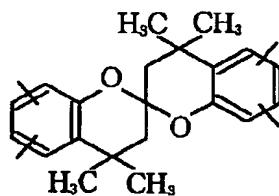
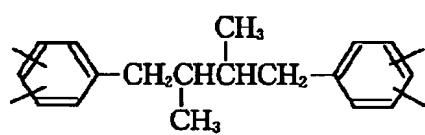
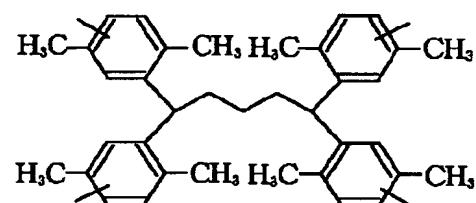
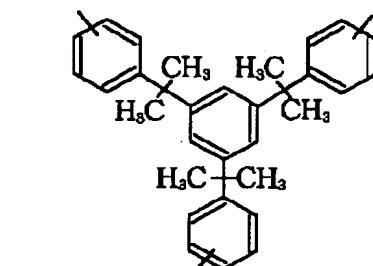
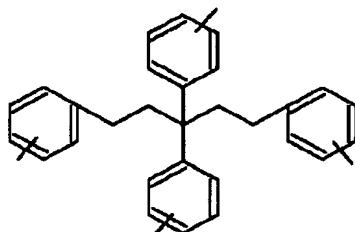
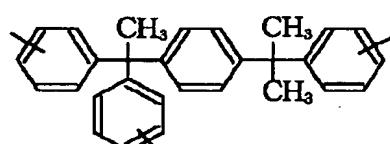
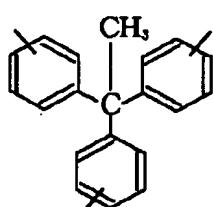
【0083】

【化27】



【0084】

【化28】



【0085】一般式 (I) で示される化合物は、例えば、Stephen. C. Lapin, Polymer s Paint Colour Journal. 17 9 (4237)、321 (1988) に記載されている方法、即ち多価アルコールもしくは多価フェノールとアセチレンとの反応、又は多価アルコールもしくは多価フェノールとハロゲン化アルキルビニルエーテルとの反応により合成することができる。

【0086】式 (I) の化合物の具体例として、エチレングリコールジビニルエーテル、トリエチレングリコ

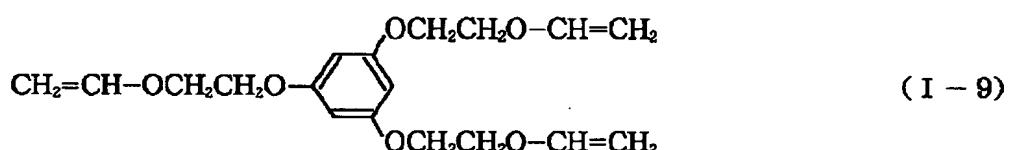
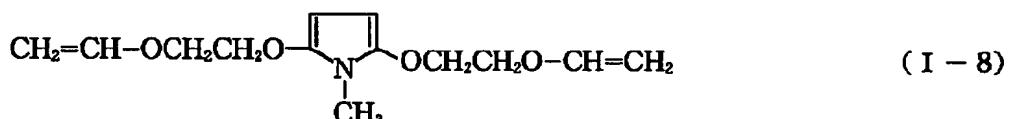
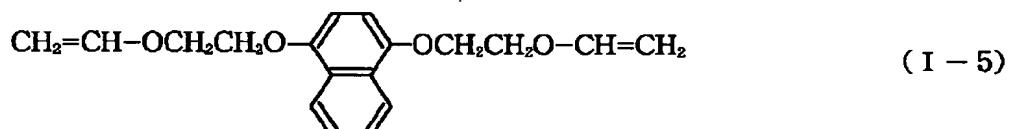
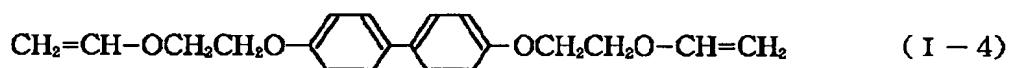
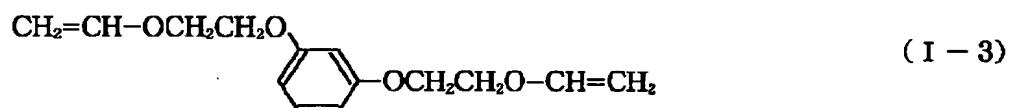
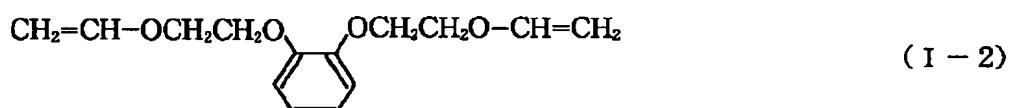
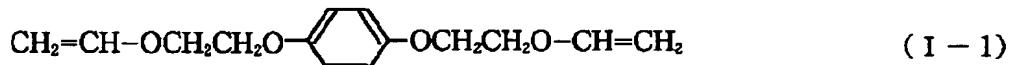
ルジビニルエーテル、1, 2-プロパンジオールジビニルエーテル、1, 3-プロパンジオールジビニルエーテル、1, 3-ブタンジオールジビニルエーテル、1, 4-ブタンジオールジビニルエーテル、テトラメチレングリコールジビニルエーテル、ネオペンチルグリコールジビニルエーテル、トリメチロールプロパントリビニルエーテル、トリメチロールエタントリビニルエーテル、ヘキサンジオールジビニルエーテル、1, 4-シクロヘキサンジオールジビニルエーテル、テトラエチレングリコールジビニルエーテル、ペンタエリスリトールジビニル

エーテル、ペンタエリスリトールトリビニルエーテル、ペンタエリスリトールテトラビニルエーテル、ソルビトールテトラビニルエーテル、ソルビトールペンタビニルエーテル、エチレングリコールジエチレンビニルエーテル、トリエチレングリコールジエチレンビニルエーテル、エチレングリコールジプロピレンビニルエーテル、トリエチレングリコールジエチレンビニルエーテル、トリエチレングリコールジエチレンビニルエーテル、ト

リメチロールプロパンジエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトールジエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトールトリエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトールテトラエチレンビニルエーテル並びに以下の式 (I-1) ~ (I-31) で示される化合物を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

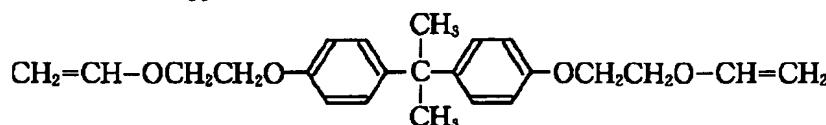
【0087】

【化29】

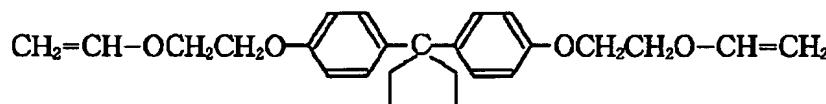


【0088】

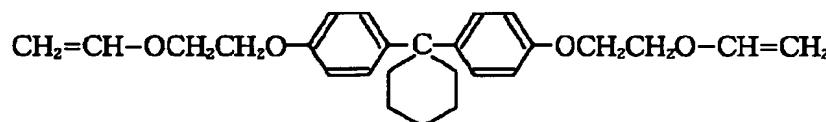
【化30】



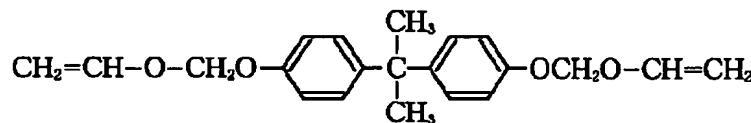
(I - 10)



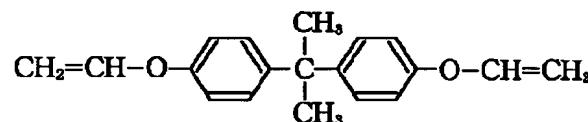
( I - 11 )



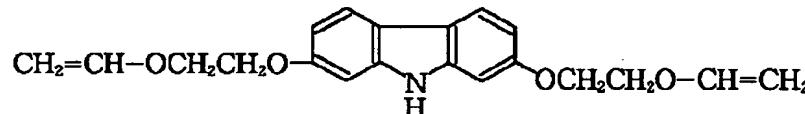
( I - 12)



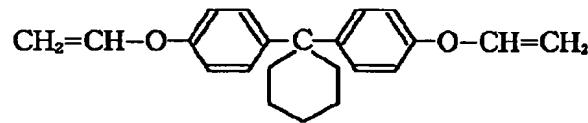
( I - 13)



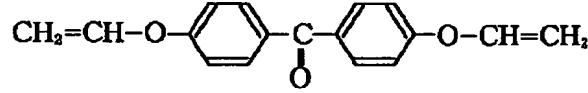
( I - 14)



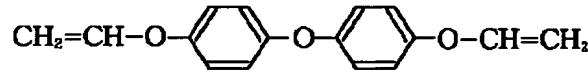
( I - 15)



(I - 16)

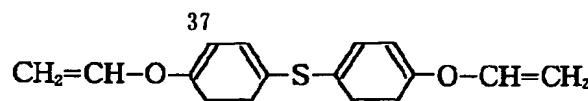


(I-17)

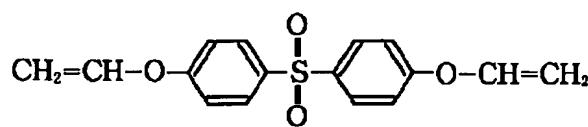


( I - 18)

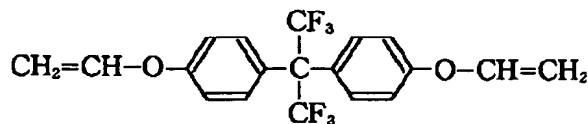
38



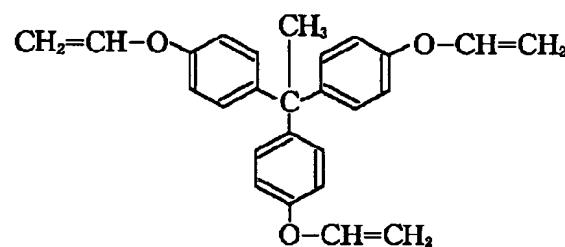
( I - 19)



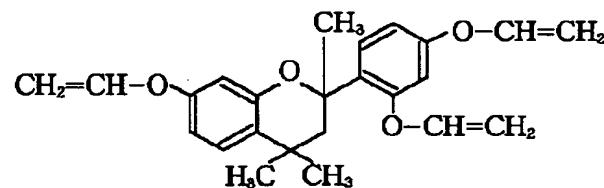
( I - 20)



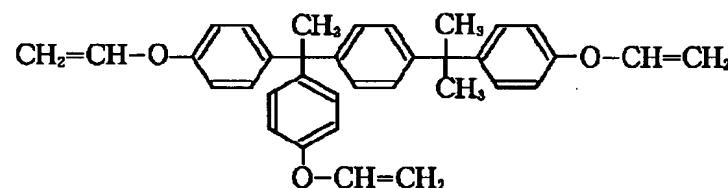
( I - 21)



( I - 22)



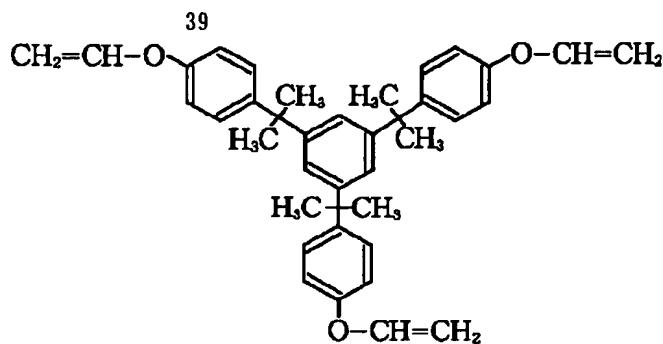
( I - 23)



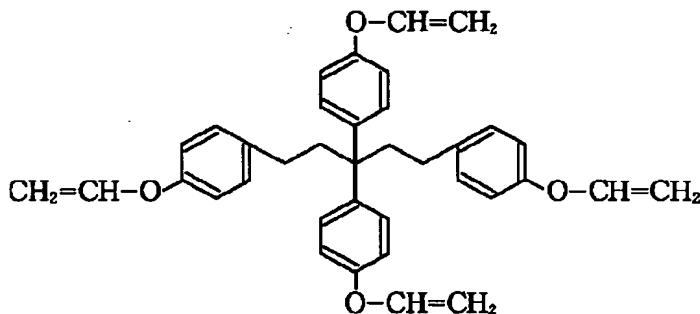
( I - 24)

【0090】

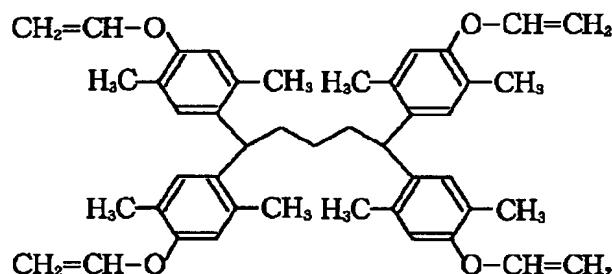
【化32】



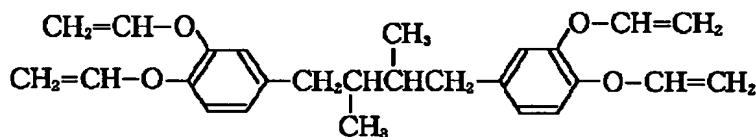
( I - 25)



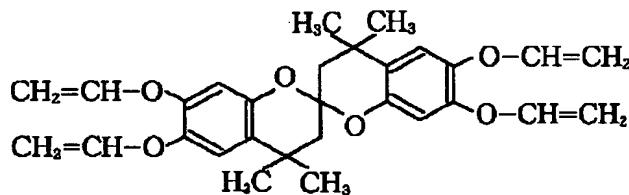
( I - 26)



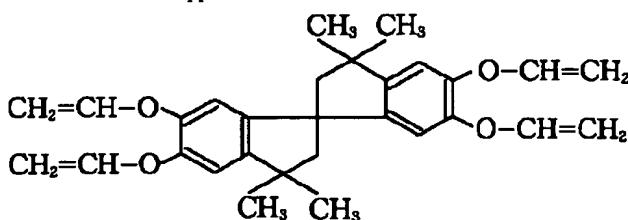
( I - 27)



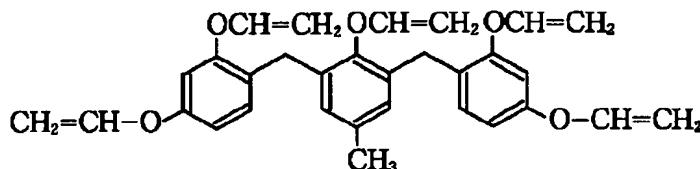
( I - 28)



( I - 29)



( I - 30)



( I - 31)

【0092】一方、Bが-CO-O-の場合の上記一般式(I I)で示される化合物は、多価カルボン酸とハロゲン化アルキルビニルエーテルとの反応により製造することができる。Bが-CO-O-の場合の式(I I)で示される化合物の具体例としては、テレフタル酸ジエチレンビニルエーテル、フタル酸ジエチレンビニルエーテル、イソフタル酸ジエチレンビニルエーテル、フタル酸ジプロピレンビニルエーテル、テレフタル酸ジプロピレンビニルエーテル、イソフタル酸ジプロピレンビニルエーテル、マレイン酸ジエチレンビニルエーテル、フマル酸ジエチレンビニルエーテル、イタコン酸ジエチレンビ

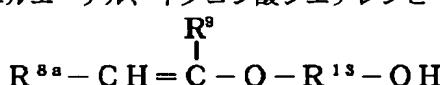
20

ニルエーテル等を挙げることができるが、これらに限定されるものではない。

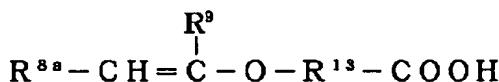
【0093】更に、本発明において好適に用いられるアルケニルエーテル基含有化合物としては、下記一般式(I I I)、(I V)又は(V)等で示される活性水素を有するアルケニルエーテル化合物とイソシアナート基を有する化合物との反応により合成されるアルケニルエーテル基含有化合物を挙げることができる。

【0094】

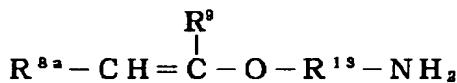
【化34】



( I I I )



( I V )



( V )

(R<sup>8a</sup>、R<sup>8</sup>、R<sup>13</sup>は上記と同様の意味を示す。)

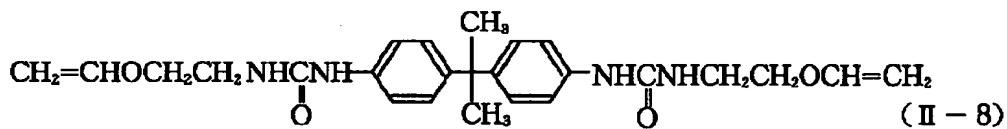
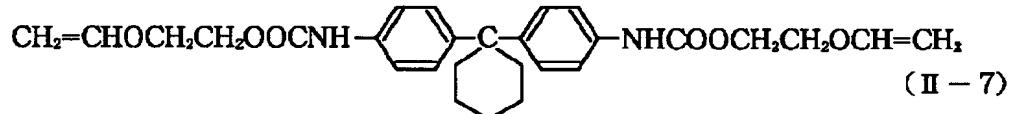
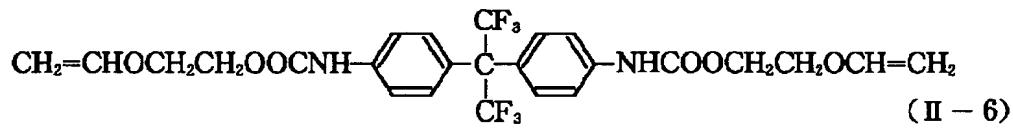
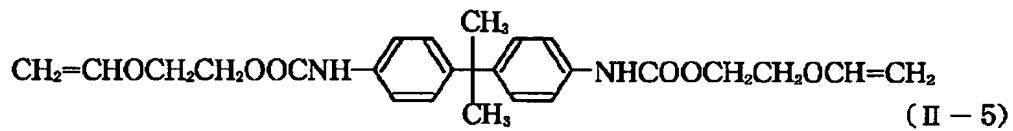
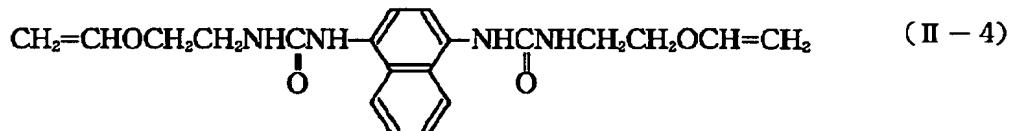
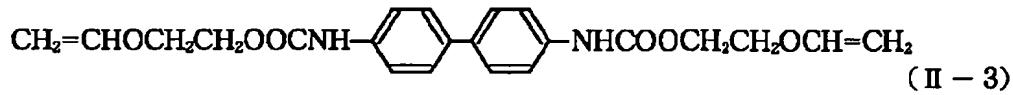
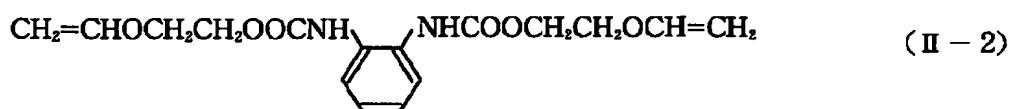
【0095】Bが-NHCO-O-又は-NHCONH-の場合の上記一般式(I I)で示されるイソシアナート基を有する化合物としては、例えば架橋剤ハンドブック(大成社刊、1981年発行)に記載の化合物を用いることができる。具体的には、トリフェニルメタントリイソシアナート、ジフェニルメタンジイソシアナート、トリレンジイソシアナート、2,4-トリレンジイソシアナートの二量体、ナフタレン-1,5-ジイソシアナート、o-トリレンジイソシアナート、ポリメチレンポリフェニルイソシアナート、ヘキサメチレンジイソシアナート等のポリイソシアナート型、トリレンジイソシア

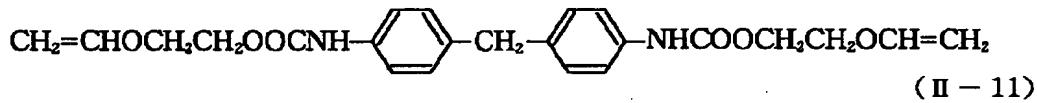
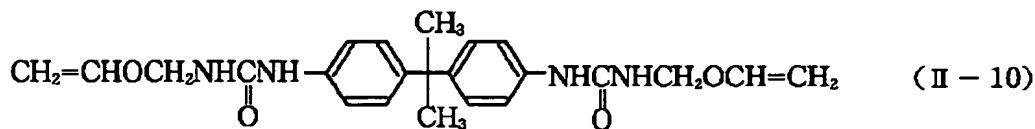
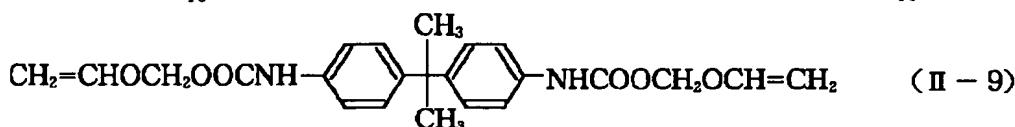
40

ナートとトリメチロールプロパンの付加体、ヘキサメチレンジイソシアナートと水との付加体、キシレンジイソシアナートとトリメチロールプロパンとの付加体等のポリイソシアナートアダクト型等を挙げることができる。上記イソシアナート基含有化合物と活性水素含有アルケニルエーテル化合物とを反応させることにより末端にアルケニルエーテル基を持つ種々の化合物ができる。このような化合物として以下の式(I I - 1)～(I I - 1)で示されるものを挙げができるが、これらに限定されるものではない。

【0096】

【化35】



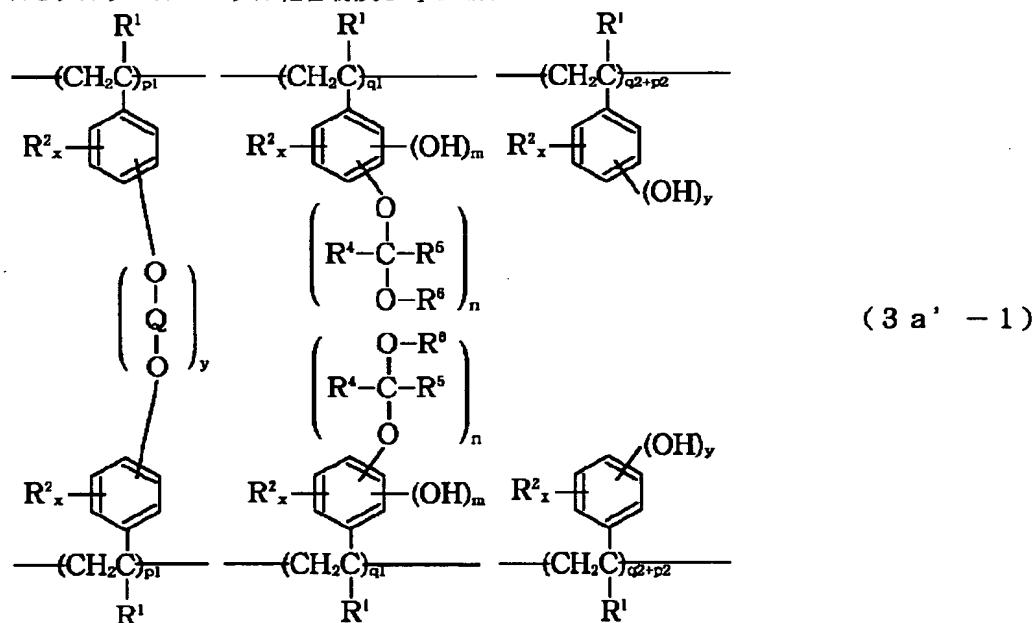


【0098】上記第1方法においては、重量平均分子量が1,000~500,000であり、好ましくは分子量分布が1.0~1.5の一般式(1')で示される高分子化合物のフェノール性水酸基の水素原子をその全水酸基の1モルに対してp 1モルの一般式(I)、(I-I')で示されるアルケニルエーテル化合物及びq 1モル

の一般式(5a)で示される化合物を反応させて、例えば下記一般式(3a'-1)又は(3a'-2)で示される高分子化合物を得ることができる。

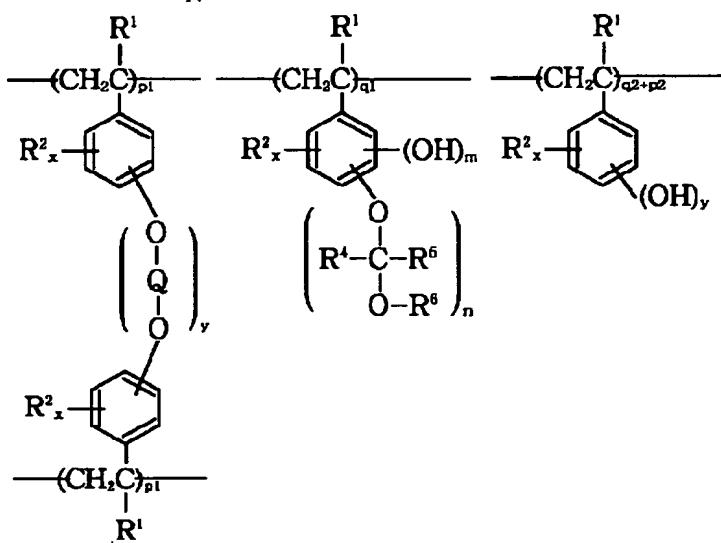
【0099】

【化37】



【0100】

【化38】



(3 a' - 2)

(式中、 $m+n=y$ であり、 $m$ 、 $n$ 、 $x$ 、 $y$ 、 $p$ 1、 $p$ 2、 $q$ 1、 $q$ 2、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $Q$ はそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

【0101】反応溶媒としては、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、酢酸エチル等の非プロトン性極性溶媒が好ましく、単独でも2種以上混合して使用してもかまわない。

【0102】触媒の酸としては、塩酸、硫酸、トリフルオロメタンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸、メタニスルホン酸、p-トルエンスルホン酸ビリジニウム塩等が好ましく、その使用量は反応する一般式(1)で示される高分子化合物のフェノール性水酸基の水素原子をその全水酸基の1モルに対して0.1~10モル%であることが好ましい。

【0103】反応温度としては-20~100°C、好ましくは0~60°Cであり、反応時間としては0.2~100時間、好ましくは0.5~20時間である。

【0104】上記反応を単離せずに一括して行う場合、一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物と一般式(5a)で示される化合物の添加する順序は特に限定しないが、初めに一般式(5a)で示される化合物を添加し、反応が十分進行した後に一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物を添加するのが好ましい。例えば一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物と一般式(5a)で示される化合物を同時に添加したり、一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物を先に添加した場合には、一般式(I)又は(II)で示されるアルケニルエーテル化合物の反応点の一部が反応系中の水分により加水分解され、生成した高分子化合物の構造が複雑化し、物性の制御が困難となる場合がある。

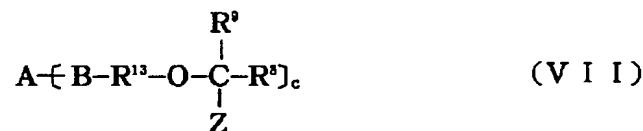
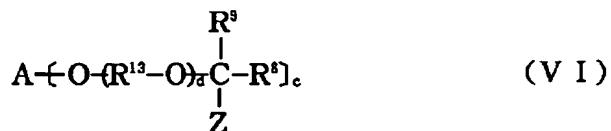
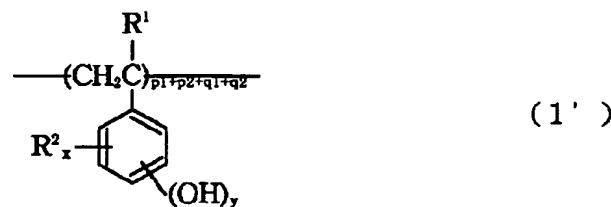
【0105】

【化39】

20 20

30 30

## 第2方法



(式中、 $\text{R}^1$ 、 $\text{R}^2$ 、 $x$ 、 $y$ 、 $p_1$ 、 $p_2$ 、 $q_1$ 、 $q_2$ 、 $\text{R}^3$ 、 $\text{R}^4$ 、 $\text{R}^5$ 及び $\text{R}^6$ 、 $\text{R}^{13}$ 、 $\text{A}$ 、 $\text{B}$ 、 $\text{c}$ 、 $\text{d}$ はそれぞれ上記と同様の意味を示し、 $\text{Z}$ はハロゲン原子(C 1、B r又はI)である。)

【0106】なお、上記式(V I)、(V I I)の化合物や式(5 b)の化合物は、上記式(I)、(I I)の化合物や式(5 a)の化合物に塩化水素、臭化水素又はヨウ化水素を反応させることにより得ることができる。

【0107】上記第2方法は、重量平均分子量が1,000~500,000であり、好ましくは分子量分布が1.0~1.5の一般式(1')で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基の水素原子をその全水酸基の1モルに対して $p_1$ モルの一般式(V I)又は(V I I)で示されるハロゲン化アルキルエーテル化合物及び $q_1$ モルの一般式(5 b)で示される化合物を反応させて、例えば上記式(3 a'-1)、(3 a'-2)で示される高分子化合物を得ることができる。

【0108】上記製造方法は、溶媒中において塩基の存在下で行うことが好ましい。

【0109】反応溶媒としては、アセトニトリル、アセ

トン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒が好ましく、単独でも2種以上混合して使用してもかまわない。

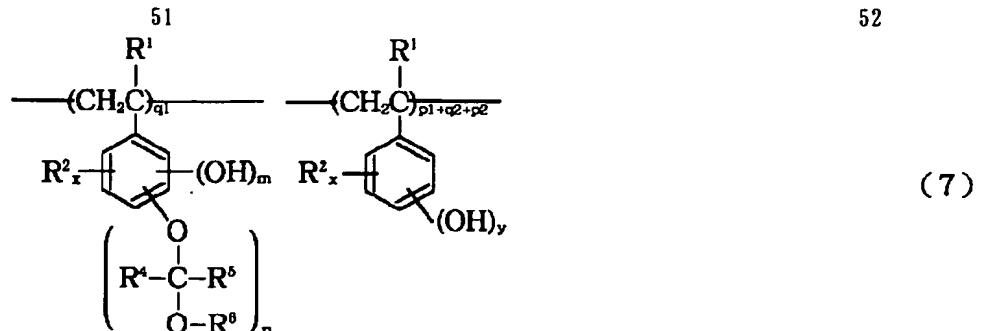
【0110】塩基としては、トリエチルアミン、ピリジン、ジイソプロピルアミン、炭酸カリウム等が好ましく、その使用量は反応する一般式(1)で示される高分子化合物のフェノール性水酸基の1モルに対して $(p_1+q_1)$ モル以上であることが好ましい。

【0111】反応温度としては-50~100°C、好ましくは0~60°Cであり、反応時間としては0.5~100時間、好ましくは1~20時間である。

【0112】なお、上述したように、式(1')で示される繰り返し単位を有する高分子化合物に式(5 a)又は(5 b)の化合物を反応させて、下記式(7)で示される化合物を得た後、これを単離し、次いで式(I)、(I I)或いは(V I)、(V I I)で示される化合物を用いて架橋を行うようにしてもよい。

【0113】

【化40】

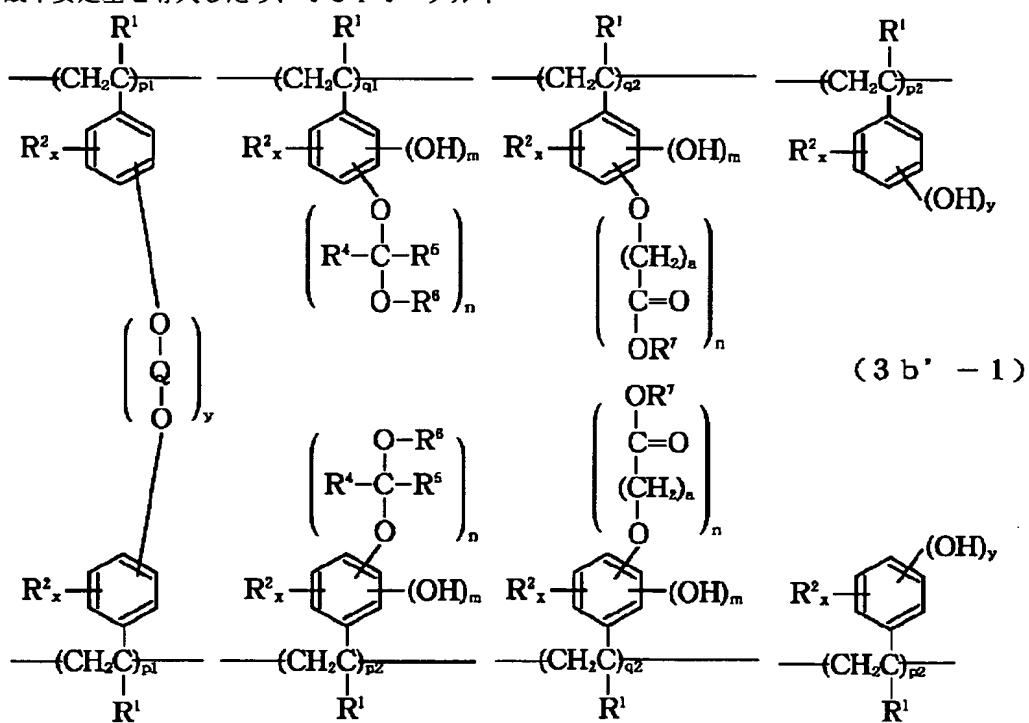


【0114】上記第1又は第2方法により得られた例え  
ば式(3a'-1)、(3a'-2)で示されるような  
高分子化合物に、必要に応じて元の一般式(1')で示  
される高分子化合物のフェノール性水酸基の1モルに対  
してq2モルの二炭酸ジアルキル化合物、アルコキシカ  
ルボニルアルキルハライド等を反応させて一般式(6)  
で示される酸不安定基を導入したり、tert-アルキ

10 ルハライド、トリアルキルシリルハライド、ケトアルキ  
ル化合物等を反応させて、例えば一般式(3b'-  
1)、(3b'-2)で示される高分子化合物を得るこ  
とができる。

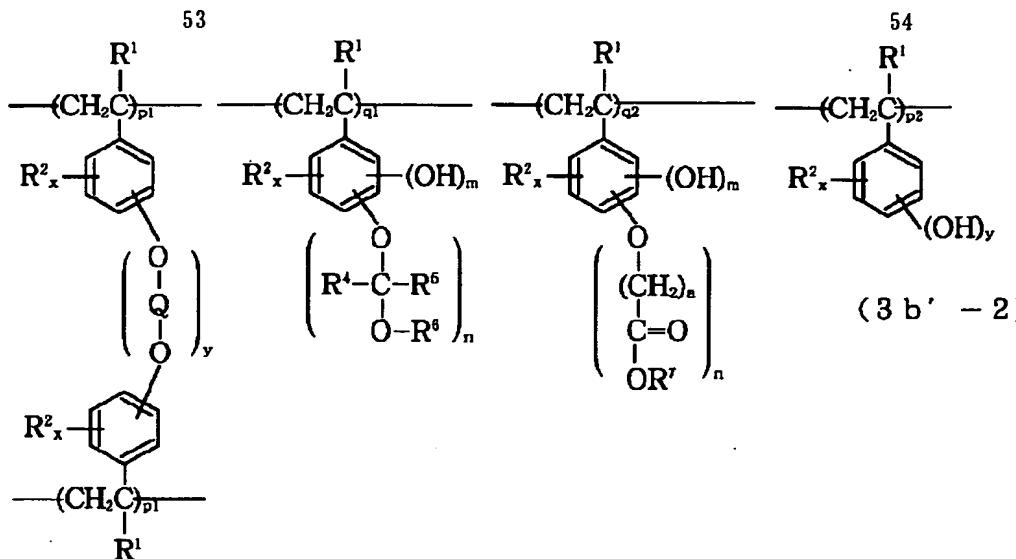
【0115】

【化41】



【0116】

【化42】



【0117】上記式(6)の酸不安定基の導入方法は、溶媒中において塩基の存在下で行うことが好ましい。

【0118】反応溶媒としては、アセトニトリル、アセトン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒が好ましく、単独でも2種以上混合して使用してもかまわない。

【0119】塩基としては、トリエチルアミン、ピリジン、イミダゾール、ジイソプロピルアミン、炭酸カリウム等が好ましく、その使用量は元の一般式(1)で示される高分子化合物のフェノール性水酸基の1モルに対してq2モルであることが好ましい。

【0120】反応温度としては0~100℃、好ましくは0~60℃である。反応時間としては0.2~100時間、好ましくは1~10時間である。

【0121】二炭酸ジアルキル化合物としては二炭酸ジ-tert-ブチル、二炭酸ジ-tert-アミル等が挙げられ、アルコキシカルボニルアルキルハライドとしてはtert-ブトキシカルボニルメチルクロライド、tert-アミロキシカルボニルメチルクロライド、tert-ブトキシカルボニルメチルブロマイド、tert-ブトキシカルボニルエチルクロライド等が挙げられ、トリアルキルシリルハライドとしてはトリメチルシリルクロライド、トリエチルシリルクロライド、ジメチル-tert-ブチルシリルクロライド等が挙げられる。

【0122】また、上記第1又は第2の方法により得られた一般式(3a'-1)、(3a'-2)で示される高分子化合物に、必要に応じて元の一般式(1')で示される高分子化合物のフェノール性水酸基の1モルに対してq2モルのtert-アルキル化剤、ケトアルキル化合物を反応させてtert-アルキル化又はケトアル

キル化することができる。

【0123】上記方法は、溶媒中において酸の存在下で行うことが好ましい。

20 【0124】反応溶媒としては、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラヒドロフラン、酢酸エチル等の非プロトン性極性溶媒が好ましく、単独でも2種以上混合して使用してもかまわない。

【0125】触媒の酸としては、塩酸、硫酸、トリフルオロメタンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸、メタノンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸ピリジニウム塩等が好ましく、その使用量は元の一般式(1')で示される高分子化合物のフェノール性水酸基の1モルに対して0.1~10モル%であることが好ましい。

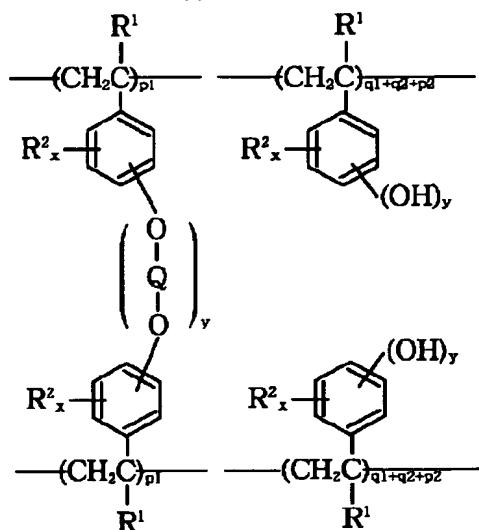
【0126】反応温度としては-20~100℃、好ましくは0~60℃であり、反応時間としては0.2~100時間、好ましくは0.5~20時間である。

【0127】tert-アルキル化剤としてはiso-ブテン、2-メチル-1-ブテン、2-メチル-2-ブテン等が挙げられ、ケトアルキル化合物としてはα-アンジエリカラクトン、2-シクロヘキセン-1-オン、5,6-ジヒドロ-2H-ピラン-2-オン等が挙げられる。

40 【0128】なお、一般式(3a'-1)、(3a'-2)で示される高分子化合物を経由せずに直接下記一般式(3c'-1)、(3c'-2)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物に一般式(6)で示される酸不安定基、tert-アルキル基、トリアルキルシリル基、ケトアルキル基等を導入後、必要に応じて一般式(5)で示される酸不安定基を導入することもできる。

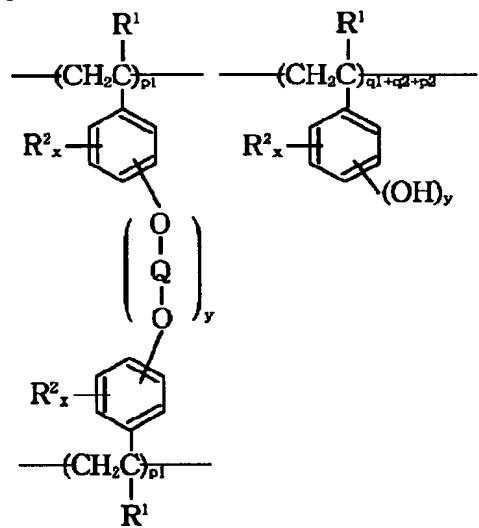
【0129】

【化43】



(3c'-1)

【0130】



【化44】

(3c'-2)

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、Q、p1、p2、q1、q2、x、yはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

【0131】本発明に係る高分子化合物において、R<sup>3</sup>の酸不安定基としては1種に限られず、2種以上を導入することができる。この場合、式(1')の高分子化合物の全水酸基1モルに対してq1モルの酸不安定基を上記のようにして導入した後、これと異なる酸不安定基を上記と同様の方法でq2モル導入することによって、かかる酸不安定基を2種又は適宜かかる操作を繰り返してそれ以上導入した高分子化合物を得ることができる。

【0132】本発明の化学增幅ポジ型レジスト材料は、上記高分子化合物をベースポリマーとして用いるもので、下記成分を含有する。

(A)：有機溶剤、

(B)：ベース樹脂として上記式(1)、好ましくは式(2)、更に好ましくは式(3)の高分子化合物、

(C)：酸発生剤、

(D)：塩基性化合物、及び

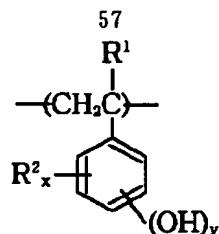
(E)：分子内に≡C-COOHで示される基を有する芳香族化合物。

【0133】この場合、本発明のレジスト材料は、上記(A)～(E)成分に加え、更に下記(F)～(I)成分の1種又は2種以上を含有することができる。

(F)：(B)成分とは別のベース樹脂として、下記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のフェノール性水酸基の水素原子を1種又は2種以上の酸不安定基により全体として平均0モル%以上80モル%以下の割合で部分置換した重量平均分子量3,000～300,000の高分子化合物。

【0134】

【化45】



(式中、R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>2</sup>は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。また、xは0又は正の整数、yは正の整数であり、x+y≤5を満足する数である。)

(G) : 溶解制御剤。

(H) : 紫外線吸収剤。

(I) : アセチレンアルコール誘導体。

【0135】ここで、本発明で使用される(A)成分の有機溶剤としては、酸発生剤、ベース樹脂、溶解制御剤等が溶解可能な有機溶媒であれば何れでも良い。このような有機溶剤としては、例えばシクロヘキサン、メチル-2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキシブタノール、3-メチル-3-メトキシブタノール、1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール等のアルコール類、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ビルビン酸エチル、酢酸ブチル、メチル-3-メトキシプロピオネート、エチル-3-エトキシプロピオネート、酢酸tert-ブチル、プロピオン酸tert-ブチル、プロピレングリコールモノtert-ブチルエーテルアセテート等のエステル類が挙げられ、これらの1種を単独で又は2種以上を混合して使用することができるが、これらに限定されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中でもレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れているエチレングリコールジメチルエーテルや1-エトキシ-2-プロパノール、乳酸エチルの他、安全溶剤であるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート及びその混合溶剤が好ましく使用される。

【0136】有機溶剤の使用量は、ベース樹脂(上記(B)成分と(D)成分との合計量、以下同様)100部(重量部、以下同様)に対して200～1,000部、特に400～800部が好適である。

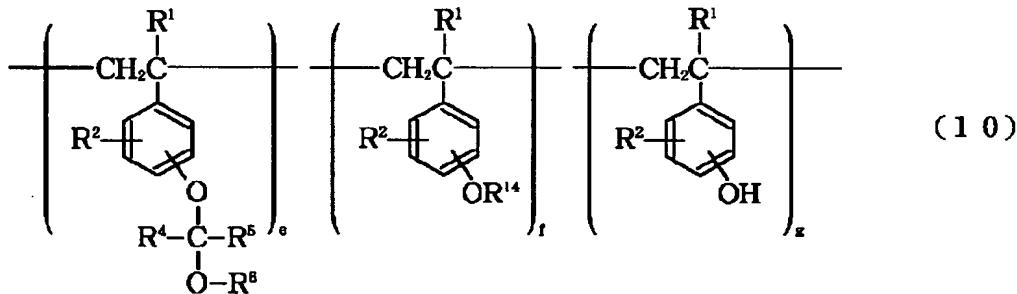
【0137】(C)成分の酸発生剤としては、例えばトリフルオロメタンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)フェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)フェニルヨード

ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、トリ

10 リフルオロメタンスルホン酸ビス(p-tert-ブトキシフェニル)フェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)フェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)スルホニウム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、ブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム等のオニウム塩、2-シクロヘキシルカルボニル-2-(p-トルエンスルホニル)プロパン、2-isoo-プロピルカルボニル-2-(p-トルエンスルホニル)プロパン等のβ-ケトスルホン誘導体、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(p-トルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(iso-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(sec-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(iso-プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(tert-ブチルスルホニル)ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導体、ジフェニルジスルホン、ジシクロヘキシルジスルホン等のジスルホン誘導体、p-トルエンスルホン酸2,6-ジニトロベンジル、p-トルエンスルホン酸2,4-ジニトロベンジル等のニトロベンジルスルホネート誘導体、1,2,3-トリス(メタノスルホニルオキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(トリフルオロメタンスルホニルオキシ)ベンゼン、1,2,3-トリス(p-トルエンスルホニルオキシ)

20 30 40 50

ベンゼン等のスルホン酸エステル誘導体、フタルイミド-イルートリフレート、フタルイミド-イルートシート、5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミド-イルートリフレート、5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミド-イルートシート、5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミド-イル-n-ブチルスルホネート等のイミド-イルースルホネート誘導体等が挙げられるが、トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)スルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸(p-tert-ブトキシフェニル)ジフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニル)スルホニウム等のオニウム塩、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(p-トルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(iso-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(sec-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(iso-プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(tert-ブチルスルホニル)ジア



〔0142〕上記式において、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ は上記と同様の意味を示し、 $R^{14}$ は上記式(5)とは異なる酸不安定基であり、例えば上記式(6)で示される基、tert-アルキル基、トリアルキルシリル基、ケトアルキル基等である。

【0143】e, f はそれぞれ0又は正数であり、e, f が同時に0となることがあり、g は正数であり、 $e + f + g = 1$  である。これらの組成比は  $0 \leq e / (e + f + g) \leq 0.5$ 、好ましくは  $0.1 \leq e / (e + f + g) \leq 0.4$ 、 $0 \leq f / (e + f + g) \leq 0.5$ 、好ましくは  $0 \leq f / (e + f + g) \leq 0.2$ 、 $0.4 \leq g / (e + f + g) \leq 0.9$ 、好ましくは  $0.6 \leq g / (e + f + g) \leq 0.8$  である。e の全体 ( $e + f + g$ 、以下同様) に対する割合が 0.5 を超え、f の全体に対する割合が 0.5 を超え、g の全体に対する割合が 0.9 を超えるか、或いは g の全体に対する割合が 0.4 に満たないと、アルカリ溶解速度のコントラストが小さくな

ゾメタン等のジアゾメタン誘導体が好ましく用いられる。なお、上記酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。オニウム塩は矩形性向上効果に優れ、ジアゾメタン誘導体は定在波低減効果に優れるが、両者を組み合わせることにより、プロファイルの微調整を行うことが可能である。

〔0138〕酸発生剤の添加量は、ベース樹脂100部に対して好ましくは0.5～1.5部、より好ましくは1～8部である。0.5部より少ないと感度が悪い場合があり、1.5部より多いとアルカリ溶解速度が低下することによってレジスト材料の解像性が低下する場合があり、またモノマー成分が過剰となるために耐熱性が低下する。

する場合がある。

【0139】(F) 成分の上記(B)成分に係る架橋されている高分子化合物とは別のベース樹脂としては、特に下記一般式(10)で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量が3,000~300,000の高分子化合物が好適に使用される。

【0140】更に(F)成分を配合することにより、パターンの寸法制御、パターンの形状コントロールを行なうことができる。

[0 1 4 1]

【化 4 6】

り、解像度が悪くなる場合がある。e、f、gはその値を上記範囲内で適宜選定することによりパターンの寸法制御、パターンの形状コントロールを任意に行うことができる。

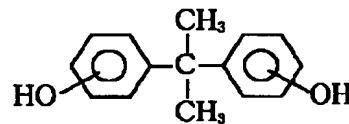
【0144】このような高分子化合物は、重量平均分子量が3,000～300,000、好ましくは5,000～30,000である必要がある。重量平均分子量が3,000に満たないとレジスト材料が耐熱性に劣るものとなり、300,000を超えるとアルカリ溶解性が低下し、解像性が悪くなる。

【0145】更に、この(F)成分のベース樹脂おいても、分子量分布( $M_w/M_n$ )が広い場合は低分子量や高分子量のポリマーが存在し、低分子量のポリマーが多く存在すると耐熱性が低下する場合があり、高分子量のポリマーが多く存在するとアルカリに対して溶解し難いものを含み、パターン形成後の裾引きの原因となる場合がある。それ故、パターンルールが微細化するに従って

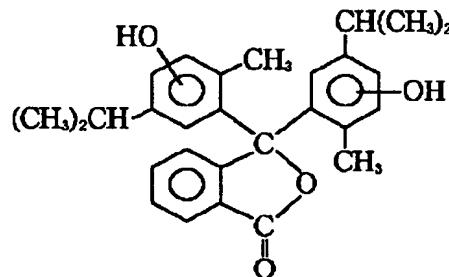
このような分子量、分子量分布の影響が大きくなり易いことから、微細なパターン寸法に好適に用いられるレジスト材料を得るには、ベース樹脂の分子量分布は 1.0 ~ 2.5、特に 1.0 ~ 1.5 の狭分散であることが好ましい。

【0146】なお、(F) 成分のベース樹脂の配合量と (B) 成分のベース樹脂(架橋されている高分子化合物)との配合割合は、0 : 100 ~ 90 : 10 の重量比が好ましく、特に 0 : 100 ~ 50 : 50 が好適である。上記(F)成分のベース樹脂の配合量が上記重量比より多いと、(B)成分のベース樹脂(架橋されている高分子化合物)による所望の効果が得られない場合がある。

【0147】本発明のレジスト材料には、更に(G)成分として溶解制御剤を添加することができ、これによりコントラストを向上させることができる。溶解制御剤と



(i)



(ii)

【0151】

30 【化48】

しては、平均分子量が 100 ~ 1,000、好ましくは 150 ~ 800 で、かつ分子内にフェノール性水酸基を 2 つ以上有する化合物の該フェノール性水酸基の水素原子を酸不安定基により全体として平均 0 ~ 100 % の割合で置換した化合物を配合する。

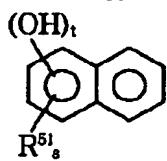
【0148】なお、フェノール性水酸基の水素原子の酸不安定基による置換率は、平均でフェノール性水酸基全体の 0 モル % 以上、好ましくは 30 モル % 以上であり、また、その上限は 100 モル %、より好ましくは 80 モル % である。

【0149】この場合、かかるフェノール性水酸基を 2 つ以上有する化合物としては、下記式 (i) ~ (xi) で示されるものが好ましい。

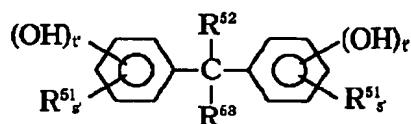
【0150】

【化47】

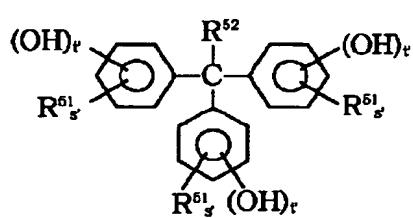
63



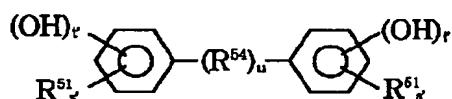
(iii)



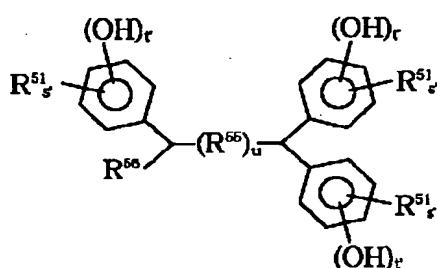
(iv)



(v)



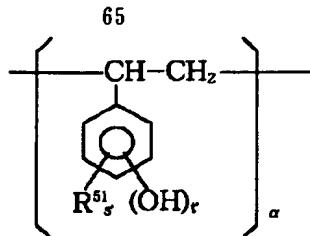
(vi)



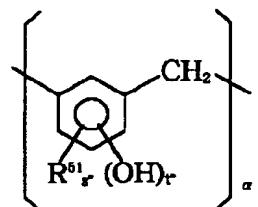
(vii)

【0152】

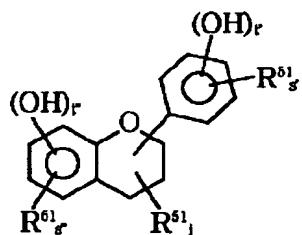
【化49】



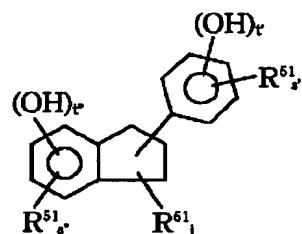
(viii)



(ix)



(x)



(xi)

(但し、式中  $R^{61}$ 、 $R^{62}$  はそれぞれ水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基であり、 $R^{63}$  は水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分岐状のアルキル基又はアルケニル基、あるいは  $- (R^{61})_n - COOH$  であり、 $R^{64}$  は  $- (CH_2)_i -$  ( $i = 2 \sim 10$ )、炭素数 6～10 のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子、 $R^{65}$  は炭素数 1～10 のアルキレン基、炭素数 6～10 のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子、 $R^{66}$  は水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分岐状のアルキル基、アルケニル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニル基又はナフチル基であり、 $R^{67}$  は炭素数 1～10 の直鎖状又は分岐状のアルキレン基である。また、 $j$  は 0～5 の整数であり、 $h$  は 0 又は 1 である。 $s$ 、 $t$ 、 $s'$ 、 $t'$ 、 $s''$ 、 $t''$  はそれぞれ  $s + t = 8$ 、 $s' + t' = 5$ 、 $s'' + t'' = 4$  を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくとも 1 つの水酸基を有するような数である。 $\alpha$  は式 (viii)、(ix) の化合物の分子量を 100～1,000 とする数である。)

【0153】上記式中  $R^{61}$ 、 $R^{62}$  としては、例えば水素

40

原子、メチル基、エチル基、ブチル基、プロピル基、エチニル基、シクロヘキシル基、 $R^{63}$  としては、例えば  $R^{61}$ 、 $R^{62}$  と同様なもの、あるいは  $-COOH$ 、 $-CH_2COOH$ 、 $R^{64}$  としては、例えばエチレン基、フェニレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子、硫黄原子等、 $R^{65}$  としては、例えばメチレン基、あるいは  $R^{66}$  と同様なもの、 $R^{66}$  としては例えば水素原子、メチル基、エチル基、ブチル基、プロピル基、エチニル基、シクロヘキシル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニル基、ナフチル基等が挙げられる。

【0154】ここで、溶解制御剤の酸不安定基としては、上記一般式 (5)、一般式 (6) で示される基、 $t$  er  $t$ -アルキル基、トリアルキルシリル基、 $\beta$ -ケトアルキル基等が挙げられる。

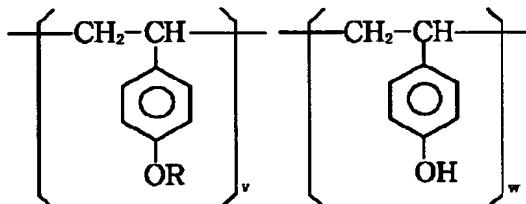
【0155】上記フェノール性水酸基を酸不安定基で部分置換した化合物（溶解制御剤）の配合量は、ベース樹脂 100 部に対し、0～50 部、好ましくは 5～50 部、より好ましくは 10～30 部であり、単独又は 2 種以上を混合して使用できる。配合量が 5 部に満たないと解像性の向上がない場合があり、50 部を超えるとバタ

50

ーンの膜減りが生じ、解像度が低下する場合がある。

【0156】なお、上記のような溶解制御剤はフェノール性水酸基を有する化合物にベース樹脂と同様に酸不安定基を化学反応させることにより合成することができる。

【0157】本発明のレジスト材料は、上記溶解制御剤の代わりに又はこれに加えて別の溶解制御剤として重量平均分子量が1,000を超える3,000以下で、かつ分子内にフェノール性水酸基を有する化合物の該フェノール性水酸基の水素原子を酸不安定基により全体として



10

(但し、式中Rは酸不安定基を示し、v、wはそれぞれ $0 \leq v / (v+w) \leq 0.6$ を満足する数である。)

【0160】ここで、上記溶解制御剤の酸不安定基としては、上記一般式(5)で示される基、上記一般式(6)で示される基、tert-アルキル基、トリアルキルシリル基、ケトアルキル基等が挙げられる。

【0161】上記別の溶解制御剤の配合量は、上記溶解制御剤と合計した溶解制御剤全体としてベース樹脂100部に対し0~50部、特に0~30部、好ましくは1部以上用いるような範囲であることが好ましい。

【0162】なお、上記のような別の溶解制御剤は、フェノール性水酸基を有する化合物にベース樹脂と同様に酸不安定基を化学反応させることにより合成することができる。

【0163】(D)成分の塩基性化合物は、酸発生剤より発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を抑制することができる化合物が適しており、このような塩基性化合物の配合により、レジスト膜中の酸の拡散速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度やバターンプロファイル等を向上することができる。

【0164】このような塩基性化合物としては、第1級、第2級、第3級の脂肪族アミン類、混成アミン類、芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキシ基を有する含窒素化合物、スルホニル基を有する含窒素化合物、ヒドロキシ基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられるが、特に脂肪族アミンが好適に用いられる。

【0165】具体的には、第1級の脂肪族アミン類として、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、n-ブロピルアミン、iso-ブロピルアミン、n-ブチルアミン、iso-ブチルアミン、sec-ブチルアミン、tert-ブチルアミン、ペンチルアミン、

平均0%以上60%以下の割合で部分置換した化合物を配合することができる。

【0158】この場合、かかる酸不安定基でフェノール性水酸基の水素原子が部分置換された化合物としては、下記一般式(11)で示される繰り返し単位を有し、重量平均分子量が1,000を超える3,000以下である化合物から選ばれる1種又は2種以上の化合物が好ましい。

【0159】

【化50】

(11)

アミルアミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチルアミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、テトラエチレンペントミン等が例示され、第2級の脂肪族アミン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジ-n-ブロピルアミン、ジ-isoo-ブロピルアミン、ジ-n-ブチルアミン、ジ-isoo-ブチルアミン、ジ-sec-ブチルアミン、ジペンチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘプチルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N,N-ジメチルメチレンジアミン、N,N-ジメチルエチレンジアミン、N,N-ジメチルテトラエチレンペントミン等が例示され、第3級の脂肪族アミン類として、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリ-n-ブロピルアミン、トリ-isoo-ブロピルアミン、トリ-n-ブチルアミン、トリ-isoo-ブチルアミン、トリ-sec-ブチルアミン、トリペンチルアミン、トリシクロヘキシルアミン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリノニルアミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミン、トリセチルアミン、N,N,N',N'-テトラメチルメチレンジアミン、N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン、N,N,N',N'-テトラメチルテトラエチレンペントミン等が例示される。

【0166】また、混成アミン類としては、例えばジメチルエチルアミン、メチルエチルブロピルアミン、ベンジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルアミン等が例示される。芳香族、複素環アミン類の具体例としては、アニリン誘導体(例えばアニリン、N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-ブロピルアニリン、N,N,N-ジメチルアニリン、2-メチルアニリン、

3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、エチルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルアニリン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニトロアニリン、2, 4-ジニトロアニリン、2, 6-ジニトロアニリン、3, 5-ジニトロアニリン、N, N-ジメチルトルイジン等)、ジフェニル(p-トリル)アミン、メチルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、フェニレンジアミン、ナフチルアミン、ジアミノナフタレン、ピロール誘導体(例えばピロール、2H-ピロール、1-メチルピロール、2, 4-ジメチルピロール、2, 5-ジメチルピロール、N-メチルピロール等)、オキサゾール誘導体(例えばオキサゾール、イソオキサゾール等)、チアゾール誘導体(例えばチアゾール、イソチアゾール等)、イミダゾール誘導体(例えばイミダゾール、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール等)、ピラゾール誘導体、フラザン誘導体、ピロリン誘導体(例えばピロリン、2-メチル-1-ピロリン等)、ピロリジン誘導体(例えばピロリジン、N-メチルピロリジン、ピロリジノン、N-メチルピロリドン等)、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジン誘導体、ピリジン誘導体(例えばピリジン、メチルピリジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピリジン、4-(1-ブチルベンチル)ピリジン、ジメチルピリジン、トリメチルピリジン、トリエチルピリジン、フェニルピリジン、3-メチル-2-フェニルピリジン、4-tert-ブチルピリジン、ジフェニルピリジン、ベンジルピリジン、メトキシピリジン、ブトキシピリジン、ジメトキシピリジン、1-メチル-2-ピリドン、4-ピロリジニピリジン、1-メチル-4-フェニルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、アミノピリジン、ジメチルアミノピリジン等)、ピリダジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導体、ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール誘導体、イソインドール誘導体、1H-インダゾール誘導体、インドリン誘導体、キノリン誘導体(例えばキノリン、3-キノリンカルボニトリル等)、イソキノリン誘導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキサン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、ブテリジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン誘導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1, 10-フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノシン誘導体、グアニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラシル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

【0167】更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物としては、例えばアミノ安息香酸、インドールカルボン酸、アミノ酸誘導体(例えばニコチン酸、アラニン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジ

10

20

30

40

50

ン、3-アミノピラジン-2-カルボン酸、メトキシアラニン)等が例示され、スルホニル基を有する含窒素化合物として3-ビリジンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸ビリジニウム等が例示され、ヒドロキシ基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素化合物として、2-ヒドロキシピリジン、アミノクレゾール、2, 4-キノリンジオール、3-インドールメタノールヒドレート、トリエタノールアミン、N-エチルジエタノールアミン、N, N-ジエチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、2, 2'-イミノジエタノール、2-アミノエタノール、3-アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1-ブタノール、4-(2-ヒドロキシエチル)モルホリン、2-(2-ヒドロキシエチル)ピリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、1-[2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル]ピペラジン、ピペリジンエタノール、1-(2-ヒドロキシエチル)ピロリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジン、3-ピペリジノ-1, 2-プロパンジオール、3-ピロリジノ-1, 2-プロパンジオール、8-ヒドロキシユロリジン、3-クイヌクリジノール、3-トロパノール、1-メチル-2-ピロリジンエタノール、1-アジリジンエタノール、N-(2-ヒドロキシエチル)フタルイミド、N-(2-ヒドロキシエチル)イソニコチニアミド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズアミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタルイミド、サクシンイミド、マレイイミド等が例示される。特にトリエチルアミン、N, N-ジメチルアニリン、N-メチルピロリドン、ピリジン、キノリン、ニコチン酸、トリエタノールアミン、ピペリジンエタノール、N, N-ジメチルアセトアミド、サクシンイミド等が好ましい。

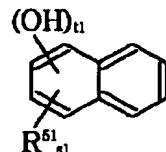
【0168】なお、上記塩基性化合物は1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができ、その配合量はベース樹脂100部に対して0.01~2部、特に0.01~1部を混合したものが好適である。配合量が0.01部より少ないと配合効果がなく、2部を超えると感度が低下しすぎる場合がある。

【0169】更に、本発明のレジスト材料に、(E)成分として配合される分子内に $\equiv C-COOH$ で示される基を有する芳香族化合物は、例えば下記I群及びII群から選ばれる1種又は2種以上の化合物を使用することができるが、これらに限定されるものではない。(E)成分の配合により、レジストのPED安定性を向上させ、塗化膜基板上でのエッジラフネスを改善することができる。

【I群】下記一般式(12)~(21)で示される化合

物のフェノール性水酸基の水素原子の一部又は全部を $-R^{57}-COOH$  ( $R^{57}$ は炭素数1~10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基)により置換してなり、かつ分子中のフェノール性水酸基Cと $\equiv C-COOH$ で示される基Dとのモル比率为 $C/(C+D) = 0.1 \sim 1.0$ である

[ I 群]



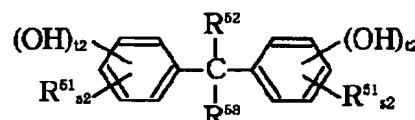
る化合物。

[ I I 群] 下記一般式(22)~(23)で示される化合物。

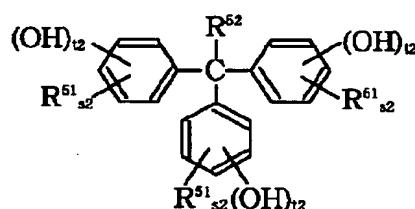
[0170]

[化51]

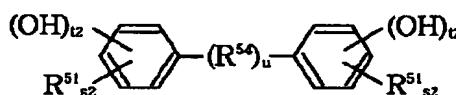
(12)



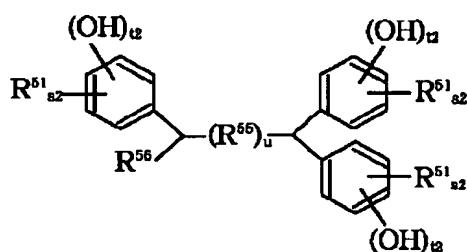
(13)



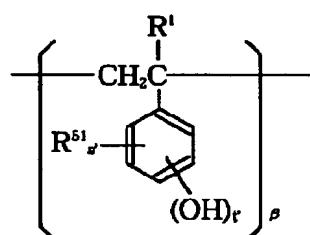
(14)



(15)



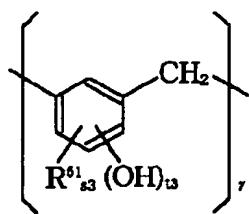
(16)



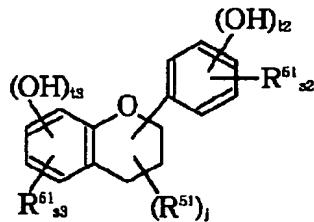
(17)

[0171]

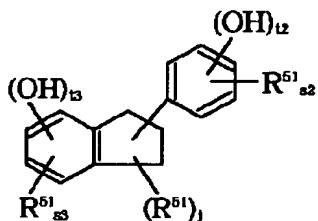
[化52]



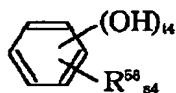
(18)



(19)



(20)



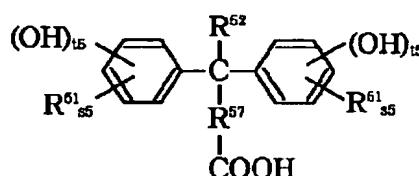
(21)

(但し、式中 R<sup>1</sup> は水素原子又はメチル基であり、  
 R<sup>51</sup>、R<sup>51'</sup> はそれぞれ水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖  
 状又は分歧状のアルキル基又はアルケニル基であり、R  
<sup>13</sup> は水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分歧状の  
 アルキル基又はアルケニル基、或いは -(R<sup>51</sup>)<sub>2</sub>-CO  
 OR' 基 (R' は水素原子又は -R<sup>51</sup>-COOH) であ  
 り、R<sup>64</sup> は -(CH<sub>2</sub>)<sub>i</sub> (i = 2～10)、炭素数 6  
 ～10 のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、  
 酸素原子又は硫黄原子、R<sup>65</sup> は炭素数 1～10 のアルキ  
 レン基、炭素数 6～10 のアリーレン基、カルボニル  
 基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子、R<sup>66</sup> は水素  
 原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分歧状のアルキ  
 基、アルケニル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニ  
 ル基又はナフチル基であり、R<sup>67</sup> は炭素数 1～10 の直  
 [I I 群]

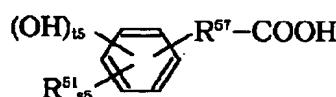
鎖状又は分歧状のアルキレン基、R<sup>68</sup> は水素原子又は炭  
 素数 1～8 の直鎖状又は分歧状のアルキル基又はアルケ  
 ニル基又は -R<sup>67</sup>-COOH 基である。j は 0～5 の整  
 数であり、h は 0 又は 1 である。s 1、t 1、s 2、t  
 2、s 3、t 3、s 4、t 4 はそれぞれ s 1 + t 1 =  
 8、s 2 + t 2 = 5、s 3 + t 3 = 4、s 4 + t 4 = 6  
 を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくとも 1 つの水  
 酸基を有するような数である。β は式 (17) の化合物  
 を重量平均分子量 1,000～5,000 とする数、γ は式  
 (18) の化合物を重量平均分子量 1,000～1  
 0,000 とする数である。)

【0172】

【化53】



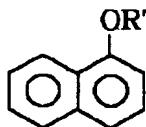
(22)



(23)

(R<sup>61</sup>、R<sup>62</sup>、R<sup>63</sup>上記と同様の意味を示す。s 5、t 5は、s 5 ≥ 0、t 5 ≥ 0で、s 5 + t 5 = 5を満足する数である。)

【0173】上記(E)成分として、具体的には下記一般式XIII-1~14及びIX-1~6で示される化

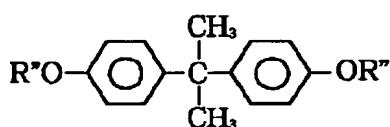


合物を挙げることができが、これらに限定されるものではない。

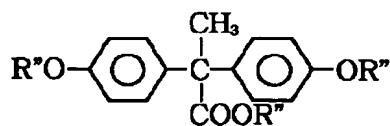
【0174】

【化54】

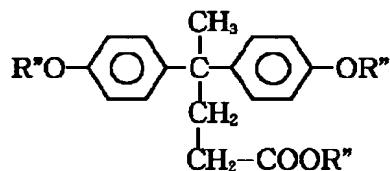
【VII-1】



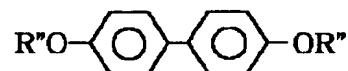
【VII-2】



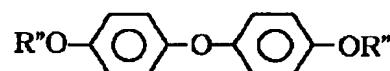
【VII-3】



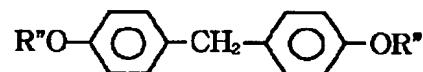
【VII-4】



【VII-5】



【VII-6】

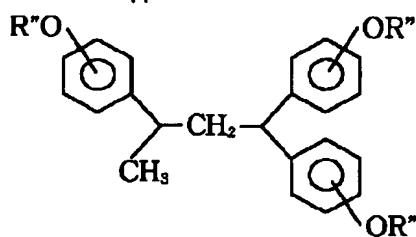


【VII-7】

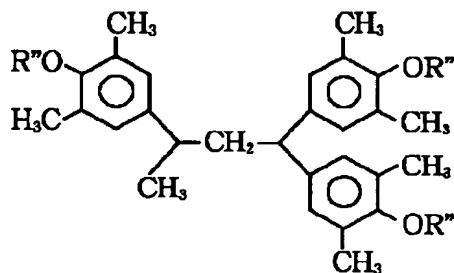
【0175】

【化55】

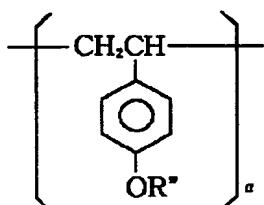
77



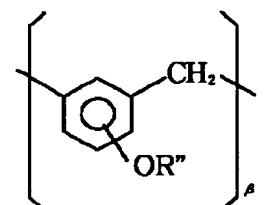
(VIII-8)



(VIII-9)



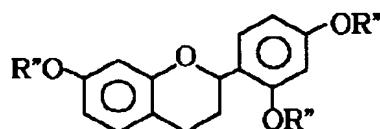
(VIII-10)



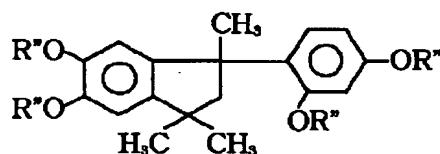
(VIII-11)

【0176】

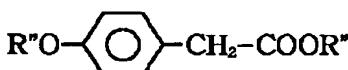
【化56】



(VIII-12)



(VIII-13)



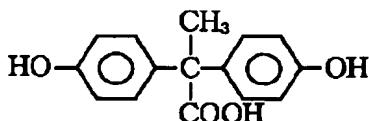
(VIII-14)

(但し、R''は水素原子又はCH<sub>3</sub>COOH基を示し、各化合物においてR''の10~100モル%はCH<sub>3</sub>COOH基である。)

【0177】

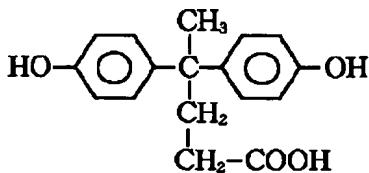
【化57】

79

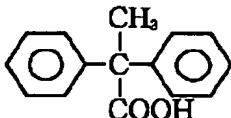


80

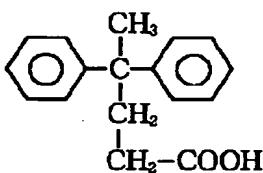
[IX-1]



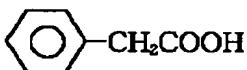
[IX-2]



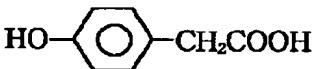
[IX-3]



[IX-4]



[IX-5]



[IX-6]

【0178】なお、上記分子内に≡C-COOHで示される基を有する芳香族化合物は、1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0179】上記分子内に≡C-COOHで示される基を有する芳香族化合物の添加量は、ベース樹脂100部に対して0.1~5部、より好ましくは1~3部である。0.1部より少ないと窒化膜基板上での裾引き及びPEDの改善効果が十分に得られない場合があり、5部より多いとレジスト材料の解像性が低下する場合がある。

【0180】更に、本発明のレジスト材料には、(H)成分の紫外線吸収剤として波長248nmでのモル吸光率が10,000以下の化合物を配合することができる。これによって、反射率の異なる基板に対し、適切な透過率を有するレジストの設計・制御が可能となる。

【0181】具体的には、ペンタレン、インデン、ナフタレン、アズレン、ペブタレン、ビフェニレン、インダン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、アセフェナントリレン、アセアントリレン、トリフェニレン、ビレン、クリセン、

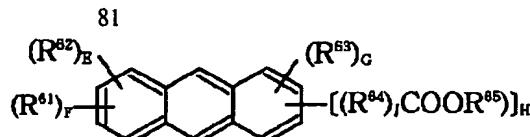
30

ナフタレン、ブレイアデン、ピセン、ペリレン、ペンタフェン、ペンタセン、ベンゾフェナントレン、アントラキノン、アントロンベンズアントロン、2,7-ジメトキシナフタレン、2-エチル-9,10-ジメトキシアントセラン、9,10-ジメチルアントラセン、9-エトキシアントラセン、1,2-ナフトキノン、9-フルオレン、下記一般式(24)、(25)等の縮合多環炭化水素誘導体、チオキサンテン-9-オン、チアントレン、ジベンゾチオフェン等の縮合複素環誘導体、2,3,4-トリビトロキシベンゾフェノン、2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、3,5-ジヒドロキシベンゾフェノン、4,4'-ジヒドロキシベンゾフェノン、4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン等のベンゾフェノン誘導体、スクエアリックアシッド、ジメチルスクエアレート等のスクエアリックアシッド誘導体等が挙げられる。

【0182】

【化58】

40



82

(24)



(25)

(式中、R<sup>61</sup>～R<sup>63</sup>はそれぞれ独立に水素原子、直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシ基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルケニル基又はアリール基である。R<sup>64</sup>は酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂肪族炭化水素基、酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂環式炭化水素基、酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の芳香族炭化水素基又は酸素原子であり、R<sup>65</sup>は酸不安定基である。Jは0又は1である。E、F、Gはそれぞれ0又は1～9の整数、Hは1～10の正の整数で、かつE+F+G+H≤10を満足する。)

【0183】更に詳しくは、上記式(24)、(25)において、R<sup>61</sup>～R<sup>63</sup>はそれぞれ独立に水素原子、直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシ基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルケニル基又はアリール基であり、直鎖状又は分岐状のアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、アダマンチル基等の炭素数1～10のものが好適であり、中でもメチル基、エチル基、イソプロピル基、tert-ブチル基がより好ましく用いられる。直鎖状又は分岐状のアルコキシ基としては、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、ヘキシロキシ基、シクロヘキシロキシ基等の炭素数1～8のものが好適であり、中でもメトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、tert-ブトキシ基がより好ましく用いられる。直鎖状又は分岐状のアルコキシアルキル基としては、例えばメトキシメチル基、エトキシプロピル基、プロポキシエチル基、tert-ブトキシエチル基等の炭素数2～10のものが好適であり、中でもメトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシプロピル基、プロポキシエチル基等が好ましい。直鎖状又は分岐状のアルケニル基としては、ビニル基、プロペニル基、アリル基、ブチニル基のような炭素数2～4のものが好適である。アリール基としては、フェニル基、キシリル基、

トルイル基、クメニル基のような炭素数6～14のものが好適である。

【0184】R<sup>64</sup>は酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂肪族炭化水素基、酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂環式炭化水素基、酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の芳香族炭化水素基又は酸素原子である。なお、式中のJは0又は1であり、Jが0の場合は-R<sup>64</sup>-結合部は単結合となる。

【0185】酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂肪族炭化水素基としては、例えばメチレン基、エチレン基、n-プロピレン基、イソプロピレン基、n-ブチレン基、sec-ブチレン基、-CH<sub>2</sub>-O-基、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O-基、-CH<sub>2</sub>OCH<sub>2</sub>-基のような炭素数1～10のものが好適であり、中でもメチレン基、エチレン基、-CH<sub>2</sub>O-基、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O-基がより好ましく用いられる。

【0186】酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の脂環式炭化水素基としては、例えば1,4-シクロヘキシレン基、2-オキサシクロヘキサン-1,4-イレン基、2-チアシクロヘキサン-1,4-イレン基のような炭素数5～10のものが挙げられる。

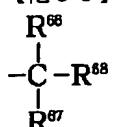
【0187】酸素原子を含んでいてもよい置換もしくは非置換の2価の芳香族炭化水素基としては、例えばO-フェニレン基、p-フェニレン基、1,2-キシレン-3,6-イレン基、トルエン-2,5-イレン基、1-クメン-2,5-イレン基のような炭素数6～14のもの、あるいは-CH<sub>2</sub>Ph-基、-CH<sub>2</sub>PhCH<sub>2</sub>-基、-OCH<sub>2</sub>Ph-基、-OCH<sub>2</sub>PhCH<sub>2</sub>O-基

(Phはフェニレン基)等の炭素数6～14のアリルアルキレン基が挙げられる。

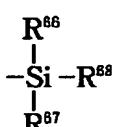
【0188】また、R<sup>65</sup>は酸不安定基であるが、ここでいう酸不安定基とはカルボキシル基を酸の存在下で分解し得る1種以上の官能基で置換したものを意味し、酸の存在下に分解してアルカリ可溶性を示す官能基を遊離するものである限り特に限定されるものではないが、特に下記一般式(26a)、(26b)、(26c)で示される基が好ましい。

50 【0189】

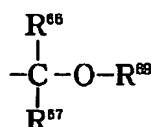
【化59】



(26a)



(26b)



(26c)

(式中、 $R^{66} \sim R^{68}$  はそれぞれ独立に水素原子、直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシ基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルケニル基又はアリール基であり、かつ、これらの基は鎖中にカルボニル基を含んでいてもよいが、 $R^{66} \sim R^{68}$  の全てが水素原子であってはならない。また、 $R^{66}$  と  $R^{67}$  は互いに結合して環を形成してもよい。 $R^{66}$  は直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状もしくは分岐状のアルケニル基又はアリール基であり、かつ、これらの基は鎖中にカルボニル基を含んでいてもよい。また、 $R^{66}$  は  $R^{67}$  と結合して環を形成してもよい。)

【0190】この場合、上記直鎖状又は分岐状のアルキル基、直鎖状又は分岐状のアルコキシ基、直鎖状又は分岐状のアルコキシアルキル基、直鎖状又は分岐状のアルケニル基、アリール基としては、上記  $R^{61} \sim R^{63}$  と同様のものを例示することができる。

【0191】また、式 (26a) において  $R^{66}$  と  $R^{67}$  が互いに結合して形成される環としては、例えばシクロヘキシリデン基、シクロペンチリデン基、3-オキソシクロヘキシリデン基、3-オキソ-4-オキサシクロヘキシリデン基、4-メチルシクロヘキシリデン基等の炭素数4～10のものが挙げられる。

【0192】また、式 (26b) において  $R^{66}$  と  $R^{67}$  が互いに結合して形成される環としては、例えば1-シラシクロヘキシリデン基、1-シラシクロペンチリデン基、3-オキソ-1-シラシクロペンチリデン基、4-メチル-1-シラシクロペンチリデン基等の炭素数3～9のものが挙げられる。

【0193】更に、式 (26c) において  $R^{66}$  と  $R^{67}$  が互いに結合して形成される環としては、例えば2-オキサシクロヘキシリデン基、2-オキサシクロペンチリデ

ン基、2-オキサ-4-メチルシクロヘキシリデン基等の炭素数4～10のものが挙げられる。

【0194】ここで、上記式 (26a) で表わされる基としては、例えば *t e r t*-アミル基、1, 1-ジメチルエチル基、1, 1-ジメチルブチル基、1-エチル-1-メチルプロピル基、1, 1-ジエチルプロピル基等の炭素数4～10の第三級アルキル基のほか、1, 1-ジメチル-3-オキソブチル基、3-オキソシクロヘキシリ基、1-メチル-3-オキソ-4-オキサシクロヘキシリ基などの3-オキソアルキル基が好適である。

【0195】上記式 (26b) で表わされる基としては、例えばトリメチルシリル基、エチルジメチルシリル基、ジメチルプロピルシリル基、ジエチルメチルシリル基、トリエチルシリル基等の炭素数3～10のトリアルキルシリル基が好適である。

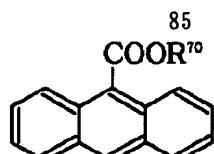
【0196】上記式 (26c) で表わされる基としては、例えば1-メトキシメチル基、1-メトキシエチル基、1-エトキシエチル基、1-エトキシプロピル基、1-エトキシソブチル基、1-n-プロポキシエチル基、1-*t e r t*-ブトキシエチル基、1-n-ブトキシエチル基、1-*i s o*-ブトキシエチル基、1-*t e r t*-ペントキシエチル基、1-シクロヘキシリオキシエチル基、1-(2'-n-ブトキシエトキシ)エチル基、1-(2'-エチルヘキシリ)オキシエチル基、1-(4'-アセトキシメチルシクロヘキシリメチルオキシ)エチル基、1-(4'-(*t e r t*-ブトキシカルボニルオキシメチル)シクロヘキシリメチルオキシ)エチル基、2-メトキシ-2-プロピル基、1-エトキシプロピル基、ジメトキシメチル基、ジエトキシメチル基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基等の炭素数2～8のものが好適である。

【0197】なお、上記式 (24)、(25) において、E、F、Gはそれぞれ0又は1～9の正の整数、Hは1～10の正の整数で、 $E+F+G+H \leq 10$  を満足する。

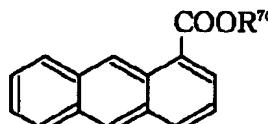
【0198】上記式 (24)、(25) の化合物の好ましい具体例としては、下記 (27a)～(27j) で示される化合物等が挙げられる。

【0199】

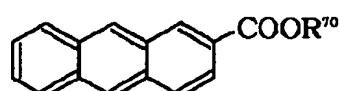
【化60】



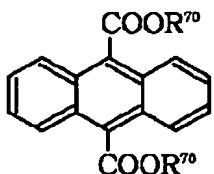
(27a)



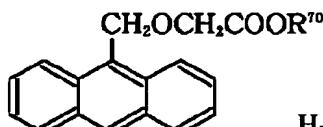
(27b)



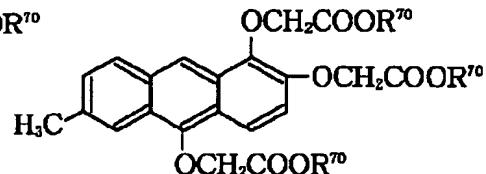
(27c)



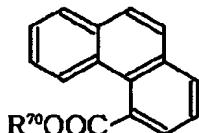
(27d)



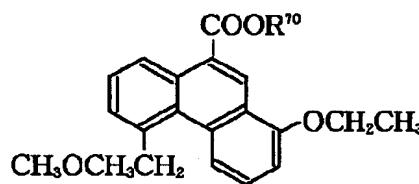
(27e)



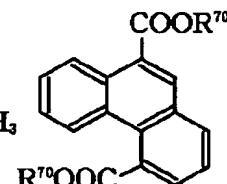
(27f)



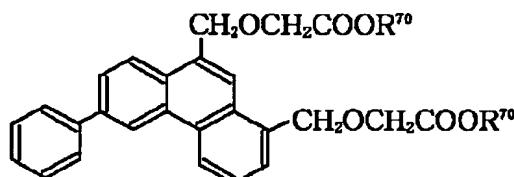
(27g)



(27h)



(27i)



(27j)

(式中、R<sup>70</sup>は酸不安定基である。)

【0200】また、紫外線吸収剤としては、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホキシド、ビス(4-tert-ブトキシフェニル)スルホキシド、ビス(4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル)スルホキシド、ビス[4-(1-エトキシエトキシ)フェニル]スルホキシド等のジアリールスルホキシド誘導体、ビス(4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビス(4-tert-ブトキシフェニル)スルホン、ビス(4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル)スルホン、ビス[4-(1-エトキシエトキシ)フェニル]スルホン、ビス[4-(1-エトキシプロポキシ)フェニル]スルホン等のジアリールスルホン誘導体、ベンゾキノンジアジド、ナフトキノンジアジド、アントラキノンジアジド、ジアゾフルオレン、ジアゾテトラロン、ジアゾフェナントロン等のジアゾ化合物、ナフトキノン-1, 2

40

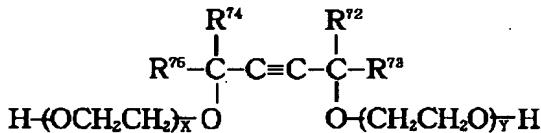
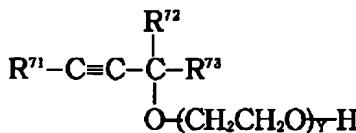
ジアジド-5-スルホン酸クロリドと2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノンとの完全もしくは部分エステル化合物、ナフトキノン-1, 2-ジアジド-4-スルホン酸クロリドと2, 4, 4'-トリヒドロキシベンゾフェノンとの完全もしくは部分エステル化合物等のキノンジアジド基含有化合物等を用いることもできる。

【0201】紫外線吸収剤として好ましくは、9-アントラセンカルボン酸tert-ブチル、9-アントラセンカルボン酸tert-アミル、9-アントラセンカルボン酸tert-メトキシメチル、9-アントラセンカルボン酸tert-エトキシエチル、9-アントラセンカルボン酸tert-テトラヒドロピラニル、9-アントラセンカルボン酸tert-テトラヒドロフラニル、ナフトキノン-1, 2-ジアジド-5-スルホン酸クロリドと2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノンとの部分エステル化合物等を挙げることができる。

50

【0202】上記(H)成分の紫外線吸収剤の配合量は、ベース樹脂100部に対して0~10部、より好ましくは0.5~10部、更に好ましくは1~5部であることが好ましい。

【0203】更に、本発明のレジスト材料には、(I)成分としてアセチレンアルコール誘導体を配合することができ、これにより保存安定性を向上させることができ



(式中、R<sup>71</sup>、R<sup>72</sup>、R<sup>73</sup>、R<sup>74</sup>、R<sup>75</sup>はそれぞれ水素原子、又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基であり、X、Yは0又は正数を示し、下記値を満足する。0≤X≤30、0≤Y≤30、0≤X+Y≤40である。)

【0206】アセチレンアルコール誘導体として好ましくは、サーフィノール61、サーフィノール82、サーフィノール104、サーフィノール104E、サーフィノール104H、サーフィノール104A、サーフィノールTG、サーフィノールPC、サーフィノール440、サーフィノール465、サーフィノール485(Air Products and Chemicals Inc. 製)等が挙げられる。サーフィノール(Surfynol)はメーカーである米国のAir Products and Chemicals Inc. の商標である。

【0207】上記アセチレンアルコール誘導体の添加量は、レジスト組成物100重量%中0.01~2重量%、より好ましくは0.02~1重量%である。0.01重量%より少ないと塗布性及び保存安定性の改善効果が十分に得られない場合があり、2重量%より多いとレジスト材料の解像性が低下する場合がある。

【0208】本発明のレジスト材料には、上記成分以外に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されている界面活性剤を添加することができる。なお、任意成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができます。

【0209】ここで、界面活性剤としては非イオン性のものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチレンエタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフルオロアルキルアミンオキサイド、含フッ素オルガノシリコン系化合物等が挙げられる。例えばフローラード「FC-430」、「FC-431」(いずれも住友スリー

る。

【0204】アセチレンアルコール誘導体としては、下記一般式(28)、(29)で示されるものを好適に使用することができる。

【0205】

【化61】

(28)

(29)

エム(株)製)、サーフロン「S-141」、「S-145」(いずれも旭硝子(株)製)、ユニダイン「DS-401」、「DS-403」、「DS-451」(いずれもダイキン工業(株)製)、メガファック「F-8151」(大日本インキ工業(株)製)、「X-70-092」、「X-70-093」(いずれも信越化学工業(株)製)等を挙げることができる。好ましくは、フローラード「FC-430」(住友スリー・エム(株)製)、「X-70-093」(信越化学工業(株)製)が挙げられる。

【0210】本発明の化学增幅ポジ型レジスト材料を使用してパターンを形成するには、公知のリソグラフィー技術を採用して行うことができ、例えばシリコンウェハ等の基板上にスピンドルティング等の手法で膜厚が0.5~2.0 μmとなるように塗布し、これをホットプレート上で60~150°C、1~10分間、好ましくは80~120°C、1~5分間プリベークする。次いで目的のパターンを形成するためのマスクを上記のレジスト膜上にかざし、波長300nm以下の遠紫外線、エキシマレーザー、X線等の高エネルギー線もしくは電子線を露光量1~200mJ/cm<sup>2</sup>程度、好ましくは10~100mJ/cm<sup>2</sup>程度となるように照射した後、ホットプレート上で60~150°C、1~5分間、好ましくは80~120°C、1~3分間ポストエクスposure(PEB)する。更に、0.1~5%、好ましくは2~3%テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド(TMAH)等のアルカリ水溶液の現像液を用い、0.1~3分間、好ましくは0.5~2分間、浸漬(dip)法、パドル(paddle)法、スプレー(spray)法等の常法により現像することにより基板上に目的のパターンが形成される。なお、本発明材料は、特に高エネルギー線の中でも254~193nmの遠紫外線又はエキシマレーザー、X線及び電子線による微細バ

ターンニングに最適である。また、上記範囲を上限及び下限から外れる場合は、目的のパターンを得ることができない場合がある。

【0211】

【発明の効果】本発明の化学增幅ポジ型レジスト材料は、高エネルギー線に感応し、感度、解像性、プラズマエッティング耐性に優れ、しかもレジストパターンの耐熱性、再現性にも優れている。また、パターンがオーバーハング状になりにくく、寸法制御性に優れている。更に、アセチレンアルコール誘導体の配合により保存安定性が向上する。従って、本発明の化学增幅ポジ型レジスト材料は、これらの特性より、特にK r Fエキシマレーザーの露光波長での吸収が小さいレジスト材料となり得るもので、微細でしかも基板に対して垂直なパターンを容易に形成でき、このため超LSI製造用の微細パターン形成材料として好適である。

【0212】

【実施例】以下、合成例、実施例及び比較例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記例に制限されるものではない。

【0213】【合成例1】2Lのフラスコにポリヒドロキシスチレン100gをジメチルホルムアミド1,000mLに溶解させ、触媒量のp-トルエンスルホン酸を添加した後、20℃で攪拌しながらエチルビニルエーテル30g、トリエチレングリコールジビニルエーテル2gを添加した。1時間反応させた後に、濃アンモニア水により中和し、水10Lに中和反応液を滴下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、アセトン500mLに溶解させ、水10Lに滴下し、濾過後、真空乾燥した。得られたポリマーは、<sup>1</sup>H-NMRからポリヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子が27%エトキシエチル化され、3%が架橋されたことが確認された(Po1ym. 1)。

【0214】【合成例2】2Lのフラスコにポリヒドロキシスチレン100gをジメチルホルムアミド1,000mLに溶解させ、触媒量のp-トルエンスルホン酸を添加した後、20℃で攪拌しながらエチルビニルエーテル30g、1,4-ジ(ビニルエーテル)シクロヘキサン2gを添加した。1時間反応させた後に、濃アンモニア水により中和し、水10Lに中和反応液を滴下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、アセトン500mLに溶解させ、水10Lに滴下し、濾過後、真空乾燥した。得られたポリマーは、<sup>1</sup>H-NMRからポリヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子が27%エトキシエチル化され、3%が架橋されたことが確認された。

【0215】更に、得られた部分架橋化されたエトキシエトキシ化ポリヒドロキシスチレン50gをビリジン500mLに溶解させ、45℃で攪拌しながら二炭酸ジtert-ブチル7gを添加した。1時間反応させた後、水3Lに反応液を滴下したところ、白色固体が得ら

れた。これを濾過後、アセトン500mLに溶解させ、水2Lに滴下し、濾過後、真空乾燥させ、ポリマーを得た。得られたポリマーは下記示性式(Po1ym. 2)で示される構造を有し、<sup>1</sup>H-NMRからポリヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子のエトキシエチル化率は27%、水酸基の水素原子のtert-ブトキシカルボニル化率は8%であった。

【0216】【合成例3】2Lのフラスコにポリヒドロキシスチレン50gをジメチルホルムアミド500mL

10に溶解させ、触媒量のp-トルエンスルホン酸を添加した後、20℃で攪拌しながらエチルビニルエーテル27g、1,4-ジ(ビニルエーテル)シクロヘキサン3gを添加した。1時間反応させた後に、濃アンモニア水により中和し、水10Lに中和反応液を滴下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、アセトン500mLに溶解させ、水10Lに滴下し、濾過後、真空乾燥した。得られたポリマーは、<sup>1</sup>H-NMRからポリヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子が24%エトキシエチル化され、10%が架橋されたことが確認された(Po1ym. 3)。

【0217】【合成例4~7】合成例1~3と同様な方法により下記示性式(Po1ym. 4~7)で示されるポリマーを得た。

【0218】【合成例8】2Lのフラスコにポリヒドロキシスチレン100gをテトラヒドロフラン900gに溶解させ、メタンスルホン酸3.9gを添加した後、30℃で攪拌しながらエチル1-プロペニルエーテル2.8.2gを添加し、3時間反応させた。次いで、1,4-ブタンジオールジビニルエーテル3.8gを添加し、

300.5時間反応させた後、濃アンモニア水により中和した。この反応液を酢酸エチルに溶媒交換し、純水と少量のアセトンを使用し、6回分液精製した後、アセトンに溶媒交換し、20Lの純水に滴下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、純水で2回洗浄、濾過後、真空乾燥した。得られたポリマーは下記示性式(Po1ym. 8)で示される構造を有し、<sup>1</sup>H-NMRからポリヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子が26%エトキシプロポキシ化され、5.5%が架橋されたことが確認された。

40【0219】【合成例9】2Lのフラスコにポリヒドロキシスチレン100gをテトラヒドロフラン900gに溶解させ、メタンスルホン酸3.9gを添加した後、30℃で攪拌しながらエチル1-プロペニルエーテル2.0.0gを添加し、3時間反応させた後、1,4-ブタンジオールジビニルエーテル3.8gを添加した。0.5時間反応させた後に、濃アンモニア水により中和した。この反応液を酢酸エチルに溶媒交換し、純水と少量のアセトンを使用し、6回分液精製した後、アセトンに溶媒交換し、20Lの純水に滴下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、純水で2回洗浄、濾過後、

真空乾燥した。

【0220】更に、得られた部分架橋化されたエトキシプロポキシ化ポリヒドロキシスチレン50gをピリジン300gに溶解させ、40℃で攪拌しながら二炭酸ジ-tert-ブチル4.5gを添加した。1時間反応させた後、水10Lに反応液を滴下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、アセトン200mLに溶解させ、水2Lに滴下し、濾過後、真空乾燥させ、ポリマーを得た。得られたポリマーは下記示性式(Polymer. 9)で示される構造を有し、<sup>1</sup>H-NMRからポリヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子が21%エトキシプロポキシ化され、5%がtert-ブトキシカルボニル化され、5.5%が架橋されたことが確認された。

【0221】〔合成例10〕2Lのフラスコにポリヒドロキシスチレン100gをテトラヒドロフラン900gに溶解させ、メタンスルホン酸3.9gを添加した後、30℃で攪拌しながらエチルビニルエーテル24.0gを添加し、1時間反応させた。次いで、1,4-ブタンジオールジビニルエーテル3.8gを添加し、0.5時間反応させた後、濃アンモニア水により中和した。この反応液を酢酸エチルに溶媒交換し、純水で6回分液精製した後、アセトンに溶媒交換し、20Lの純水に滴下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、純水で2回洗浄、濾過後、真空乾燥した。得られたポリマーは下記示性式(Polymer. 10)で示される構造を有し、<sup>1</sup>H-NMRからポリヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子が18.0%エトキシ化され、5%がtert-ブトキシカルボニル化され、5.5%が架橋されたことが確認された。

【0222】〔合成例11〕2Lのフラスコにポリヒドロキシスチレン100gをテトラヒドロフラン900gに溶解させ、メタンスルホン酸3.9gを添加した後、30℃で攪拌しながらエチルビニルエーテル16.4gを添加し、1時間反応させた。1,4-ブタンジオールジビニルエーテル3.8gを添加し、0.5時間反応させた後、濃アンモニア水により中和した。この反応液を

酢酸エチルに溶媒交換し、純水で6回分液精製した後、アセトンに溶媒交換し、20Lの純水に滴下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、純水で2回洗浄、濾過後、真空乾燥した。

【0223】更に、得られた部分架橋化されたエトキシエトキシ化ポリヒドロキシスチレン50gをピリジン300gに溶解させ、40℃で攪拌しながら二炭酸ジ-tert-ブチル4.5gを添加した。1時間反応させた後、水10Lに反応液を滴下したところ、白色固体が得られた。これを濾過後、アセトン200mLに溶解させ、水2Lに滴下し、濾過後、真空乾燥させ、ポリマーを得た。得られたポリマーは下記示性式(Polymer. 11)で示される構造を有し、<sup>1</sup>H-NMRからポリヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子が18.0%エトキシ化され、5%がtert-ブトキシカルボニル化され、5.5%が架橋されたことが確認された。

【0224】〔合成例12〕エチルビニルエーテルを用いないこと以外は合成例11と同様の方法により下記示性式(Polymer. 12)で示されるポリマーを得た。

【0225】〔合成例13〕ポリ(3,4-ジヒドロキシスチレン)とアルケニルエーテル化合物(I-22)を用いて合成例11と同様の方法により下記示性式(Polymer. 13)で示されるポリマーを得た。

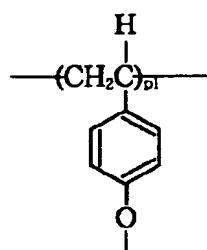
【0226】〔合成例14〕アルケニルエーテル化合物(I-1-1)を用いて合成例9と同様の方法により下記示性式(Polymer. 14)で示されるポリマーを得た。

【0227】得られたポリマーの構造は下記示性式の通りであり、それぞれの置換率は表1に示す通りであった。なお、下記式において、Rは下記単位U<sub>1</sub>又はU<sub>2</sub>を分子間又は分子内架橋している架橋基を示し、(R)は架橋基Rが結合している状態を示す。

【0228】

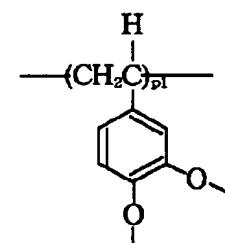
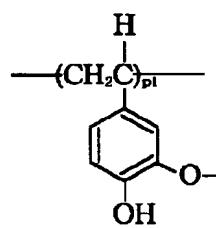
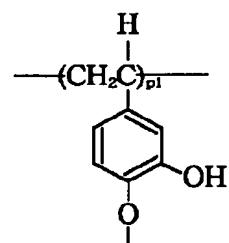
【化62】

93

U<sub>1</sub>

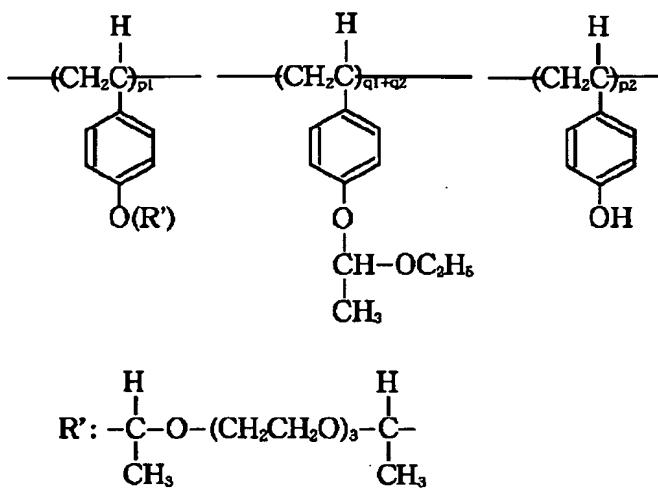
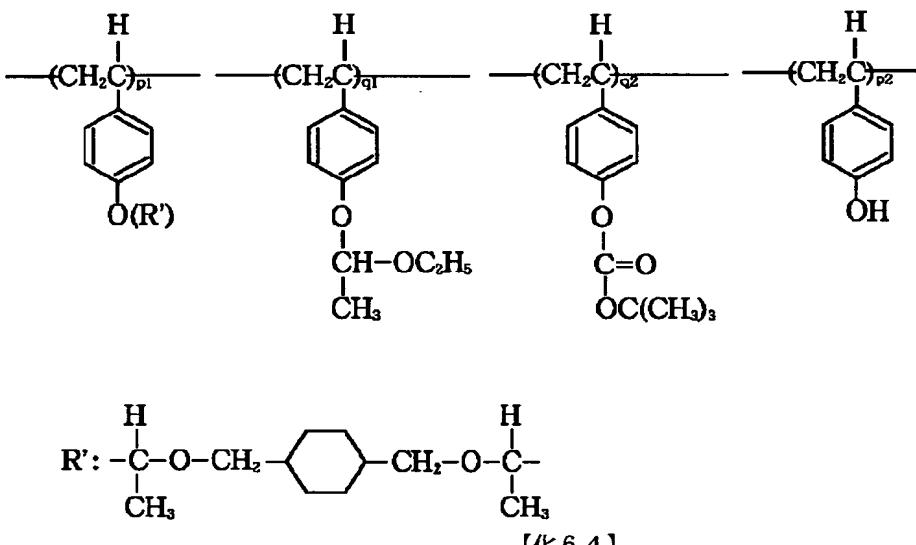
(Polym.1~12)

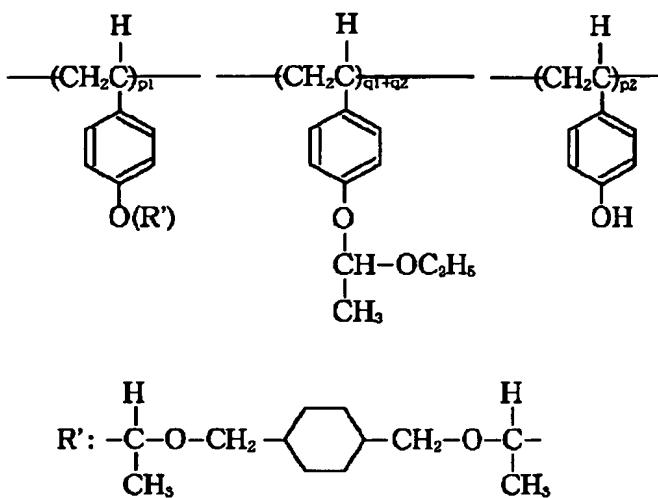
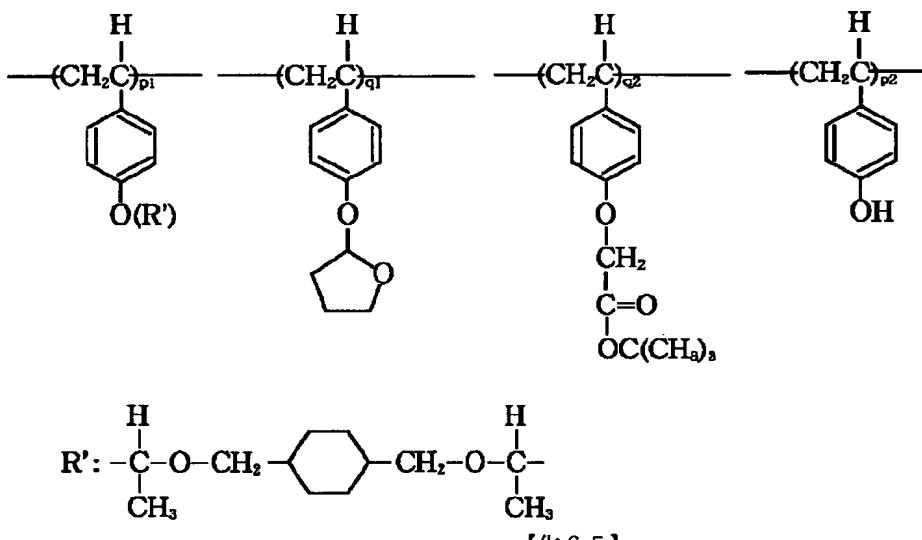
94

U<sub>2</sub>

【0229】

【化63】

Polym.1Polym.2

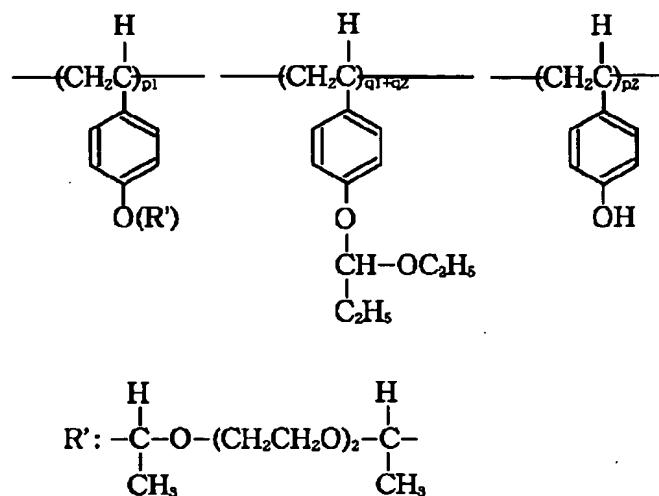
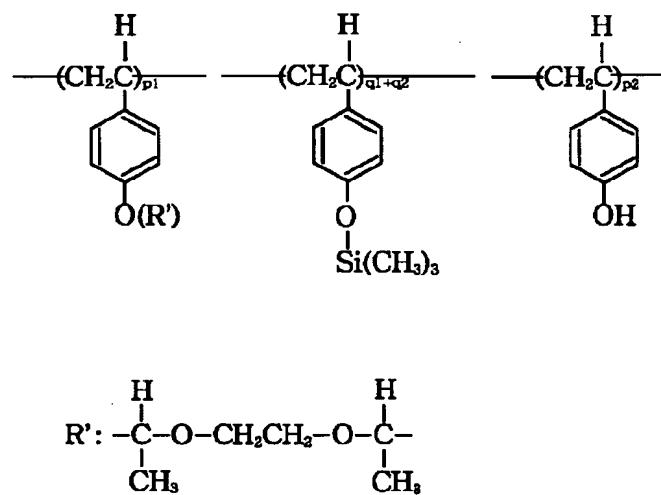
Polym.3Polym.4

【0231】

【化65】

99

100

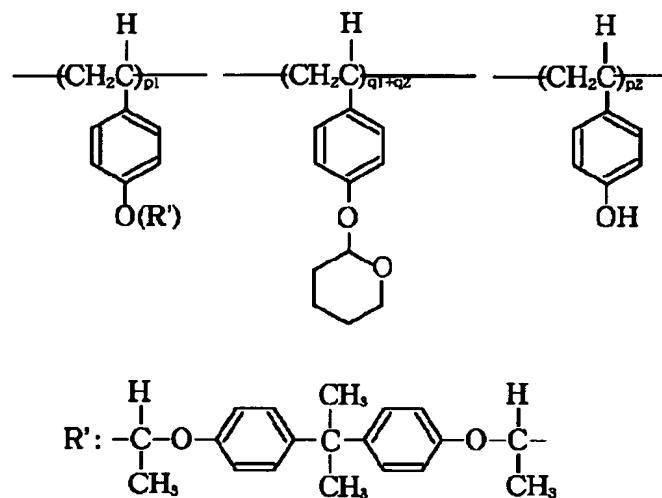
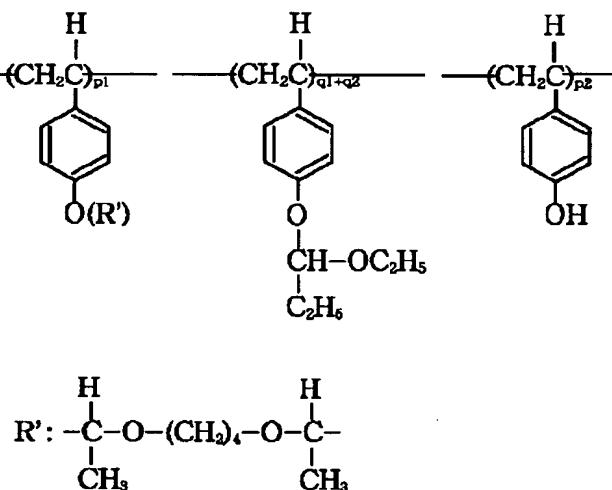
Polym.5Polym.6

【0232】

【化66】

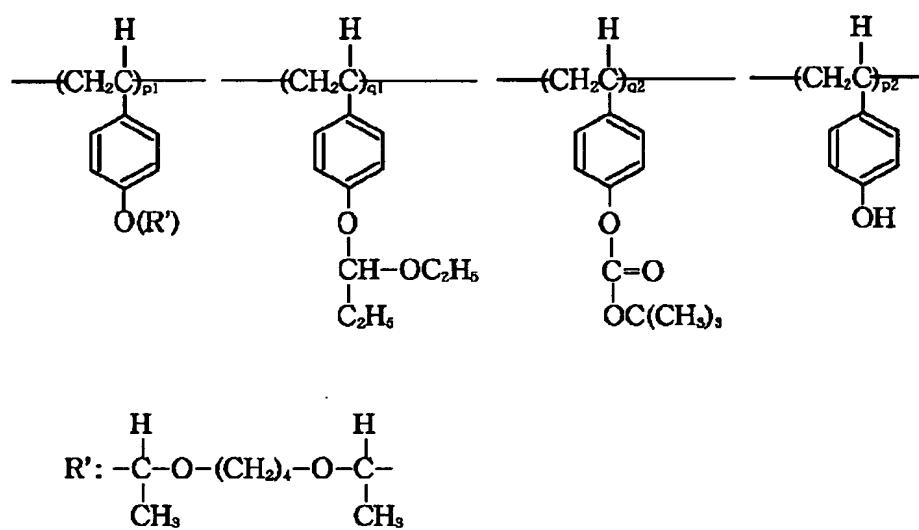
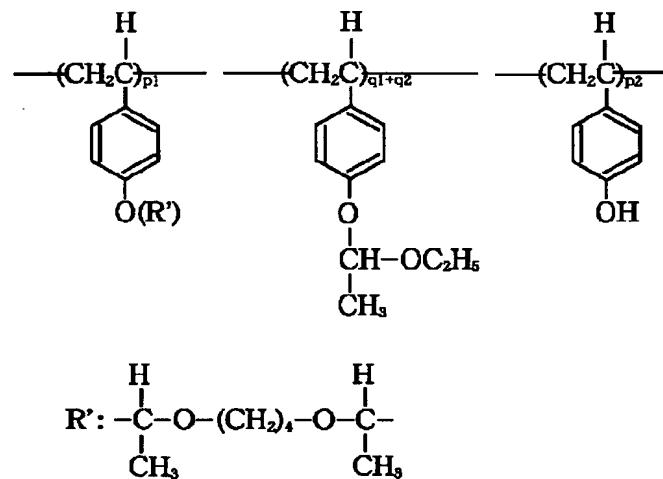
101  
Polym.7

102

Polym.8

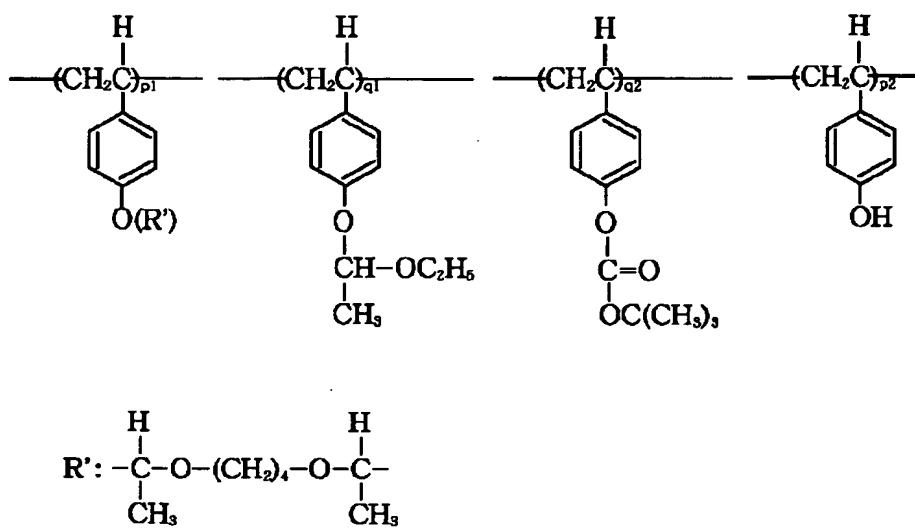
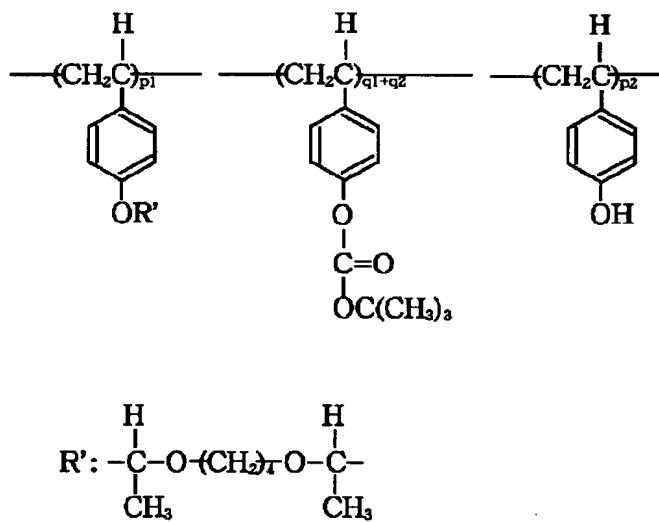
【0233】

【化67】

Polym.9Polym.10

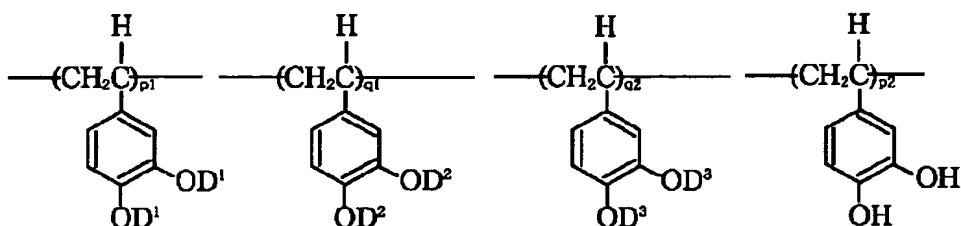
【0 2 3 4】

【化 6 8】

Polym.11Polym.12

【0235】

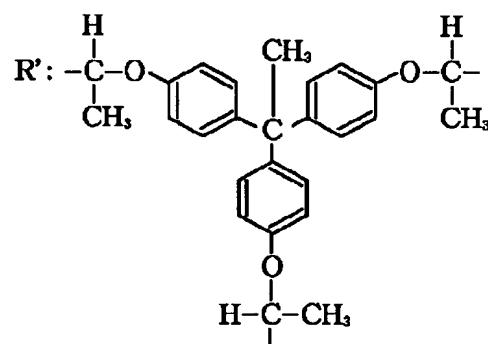
【化69】

Polym.13

$D^1 = H$  又は  $(R')$

$D^2 = H$  又は  $-\underset{C_2H_6}{\underset{|}{\underset{|}{CH}}}-OC_2H_5$

$D^3 = H$  or  $-\underset{O}{\underset{|}{C}}-OC(CH_3)_3$

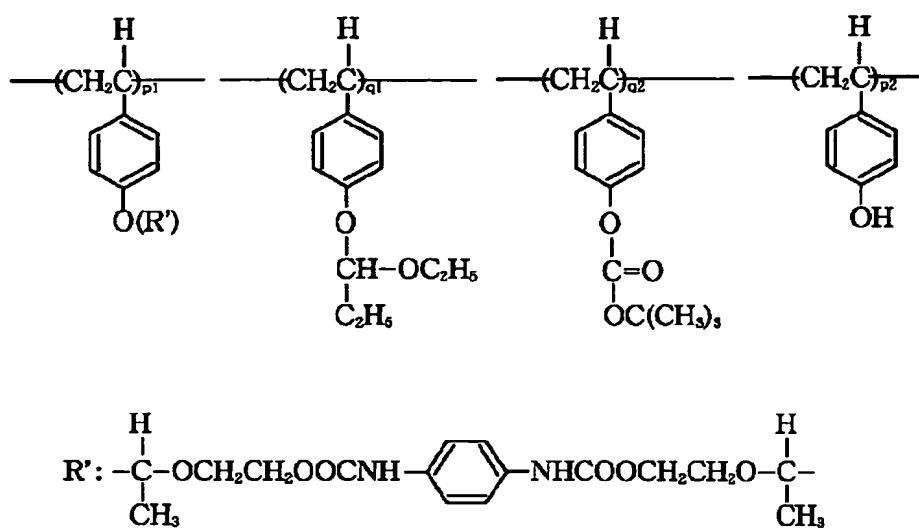


(但し、 $D^1$ の少なくとも1個は $R$ 、 $D^2$ の少なくとも1個は $-\underset{C_2H_6}{\underset{|}{\underset{|}{CH}}}-OC_2H_5$ 、 $D^3$ の少なくとも1個は $-\underset{O}{\underset{|}{C}}-OC(CH_3)_3$ である。)

109

Polym.14

110



【0237】

【表1】

合成例	組成比(モル比)				PHS <sup>*</sup> の Mw	PHS <sup>*</sup> の Mw/Mn	高分子化合物 のMw
	p1	q1	q2	p2			
1 [Polym.1]	3	27		70	11,000	1.05	22,000
2 [Polym.2]	3	27	8	62	11,000	1.05	23,000
3 [Polym.3]	10	24		66	5,000	1.05	12,000
4 [Polym.4]	7	10	5	78	5,000	1.05	12,000
5 [Polym.5]	4	35		61	11,000	1.42	24,000
6 [Polym.6]	7	25		68	13,000	1.15	30,000
7 [Polym.7]	10	20		70	3,000	1.10	8,000
8 [Polym.8]	5.5	26		68.5	11,000	1.05	22,000
9 [Polym.9]	5.5	21	5	68.5	11,000	1.05	24,000
10 [Polym.10]	5.5	31		63.5	11,000	1.05	25,000
11 [Polym.11]	5.5	18	5	71.5	11,000	1.05	24,000
12 [Polym.12]	4	18		78	10,000	1.08	23,000
13 [Polym.13]	4	20	4	72	10,000	1.20	25,000
14 [Polym.14]	2	21	5	71	10,000	1.30	27,000

\*ポリヒドロキシスチレン

【0238】 [実施例、比較例] 上記合成例で得られた高分子化合物 (Polym. 1~14) をベース樹脂、

下記式 (PAG. 1~12) で示される酸発生剤、下記式 (D.R.R. 1~4) で示される溶解制御剤、塩基性化

111

合物、下記式 (ACC. 1、2) で示される分子内に  $\equiv$  C-COOH で示される基を有する芳香族化合物、下記式 (DYE. 1、2) で示される紫外線吸収剤から選ばれるレジスト材料用成分を溶剤に溶解し、表 2、3 に示す組成でレジスト液を調合した。必要に応じて、界面活性剤フロラード「FC-430 (住友スリーエム (株) 製)」0.1 部を加え、成膜性を改善した。

【0239】また、比較のため下記示性式 (Polymer. 1.5~1.8) で示される高分子化合物をベース樹脂として上記と同様にレジスト液を表 4 に示す組成で調合した。

【0240】これら各組成物を 0.1  $\mu\text{m}$  のテフロン製フィルターで濾過することによりレジスト液を調製した。これをシリコンウェハー上へスピンドルコートし、このシリコンウェハーを 100°C のホットプレートで 90 秒間ペークした。なお、膜厚は 0.55  $\mu\text{m}$  に設定した。

【0241】そして、目的のパターンを形成するためのマスクを介してエキシマレーザーステッパー (ニコン社、NSR-2005EX NA=0.5) を用いて露 10

光し、110°C で 90 秒間ペークを施し、2.38% のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液で 60 秒間の現像を行うと、ポジ型のパターンを得ることができた。

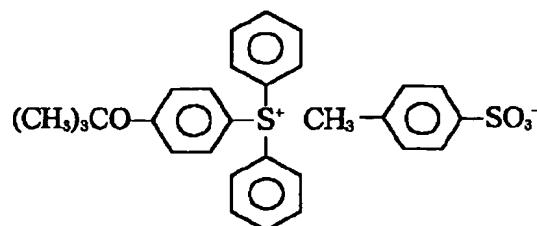
【0242】得られたレジストパターンを次のように評価した。まず、感度 (E<sub>th</sub>) を求めた。次に 0.24  $\mu\text{m}$  のラインアンドスペースのトップとボトムを 1:1 で解像する露光量を最適露光量 (感度: E<sub>op</sub>) として、この露光量における分離しているラインアンドスペースの最小線幅を評価レジストの解像度とした。同一露光量での露光から加熱処理までの時間経過 (PED) を 2 時間とした際の解像度も観察した。また、解像したレジストパターンの形状は、走査型電子顕微鏡を用いて観察し、耐熱性試験として、このレジストパターンを 130°C で 10 分間ホットプレート上にて加熱し、加熱前後のパターン形状の変化を観察した。

【0243】レジスト組成を表 2~4、実施例の評価結果を表 5 並びに比較例の評価結果を表 6 に示す。

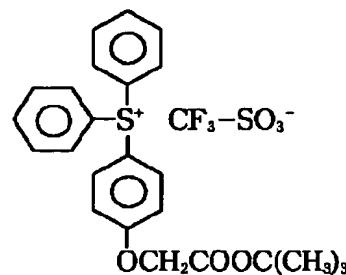
【0244】

【化 71】

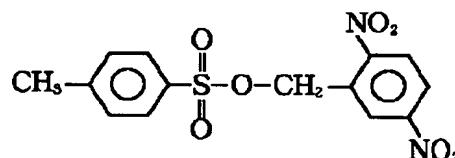
20



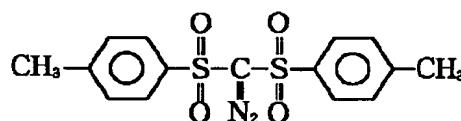
(PAG.1)



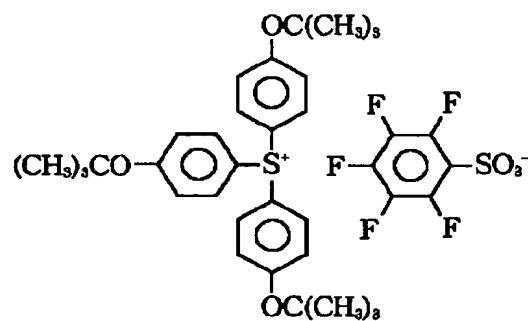
(PAG.2)



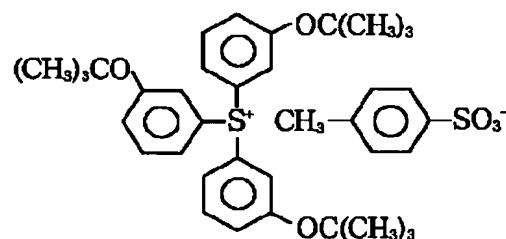
(PAG.3)



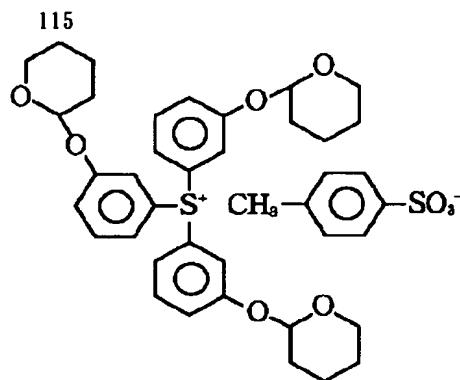
(PAG.4)



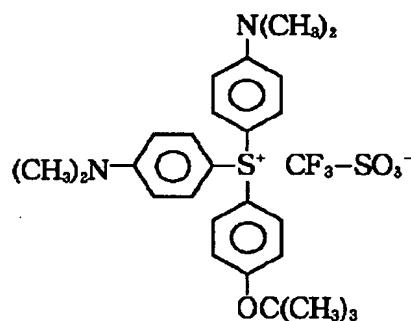
(PAG.5)



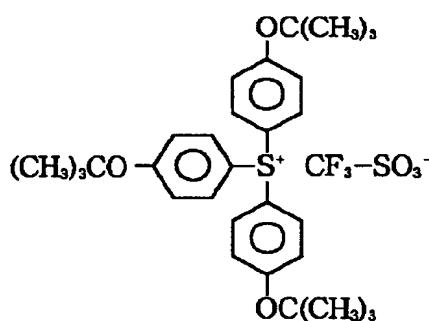
(PAG.6)



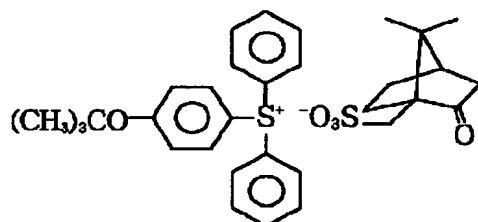
(PAG.7)



(PAG.8)

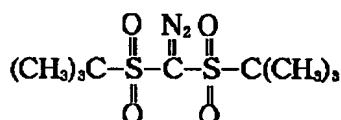


(PAG.9)



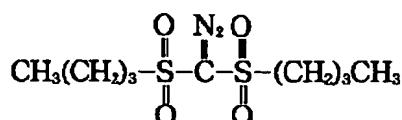
(PAG.10)

【0246】



【化73】

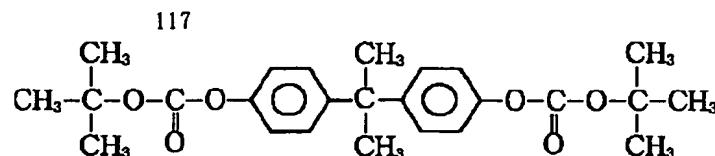
(PAG.11)



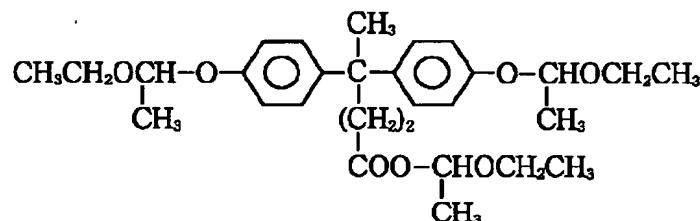
(PAG.12)

【0247】

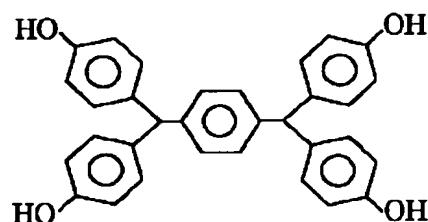
【化74】



(DRR.1)

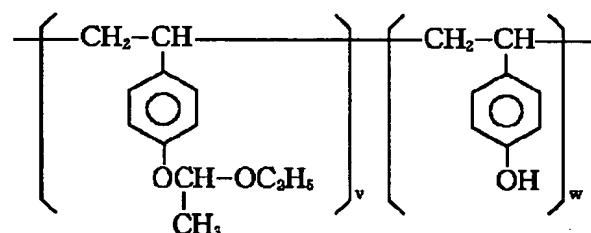


(DRR.2)



(DRR.3)

酸不安定基：  
tert-ブロキシカルボニル基  
平均置換率 50 %

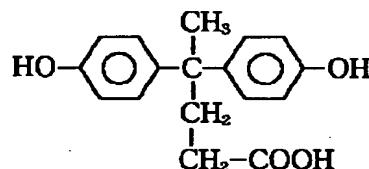


(DRR.4)

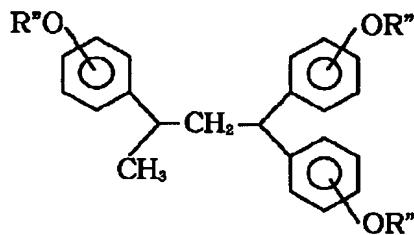
$v/(v+w)=0.09$   
重量平均分子量 3,000

【0248】

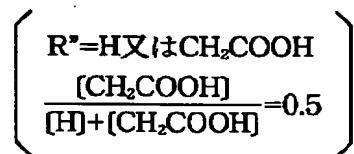
【化75】



ACC.1

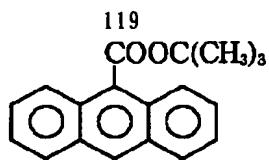


ACC.2

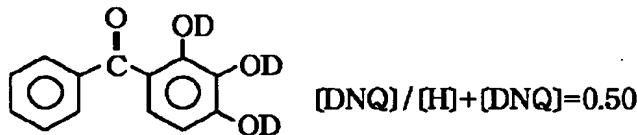


【0249】

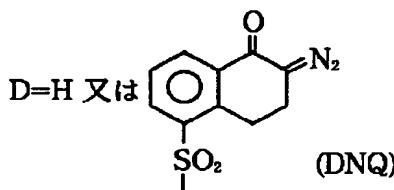
50 【化76】



DYE.1

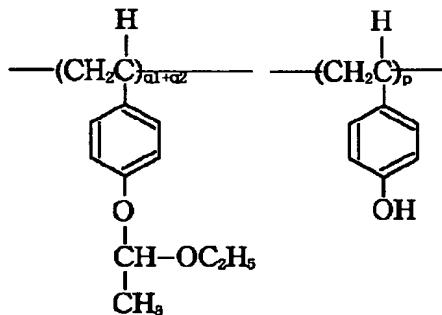


DYE.2

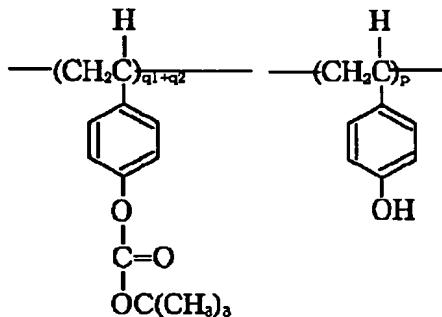


【0250】

【化77】

Polym.15

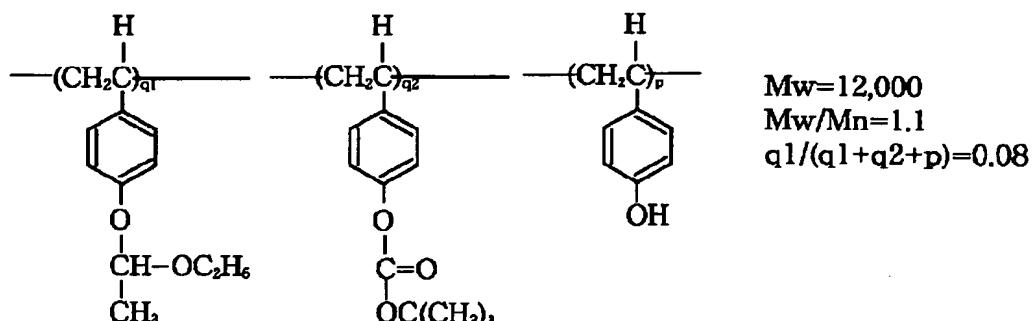
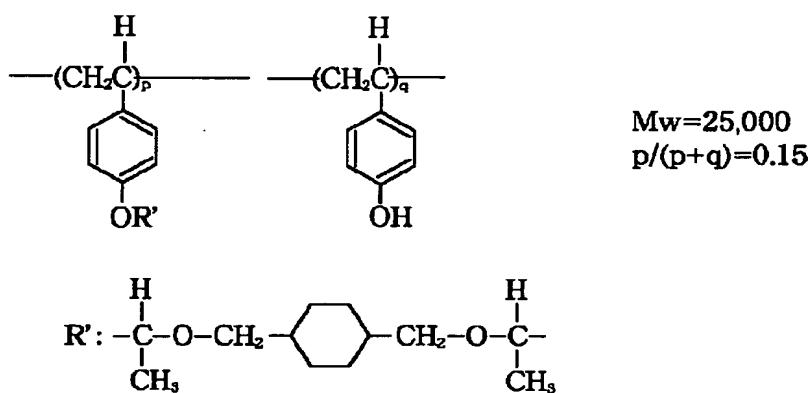
Mw=12,000  
Mw/Mn=2.0  
q1+q2/(q1+q2+p)=0.35

Polym.16

Mw=15,000  
Mw/Mn=1.5  
q1+q2/(q1+q2+p)=0.20

【0251】

【化78】

Polym.17Polym.18

【0252】

【表2】

実施例	レジスト材料組成物 (括弧内:組成比 (単位:重量部))					
	ベース樹脂	酸発生剤	溶解抑制剤	塩基性化合物	その他の添加剤	有機溶剤
1	Polym.1 (80)	PAG.1 (3)	—	N,N-ジエチルエタノールアミン (0.1)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)
2	Polym.2 (80)	PAG.2 (3)	—	N-エチルジエタノールアミン (0.1)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)
3	Polym.3 (80)	PAG.3 (3)	—	N-メチルピロリドン (0.1)	ACC.1 (0.2)	DGLM (300)
4	Polym.4 (80)	PAG.4 (3)	—	トリエタノールアミン (0.1)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)
5	Polym.5 (80)	PAG.5 (3)	—	2-ヒドロキシビリジン (0.11)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)
6	Polym.6 (80)	PAG.6 (3)	DRR.1 (16)	N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン (0.09)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)
7	Polym.7 (80)	PAG.1 (3.5) PAG.8 (0.5)	DRR.3 (16)	トリエタノールアミン (0.09)	ACC.1 (0.2)	EDPA (580)
8	Polym.8 (80)	PAG.1 (1) PAG.11 (2)	—	トリエタノールアミン (0.1) ビペリジンエタノール (0.05)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)
9	Polym.9 (80)	PAG.1 (1) PAG.12 (2)	—	トリエタノールアミン (0.1) 1,8-ジアザビシクロウニデン (0.05)	ACC.1 (0.5)	PGMEA (530)
10	Polym.10 (80)	PAG.9 (2) PAG.7 (1)	DRR.2 (8)	N-メチルピロリドン (0.1)	ACC.1 (0.2)	EL/BA (510)
11	Polym.11 (80)	PAG.9 (2) PAG.10 (1)	DRR.4 (8)	N,N-ジメチルアセトアミド (5.0)	ACC.1 (0.2)	EL/BA (510)
12	Polym.10 (50) Polym.12 (30)	PAG.1 (4)	—	トリプチルアミン (0.03) N,N-ジメチルアセトアミド (5.0)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)
13	Polym.10 (40) Polym.13 (40)	PAG.1 (4)	DRR.2 (4)	2-ヒドロキシビリジン (0.11)	ACC.2 (2)	PGMEA (530)

【0253】

【表3】

実 施 例	レジスト材料組成物 (括弧内:組成比 (単位:重量部))					
	ベース 樹 脂	酸発生剤	溶解抑制剤	塩基性化合物	その他の 添加剤	有機溶剤
14	Polym.9 (35) Polym.15 (45)	PAG.9 (4)	—	トリエタノールアミン (0.1)	ACC.1 (1)	PGMEA (530)
15	Polym.8 (80)	PAG.1 (1) PAG.11 (2)	—	トリエタノールアミン (0.05)	ACC.1 (0.2) DYE.1 (1.2)	PGMEA (530)
16	Polym.9 (80)	PAG.1 (1) PAG.11 (2)	—	ビペリジンエタノール (0.05)	ACC.1 (0.2) DYE.2 (4)	PGMEA (530)
17	Polym.10 (80)	PAG.1 (1) PAG.12 (2)	—	トリエタノールアミン (0.05)	ACC.1 (0.2) DYE.1 (1.2)	PGMEA (530)
18	Polym.11 (80)	PAG.1 (1) PAG.12 (2)	—	ビペリジンエタノール (0.05)	ACC.1 (0.2) DYE.2 (4)	PGMEA (530)
19	Polym.1 (80)	PAG.1 (2)	DRR.1 (4) DRR.3 (4)	N-メチルビロリドン (0.05)	ACC.1 (0.2)	PGMEA/ EP (530)
20	Polym.1 (80)	PAG.1 (2)	DRR.2 (4) DRR.4 (4)	N-メチルビロリドン (0.05)	ACC.1 (0.2)	PGMEA/ CH (530)
21	Polym.2 (80)	PAG.1 (2)	—	N-メチルビロリドン (0.05)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)
22	Polym.2 (80)	PAG.1 (2)	—	N-メチルビロリドン (0.05)	ACC.1 (0.2)	PGMEA (530)
23	Polym.12 (80)	PAG.1 (1.5)	—	トリエタノールアミン (0.08)	ACC.1 (0.2)	PGMEA/ EL (530)
24	Polym.13 (80)	PAG.1 (1.5)	—	トリエタノールアミン (0.08)	ACC.1 (0.2)	PGMEA/ EL (530)
25	Polym.14 (80)	PAG.2 (4)	—	N,N-ジメチルアセトア ミド (1.0)	ACC.1 (2)	PGMEA/ EL (530)
26	Polym.8 (40) Polym.17 (40)	PAG.1 (1) PAG.4 (2) PAG.11 (2)	—	トリエタノールアミン (0.3)	ACC.1 (1)	PGMEA/ EL (530)
27	Polym.8 (80)	PAG.4 (0.5) PAG.11 (2)	—	トリエタノールアミン (0.1)	ACC.1 (1)	PGMEA/ EL (530)

【0254】

【表4】

比 較 例	レジスト材料組成物 (括弧内:組成比 (単位:重量部))					
	ベース 樹 脂	酸発生剤	溶解抑制剤	塩基性化合物	その他の 添加剤	有機溶剤
1	Polym.15 (80)	PAG.1 (2)	—	N-メチルビロリドン (0.05)	—	PGMEA (530)
2	Polym.16 (80)	PAG.1 (2)	—	N-メチルビロリドン (0.05)	—	PGMEA (530)
3	Polym.17 (80)	PAG.1 (2)	—	N-メチルビロリドン (0.05)	—	PGMEA (530)
4	Polym.18 (80)	PAG.1 (2)	—	N-メチルビロリドン (0.05)	—	PGMEA (530)
5	Polym.9 (80)	PAG.1 (1) PAG.12 (2)	—	トリエタノールアミン (0.1) 1,8-ジアザビシクロウ ンデセン (0.05)	—	PGMEA (530)

D G L M : 2-メトキシエチルエーテル

E I P A : 1-エトキシ-2-プロパノール

E L / B A : 乳酸エチル (85重量%) と酢酸ブチル  
(15重量%) の混合溶液P G M E A : プロピレングリコールモノメチルエーテル  
アセテートP G M E A / E P : プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (90重量%) とビルビン酸エチル  
(10重量%) の混合溶液P G M E A / C H : プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (90重量%) とシクロヘキサン  
(10重量%) の混合溶液

P G M E A / E L : プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート (70重量%) と乳酸エチル (30重量%) の混合溶液

【0255】

【表5】

実 施 例	感度: EOP (mJ/cm <sup>2</sup> )	解像度 (μm)		即時/PED2時間 のプロファイル	耐熱性
		即時	PED2時間		
1	24.0	0.20	0.20	矩形	○
2	28.0	0.20	0.20	矩形	○
3	32.0	0.20	0.20	矩形	○
4	30.0	0.18	0.18	矩形	○
5	35.0	0.18	0.18	矩形	○
6	25.0	0.18	0.18	矩形	○
7	18.0	0.18	0.18	矩形	○
8	31.0	0.18	0.18	矩形	○
9	30.0	0.18	0.18	矩形	○
10	28.0	0.18	0.18	矩形	○
11	20.0	0.18	0.18	矩形	○
12	24.0	0.18	0.18	矩形	○
13	25.0	0.18	0.18	矩形	○
14	22.0	0.18	0.18	矩形	○
15	23.0	0.20	0.20	若干順テーパー	○
16	24.0	0.20	0.20	若干順テーパー	○
17	23.0	0.20	0.20	若干順テーパー	○
18	24.0	0.20	0.20	若干順テーパー	○
19	19.0	0.18	0.18	矩形	○
20	20.0	0.18	0.18	矩形	○
21	20.0	0.18	0.18	矩形	○
22	21.0	0.18	0.18	矩形	○
23	28.0	0.20	0.20	矩形	○
24	30.0	0.20	0.20	矩形	○
25	50.0	0.20	0.20	矩形	○
26	24.0	0.18	0.18	矩形	○
27	23.0	0.18	0.18	矩形	○

耐熱性 ○: 加熱前後のパターン形状の変化なし

【表6】

【0256】

比較例	感度: EOP (mJ/cm <sup>2</sup> )	解像度 (μm)		即時/PED2時間 のプロファイル	耐熱性
		即時	PED2時間		
1	20.0	0.22	0.20	矩形/ 逆テーパー	×
2	22.0	0.22	解像せず	矩形/ 解像せず	×
3	21.0	0.22	0.26	T-トップ	×
4	17.0	0.24	0.20	矩形/ 逆テーパー	○
5	30.0	0.18	0.24	矩形/ 逆テーパー	○

耐熱性 ○: 加熱前後のパターン形状の変化なし

10 【0258】

×: 加熱後、熱垂れのためパターン劣化

【化79】

【0257】次に、上記実施例21、22、23、24のレジスト組成物に、下記構造式のサーフィノール82を全体の0.05重量%となるように添加したレジスト組成物、比較例6、7、8、9のレジスト組成物につき、パーティクル（異物）の増加に関する保存安定性を観察した。結果を下記表7に示す。この際、液中パーティクルカウンターとしてKL-20A（リオン（株）製）を使用し、40°C保存による加速試験での0.3μmのパーティクルサイズについてモニターした。

【0259】

【表7】

20

		通過直後 (個/ml)	一ヶ月後 (個/ml)
実施例	21	5	26
	22	6	33
	23	6	13
	24	4	10
	6	5	7
比較例	7	5	6
	8	6	6
	9	4	5

## 【手続補正書】

【提出日】平成9年7月22日

## 【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項4

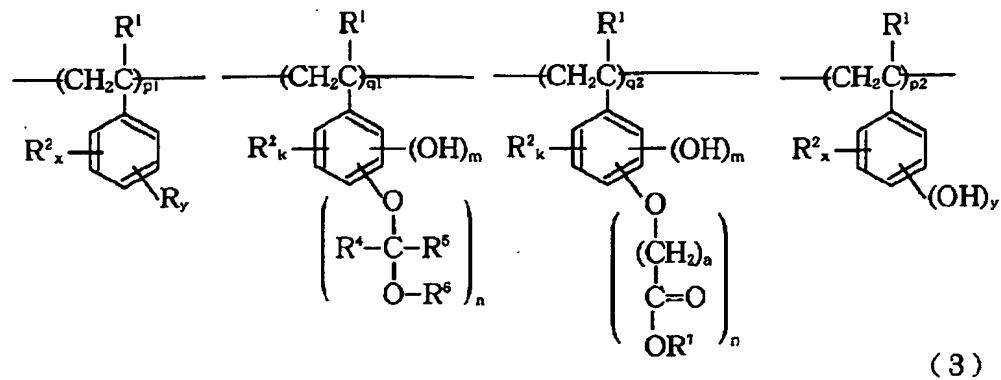
【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項4】 (B) 成分のベース樹脂として、下記一般式(3)で示される繰り返し単位を有する高分子化合物のRで示されるフェノール性水酸基の水素原子がとれてその酸素原子が下記一般式(4a)又は(4b)で示

されるC-O-C基を有する架橋基により分子内及び/又は分子間で架橋されており、上記酸不安定基と架橋基との合計量が式(1)のフェノール性水酸基の水素原子全体の平均0モル%を超え80モル%以下の割合である重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物を含有してなる請求項3記載の化学增幅ポジ型レジスト材料。

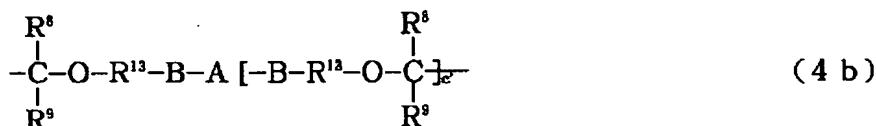
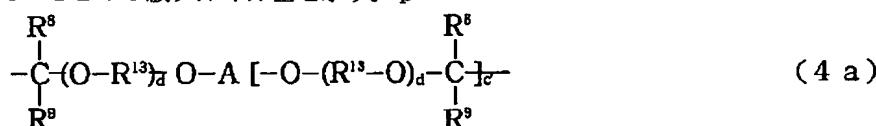
【化3】



(式中、Rは水酸基又はOR<sup>3</sup>基を示し、少なくとも1個は水酸基である。R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>2</sup>は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。R<sup>3</sup>は酸不安定基を示す。R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R<sup>6</sup>は炭素数1～18のヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基を示し、R<sup>4</sup>とR<sup>5</sup>、R<sup>4</sup>とR<sup>6</sup>、R<sup>5</sup>とR<sup>6</sup>とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>はそれぞれ炭素数1～18の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R<sup>7</sup>は炭素数4～12の3級アルキル基を示す。p

1、p2は正数、q1、q2は0又は正数であり、0 < p1 / (p1 + q1 + q2 + p2) ≤ 0.8、0 ≤ q1 / (p1 + q1 + q2 + p2) ≤ 0.8、0 ≤ q2 / (p1 + q1 + q2 + p2) ≤ 0.8、p1 + q1 + q2 + p2 = 1を満足する数であるが、q1とq2が同時に0となることはない。aは0又は1～6の正の整数である。x、y、k、m、nはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

【化4】



(式中、R<sup>8</sup>、R<sup>9</sup>は水素原子又は炭素数1～8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。又は、R<sup>8</sup>とR<sup>9</sup>とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR<sup>8</sup>、R<sup>9</sup>は炭素数1～8の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R<sup>13</sup>は炭素数1～10の直鎖状又は分岐状のアルキレン基、dは0又は1～10の整数である。Aは、c価の炭素数1～50の脂肪族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基を示し、これらの基はヘテロ原子を介在していてもよく、またその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、カルボニル基又はフッ素原子によって置

換されていてもよい。Bは-CO-O-、-NHCO-O-又は-NHCONH-を示す。cは2～8、c'は1～7の整数である。)

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

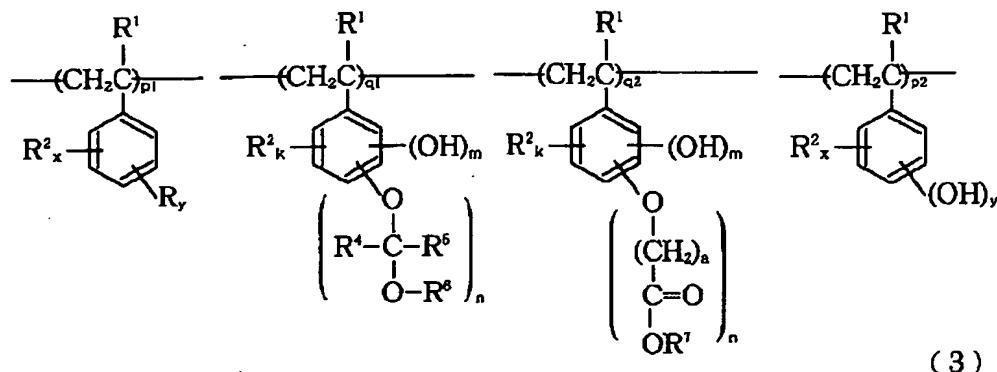
【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】

【化9】



( 3 )

(式中、Rは水酸基又はOR<sup>3</sup>基を示し、少なくとも1個は水酸基である。R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>2</sup>は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。R<sup>3</sup>は酸不安定基を示す。R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R<sup>6</sup>は炭素数1~18のヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基を示し、R<sup>4</sup>とR<sup>5</sup>、R<sup>4</sup>とR<sup>6</sup>、R<sup>5</sup>とR<sup>6</sup>とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>はそれぞれ炭素数1~18の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R<sup>7</sup>は炭素数4~12の3級アルキル基を示す。p<sub>1</sub>、p<sub>2</sub>は正数、q<sub>1</sub>、q<sub>2</sub>は0又は正数であり、0<p<sub>1</sub>/(p<sub>1</sub>+q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>+p<sub>2</sub>)≤0.8、0≤q<sub>1</sub>/(p<sub>1</sub>+q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>+p<sub>2</sub>)≤0.8、0≤q<sub>2</sub>/

(p<sub>1</sub>+q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>+p<sub>2</sub>)≤0.8、p<sub>1</sub>+q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>+p<sub>2</sub>=1を満足する数であるが、q<sub>1</sub>とq<sub>2</sub>が同時に0となることはない。aは0又は1~6の正の整数である。x、y、k、m、nはそれぞれ上記と同様の意味を示す。)

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

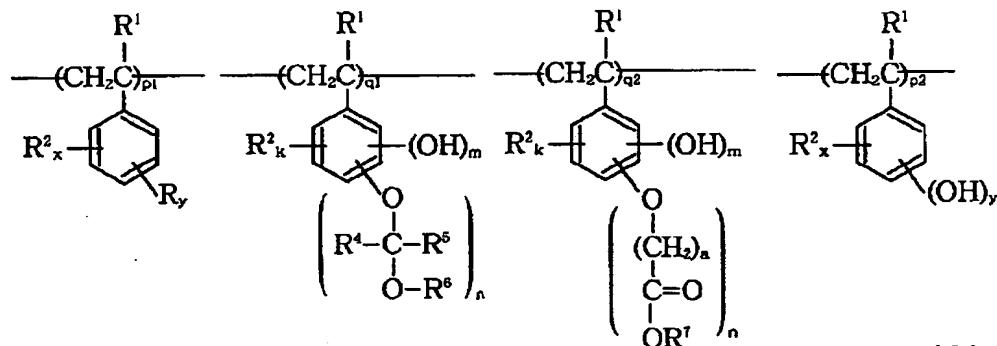
【補正対象項目名】0058

【補正方法】変更

【補正内容】

【0058】

【化20】



( 3 )

(式中、Rは水酸基又はOR<sup>3</sup>基を示し、少なくとも1個は水酸基である。R<sup>1</sup>は水素原子又はメチル基を示し、R<sup>2</sup>は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。R<sup>3</sup>は酸不安定基を示す。R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>は水素原子又は炭素数1~8の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示し、R<sup>6</sup>は炭素数1~18のヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基を示し、R<sup>4</sup>とR<sup>5</sup>、R<sup>4</sup>とR<sup>6</sup>、R<sup>5</sup>とR<sup>6</sup>とは環を形成してもよく、環を形成する場合にはR<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>はそれぞれ炭素数1~18の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。R<sup>7</sup>は炭素数4~12の3級アルキル基を示す。p<sub>1</sub>、p<sub>2</sub>は正数、q<sub>1</sub>、q<sub>2</sub>は0又は正数であり、0<p<sub>1</sub>/(p<sub>1</sub>+q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>+p<sub>2</sub>)≤0.8、0≤q<sub>1</sub>/(p<sub>1</sub>+q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>+p<sub>2</sub>)≤0.8、0≤q<sub>2</sub>/

(p<sub>1</sub>+q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>+p<sub>2</sub>)≤0.8、p<sub>1</sub>+q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>+p<sub>2</sub>=1を満足する数であるが、q<sub>1</sub>とq<sub>2</sub>が同時に0となることはない。aは0又は1~6の正の整数である。x、y、k、m、nはそれぞれ上記と同様の意味を示す。なお、p<sub>1</sub>+p<sub>2</sub>=p、q<sub>1</sub>+q<sub>2</sub>=qである。)

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

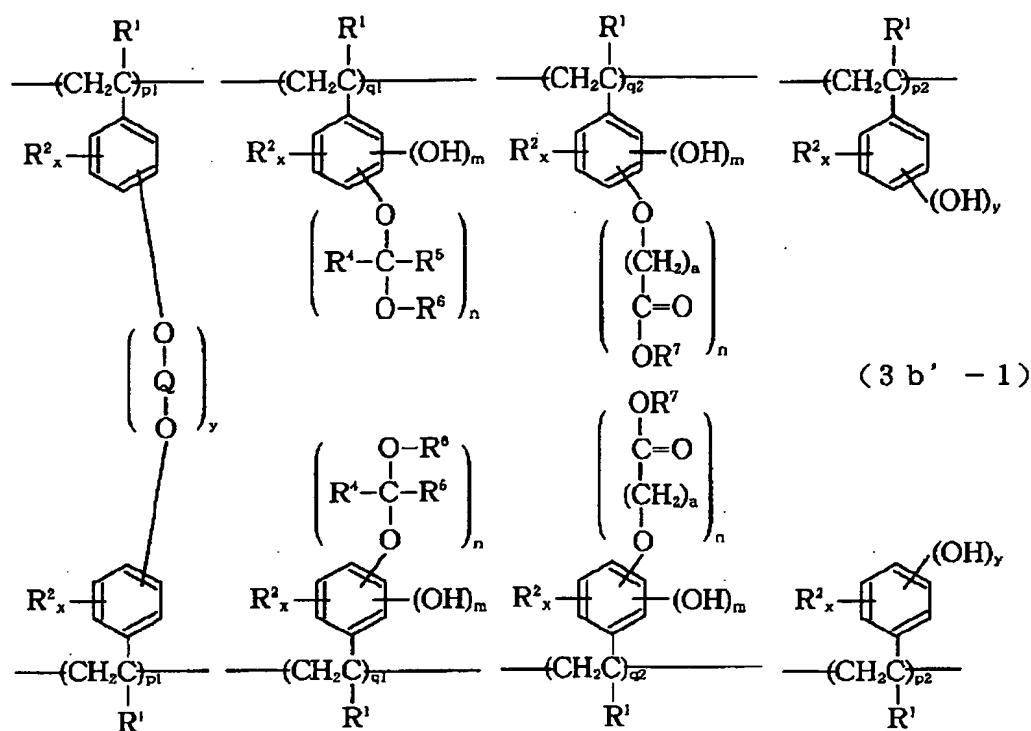
【補正対象項目名】0115

【補正方法】変更

【補正内容】

【0115】

【化41】



【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

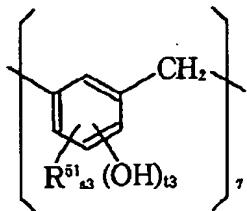
【補正対象項目名】0171

【補正方法】変更

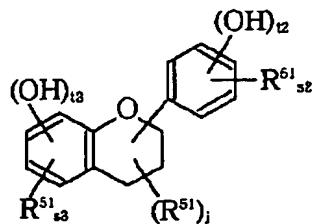
【補正内容】

【0171】

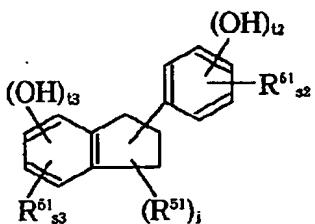
【化52】



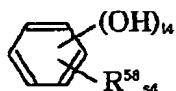
( 1 8 )



( 1 9 )



( 2 0 )



( 2 1 )

(但し、式中 R<sup>1</sup> は水素原子又はメチル基であり、R<sup>5<sub>1</sub></sup>、R<sup>5<sub>2</sub></sup> はそれぞれ水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分歧状のアルキル基又はアルケニル基であり、R<sup>5<sub>3</sub></sup> は水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分歧状のアルキル基又はアルケニル基、或いは -(R<sup>5<sub>7</sub></sup>)<sub>n</sub> -COOR' 基 (R' は水素原子又は -R<sup>5<sub>7</sub></sup> -COOH 基) であり、R<sup>5<sub>4</sub></sup> は -(CH<sub>2</sub>)<sub>i</sub> - (i = 2～10) 、炭素数 6～10 のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子、R<sup>5<sub>5</sub></sup> は炭素数 1～10 のアルキレン基、炭素数 6～10 のアリーレン基、カルボニル基、スルホニル基、酸素原子又は硫黄原子、R<sup>5<sub>6</sub></sup> は水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分歧状のアルキル基、アルケニル基、それぞれ水酸基で置換されたフェニル基又はナフチル基であり、R<sup>5<sub>7</sub></sup> は炭素数 1～10 の直鎖状又は分歧状のアルキレン基、R<sup>5<sub>8</sub></sup> は水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分歧状のアルキル基又はアルケニル基又は -R<sup>5<sub>7</sub></sup> -COOH 基である。j は 0～5 の整数であり、u、h は 0 又は 1 である。s<sub>1</sub>、t<sub>1</sub>、s<sub>2</sub>、t<sub>2</sub>、s<sub>3</sub>、t<sub>3</sub>、s<sub>4</sub>、t<sub>4</sub> はそれぞれ s<sub>1</sub> + t<sub>1</sub> = 8、s<sub>2</sub> + t<sub>2</sub> = 5、s<sub>3</sub> + t<sub>3</sub> = 4、s<sub>4</sub> + t<sub>4</sub> = 6 を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくとも 1 つの水酸基を有するような数である。β は式 (17) の化合物を重量平均分子量 1,000～5,000 とする数、γ は式 (18) の化合物を重量平均分子量 1,000～10,000 とする数である。)

換されたフェニル基又はナフチル基であり、R<sup>5<sub>7</sub></sup> は炭素数 1～10 の直鎖状又は分歧状のアルキレン基、R<sup>5<sub>8</sub></sup> は水素原子又は炭素数 1～8 の直鎖状又は分歧状のアルキル基又はアルケニル基又は -R<sup>5<sub>7</sub></sup> -COOH 基である。j は 0～5 の整数であり、u、h は 0 又は 1 である。s<sub>1</sub>、t<sub>1</sub>、s<sub>2</sub>、t<sub>2</sub>、s<sub>3</sub>、t<sub>3</sub>、s<sub>4</sub>、t<sub>4</sub> はそれぞれ s<sub>1</sub> + t<sub>1</sub> = 8、s<sub>2</sub> + t<sub>2</sub> = 5、s<sub>3</sub> + t<sub>3</sub> = 4、s<sub>4</sub> + t<sub>4</sub> = 6 を満足し、かつ各フェニル骨格中に少なくとも 1 つの水酸基を有するような数である。β は式 (17) の化合物を重量平均分子量 1,000～5,000 とする数、γ は式 (18) の化合物を重量平均分子量 1,000～10,000 とする数である。)

フロントページの続き

(51) Int. Cl.®

C 0 8 K 5/34  
5/42  
C 0 8 L 25/18  
H 0 1 L 21/027

識別記号

F I

C 0 8 K 5/34  
5/42  
C 0 8 L 25/18  
H 0 1 L 21/30

5 0 2 R

(72) 発明者 降▲旗▼ 智欣

群馬県碓氷郡松井田町大字人見 1 番地10  
信越化学工業株式会社シリコーン電子材料  
技術研究所内

(72) 発明者 竹田 好文

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1  
信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72) 発明者 名倉 茂広

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1  
信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72) 発明者 石原 俊信

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1  
信越化学工業株式会社合成技術研究所内

(72) 発明者 山岡 亜夫

千葉県船橋市本中山 3-22-7